日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 3月 4日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-057238

[ST. 10/C]:

[JP2003-057238]

出 願 人
Applicant(s):

三菱電機株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年10月21日





【書類名】

特許願

【整理番号】

541887JP02

【提出日】

平成15年 3月 4日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01S 5/028

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】

鴫原 君男

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】

川崎 和重

【特許出願人】

【識別番号】

000006013

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

【氏名又は名称】

三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】

100062144

【弁理士】

【氏名又は名称】

青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】

100086405

【弁理士】

【氏名又は名称】

河宮·治

【選任した代理人】

【識別番号】

100113170

【弁理士】

【氏名又は名称】 稲葉 和久



【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2002-283438

【出願日】

平成14年 9月27日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013262

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0010684

【プルーフの要否】

要

【発明の名称】 半導体光素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 活性層と、前記活性層を挟む2枚のクラッド層とからなる導 波層を含む積層構造体と、

前記積層構造体の一対の相対する端面部のうち少なくとも一方の端面部に形成 された多層反射膜と

を備え、

前記多層反射膜は、それぞれの膜の屈折率n;と膜厚d;との積n;d;の総 和 $\Sigma n_i d_i$ が、前記導波層を導波する光の波長 λ について、 $\Sigma n_i d_i > \lambda$ 4の関係を満足すると共に、

前記多層反射膜は、前記波長 λ の場合の反射率 R (λ) を基準として、+2. 0%以下となる前記波長λを含む連続する波長帯域幅Δλが、前記積層構造体の 実効屈折率 n c と前記波長λの場合の反射率 R' (λ) とについて、下記の関係 式、

 $(\lambda) = ((n_c - n_f^2) / (n_c + n_f^2))^2$

を満たす屈折率 n f の仮想単層反射膜を厚さ 5 λ / (4 n f) だけ前記端面部に 形成した場合の反射率 R'を基準として、+2.0%以下となる前記波長 λ を含 む連続した波長帯域幅Δ'λよりも広いことを特徴とする半導体光素子。

【請求項2】 活性層と、前記活性層を挟む2枚のクラッド層とからなる導 波層を含む積層構造体と、

前記積層構造体の一対の相対する端面部のうち少なくとも一方の端面部に形成 された多層反射膜と

を備え、

前記多層反射膜は、それぞれの膜の屈折率n;と膜厚d;との積n;d;の総 和 Σ n;d;が、前記導波層を導波する光の波長 λ について、 Σ n;d; λ / 4の関係を満足すると共に、

前記多層反射膜は、反射率が前記波長λの場合の反射率R(λ)を基準として -1%から+2.0%の範囲内となる前記波長λを含む連続する波長帯域幅Δλ



を、前記波長 λ で割った値 $\Delta\lambda$ / λ が0.062以上であることを特徴とする半**導体光素子。**

【請求項3】 活性層と、前記活性層を挟む2枚のクラッド層とからなる導 波層を含む積層構造体と、

前記積層構造体の一対の相対する端面部のうち少なくとも一方の端面部に形成 された多層反射膜と

を備え、

前記多層反射膜は、それぞれの膜の屈折率n;と膜厚d;との積n;d;の総 和 Σ n;d;が、前記導波層を導波する光の波長 λ について、 Σ n;d; λ / 4の関係を満足すると共に、

前記多層反射膜は、反射率が前記波長λの場合の反射率R(λ)を基準として -1.5%から+1.0%の範囲内となる前記波長λを含む連続する波長帯域幅 $\Delta \lambda$ を、前記波長 λ で割った値 $\Delta \lambda / \lambda$ が 0. 066以上であることを特徴とす る半導体光素子。

【請求項4】 前記多層反射膜は、前記導波層を含む前記積層構造体の実効 屈折率ncの平方根より大きい屈折率の第1反射膜と、前記実効屈折率ncの平 方根より小さい第2反射膜とを含むことを特徴とする請求項1に記載の半導体光 素子。

【請求項5】 前記多層反射膜は、前記第1反射膜と前記第2反射膜とが交 互に積層されていることを特徴とする請求項4に記載の半導体光素子。

【請求項6】 前記多層反射膜のうち、前記導波層に接する第1層膜は、前 記導波層を含む前記積層構造体の実効屈折率ncの平方根よりも小さい屈折率を 有することを特徴とする請求項1に記載の半導体光素子。

【請求項7】 前記多層反射膜は、3種類以上の膜で構成されることを特徴 とする請求項1に記載の半導体光素子。

【請求項8】 前記多層反射膜は、7層膜で構成されていることを特徴とす る請求項1に記載の半導体光素子。

【請求項9】 前記多層反射膜は、6層膜で構成されていることを特徴とす る請求項1に記載の半導体光素子。

【請求項11】 前記多層反射膜のうち、前記導波層に接する第1層膜は、前記多層反射膜の中で最も大きい熱伝導率を有することを特徴とする請求項1に記載の半導体光素子。

【請求項12】 前記多層反射膜のうち、前記導波層に接する第1層膜は、 窒化アルミニウムからなることを特徴とする請求項1に記載の半導体光素子。

【請求項13】 前記多層反射膜の反射率の極小値は、1~32%の範囲内にあることを特徴とする請求項1に記載の半導体光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光情報処理用の光源、光通信の信号、及びファイバアンプの励起光源などとして用いられる半導体レーザ素子、及び光信号を増幅する半導体増幅器及び光信号を変調する光変調器等の半導体光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】

[0003]

半導体光素子の端面部の導波層を含む積層構造体(実効屈折率 $n_c=3$. 37)に膜厚を変えて形成された単層反射膜(屈折率 $n_1=1$. 449)の反射率の波長依存性を考える。ここで、設定波長 $\lambda=9$ 80 n m で反射率が最小値をとるように設定する。反射率が最小値をとる場合とは、 λ / (4 n_1) の奇数倍の膜



厚の場合である。そこで、膜厚 λ / $(4 n_1)$ の単層反射膜の場合と、膜厚 5λ / $(4 n_1)$ の単層反射膜のそれぞれの場合について検討すると、膜厚 λ / $(4 n_1)$ の単層反射膜のほうが膜厚 5λ / $(4 n_1)$ の単層反射膜より反射率の極小値近傍における平坦部分が広い。

[0004]

具体的には以下の通りである。厚さ d $1=\lambda$ / (4 n 1) の場合は、波長 9 8 0 n mで極小反射率値 4 %となり、極小反射率値 + 2 % の波長帯域は 8 4 8 n m から 1 161 n mの 3 13 n mと広い。一方、厚さ d $1 = 5 \lambda$ / (4 n 1) の場合は、波長 9 8 0 n mで極小反射率値 4 %は同じであるが、極小反射率値 + 2 % の波長帯域は 9 5 1 n mから 1 0 1 1 n mの 6 0 n mと極端に狭くなる。このとき、波長帯域を所定の波長で割った値は 0.061 となる。また、極小反射率値 + 2.5 % の波長帯域は 9 4 9 n mから 1 0 1 3 n mの 6 4 n mであり、この波長帯域を所定波長 9 8 0 n mで割った値は 0.065 となる。

[0005]

【非特許文献1】

I. Ladany, et al., "Scandium oxide antireflection coatings for s uperluminescent LEDs", Appl. Opt. Vol. 25, No. 4, pp.472-473, (1986)

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

上記のように半導体光素子の端面部の反射膜の膜厚 d を λ / (4 n 1)の奇数 倍で厚膜化した場合には、反射率の極小値近傍における低反射率領域の波長帯域 が狭くなり、半導体レーザ特性が反射膜の反射率の波長依存性の影響を受けて大 きく変化するという問題があった。

[0007]

そこで、本発明の目的は、極小反射率近傍の波長帯域が広い反射膜を備えた半 導体光素子を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る半導体光素子は、活性層と、前記活性層を挟む2枚のクラッド層

とからなる導波層を含む積層構造体と、

前記積層構造体の一対の相対する端面部のうち少なくとも一方の端面部に形成された多層反射膜と

を備え、

前記多層反射膜は、それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i が、前記導波層を導波する光の波長 λ について、 Σ n_i d_i $> \lambda$ / 4の関係を満足すると共に、

前記多層反射膜は、前記波長 λ の場合の反射率R(λ)を基準として、+2. 0%以下となる前記波長 λ を含む連続する波長帯域幅 Δ λ が、前記積層構造体の実効屈折率 n_cと前記波長 λ の場合の反射率R'(λ)とについて、下記の関係式、

$$R'(\lambda) = ((n_c - n_f^2) / (n_c + n_f^2))^2$$

本発明に係る半導体光素子は、活性層と、前記活性層を挟む2枚のクラッド層とからなる導波層を含む積層構造体と、

前記積層構造体の一対の相対する端面部のうち少なくとも一方の端面部に形成された多層反射膜と

を備え、

前記多層反射膜は、それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i が、前記導波層を導波する光の波長 λ について、 Σ n_i d_i $> \lambda$ / 4の関係を満足すると共に、

前記多層反射膜は、反射率が前記波長 λ の場合の反射率R(λ)を基準として-1. 0%から+2. 0%の範囲内となる前記波長 λ を含む連続する波長帯域幅 $\Delta \lambda$ を、前記波長 λ で割った値 $\Delta \lambda$ λ が 0. 0 6 2 以上であることを特徴とする。

[0010]



本発明に係る半導体光素子は、活性層と、前記活性層を挟む2枚のクラッド層とからなる導波層を含む積層構造体と、

前記積層構造体の一対の相対する端面部のうち少なくとも一方の端面部に形成された多層反射膜と

を備え、



前記多層反射膜は、それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i が、前記導波層を導波する光の波長 λ について、 Σ n_i d_i $> \lambda$ / 4の関係を満足すると共に、

前記多層反射膜は、反射率が前記波長 λ の場合の反射率 $R(\lambda)$ を基準として-1.5%から+1.0%の範囲内となる前記波長 λ を含む連続する波長帯域幅 $\Delta\lambda$ を、前記波長 λ で割った値 $\Delta\lambda$ / λ が0.066以上であることを特徴とする。

[0011]

なお、 Σ n_i d_i について、好ましくは Σ n_i d_i > 5 λ / 4 の関係を満たすことである。これによりさらに厚い反射膜とすることができる。また、上記波長帯域幅 Δ λ を、前記波長 λ で割った値 Δ λ / λ は、好ましくは、0. 0 7 0 以上であり、さらに好ましくは0. 0 9 0 以上、またさらに好ましくは0. 1 0 以上である。低反射率の波長帯域幅 Δ λ が広いと、反射率の波長依存性が小さいので、導波光の波長が変化した場合にも特性変化を抑制できる。

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態に係る半導体光素子について、添付図面を用いて説明する。なお、図面において、実質的に同一の部材には同一の符号を付している。

[0013]

まず、本発明の実施の形態に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜の反射率の算出について、図1から図5を用いて説明する。図1は、複素数表示された振幅反射率 r を示す複素平面図である。図2は、半導体光素子の端面部の単層反射膜を示す概略断面図である。図3は、図2の単層反射膜に代えて2層反射膜を設けた場合の概略断面図である。図4は、図2の単層反射膜に代えて4

【数1】

$$r = r_{r} (\lambda) + i r_{i} (\lambda)$$
 (1)

ここで、i は虚数単位(i=(-1) 1/2)であり、 r_r (λ) は、実数部であり、 r_i (λ) は、虚数部である。通常用いられる反射率は、上記の振幅反射率の2乗であって、この反射率がゼロとなる場合とは、下記式(2a)、(2b)のように振幅反射率の実数部及び虚数部とが共にゼロとなる場合である。これらの関係式を解くことによって反射率がゼロとなる条件を得ることができる。

【数2】

$$\mathbf{r}_{\mathbf{r}}(\lambda) = 0 \qquad (2 a)$$

$$r_i (\lambda) = 0 \qquad (2b)$$

 $[0\ 0\ 1\ 4]$

一方、ゼロでない反射率を求めようとする場合には、図1の複素平面上で円周上の各点の振幅反射率が該当することとなるため、上記のような条件式が一義的には定まらない。そこで、導波する光の波長 λ について所望の反射率が得られる仮想的な単層反射膜を考える。図2は、半導体光素子の導波層10の端面に単層反射膜1を設けた仮想単層反射膜の概略断面図である。反射膜1は大気等の自由空間5に面している。単層反射膜1の振幅反射率 r を最小にする条件は、半導体光素子の導波層10を導波する光の波長 λ 、単層反射膜1の屈折率 r 及び膜厚 r を用いて、下記式(3)で表される。

【数3】

$$d_f = \frac{\lambda}{4n_f} (2m+1) \tag{3}$$

ここで、m=0、1、2、3等の負でない整数である。

[0015]

この仮想単層膜の振幅反射率 r の最小値は、下記式(4)で表される。

【数4】

$$r = \frac{n_c - n_f^2}{n_c + n_f^2} \tag{4}$$

[0016]

なお、反射率 R は、振幅反射率 r について、 $| r | ^2$ で表される。つまり、R = $((n_c - n_f ^2) / (n_c + n_f ^2))^2$ で表される。従って、反射率 R = 4% を得ようとすると、半導体光素子の導波層の実効屈折率 $n_c = 3$. 37の場合には、上記式を解いて、単層反射膜 1 の屈折率 n_f として、2. 2 48又は 1 . 499が得られる。しかし、通常、このような屈折率を有する単層膜は得られないことが多い。そこで、上記仮想単層反射膜を多層反射膜で置換することについて検討する。

[0017]

上記の単層反射膜に代えて、2層反射膜を設けた場合の反射率について検討する。図3は、仮想単層反射膜に代えて、端面部に2層反射膜を用いた場合の概略断面図である。この2層反射膜の反射率の極小値を所定値に設定する条件について、本発明者らによる検討結果を説明する。2層反射膜を構成する第1層膜1及び第2層膜2の位相変化をそれぞれ φ1、φ2とすると、下記式(5)及び(6)のように定義される。

【数5】

$$\phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} n_1 d_1 \tag{5}$$

【数6】

$$\phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} n_2 d_2 \tag{6}$$

[0018]

この場合に、複素数表示による振幅反射率 r は次式 (7) で表される。

【数7】

$$r = \frac{\text{Re}\,1 + i\,\text{Im}\,1}{\text{Re}\,2 + i\,\text{Im}\,2} \tag{7}$$

ここで、i は虚数単位であり、Re1 及びRe2 はそれぞれ分子・分母の実数部であり、Im1、Im2 はそれぞれ分子・分母の虚数部である。

[0019]

上記式 (7) の分子・分母における実部部 R e 1、 R e 2 と虚部部 I m 1、 I m 2 は、それぞれ次式 (8 a) から式 (8 d) のように表される。

【数8】



Re 1 =
$$(n_c - 1)\cos\phi_1\cos\phi_2 + \left(\frac{n_1}{n_2} - \frac{n_2 n_c}{n_1}\right)\sin\phi_1\sin\phi_2$$
 (8 a)

【数9】

$$\operatorname{Im} 1 = -\left\{ \left(\frac{n_c}{n_2} - n_2 \right) \cos \phi_1 \sin \phi_2 + \left(\frac{n_c}{n_1} - n_1 \right) \sin \phi_1 \cos \phi_2 \right\}$$
 (8 b)

【数10】

Re 2 =
$$(n_c + 1)\cos\phi_1\cos\phi_2 - \left(\frac{n_2 n_c}{n_1} + \frac{n_1}{n_2}\right)\sin\phi_1\sin\phi_2$$
 (8 c)

【数11】

Im 2 =
$$-\left\{ \left(\frac{n_c}{n_2} + n_2 \right) \cos \phi_1 \sin \phi_2 + \left(\frac{n_c}{n_1} + n_1 \right) \sin \phi_1 \cos \phi_2 \right\}$$
 (8 d)

[0020]

また、電力反射率 R は、上記振幅反射率 r を用いて $|r|^2$ で表される。この式 (7) で表される振幅反射率が、式 (4) で表される上記仮想単層反射膜の振幅反射率と等しくなるように厚さ d 1 及び d 2 を決めればよい。

[0021]

図4は、単層反射膜に代えて、端面部に4層反射膜を設ける場合の概略断面図である。この4層反射膜の反射率が設定波長で前記仮想単層膜の反射率と同一になる条件について検討する。4層反射膜の場合には、振幅反射率は下記式(9)で表される。

【数12】

$$r = \frac{\left(m_{11} + m_{12}\right)n_c - \left(m_{21} + m_{22}\right)}{\left(m_{21} + m_{22}\right)n_c + \left(m_{21} + m_{22}\right)} \tag{9}$$

[0022]

ここで、 m_{ij} (i, jは1又は2)は下記式(10)で表される。

【数13】

$$\begin{pmatrix}
m_{11} & m_{12} \\
m_{21} & m_{22}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\cos A\phi_1 & -\frac{i}{n_1}\sin A\phi_1 \\
-in_1\sin A\phi_1 & \cos A\phi_1
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos A\phi_2 & -\frac{i}{n_2}\sin A\phi_2 \\
-in_2\sin A\phi_2 & \cos A\phi_2
\end{pmatrix} \\
\times \begin{pmatrix}
\cos B\phi_1 & -\frac{i}{n_1}\sin B\phi_1 \\
-in_1\sin B\phi_1 & \cos B\phi_1
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos B\phi_2 & -\frac{i}{n_2}\sin B\phi_2 \\
-in_2\sin B\phi_2 & \cos B\phi_2
\end{pmatrix} (10)$$

なお、A, Bは、第1層膜1の膜厚Ad1、第2層膜2の膜厚Ad2、第3層膜3の膜厚Bd1、第4層膜4の膜厚Bd2とした場合の、それぞれの2層膜(ペア)の寄与率を表すパラメータである。

[0023]

図5は、単層反射膜に代えて、導波層10の端面部に7層反射膜20を設けた場合の概略断面図である。この7層反射膜20の反射率が前記仮想単層膜の反射率と同一になるように設定する条件について検討する。7層反射膜20の場合には、振幅反射率は、4層反射膜と同様に下記式(11)で表される。

【数14】

$$r = \frac{(m_{11} + m_{12})n_c - (m_{21} + m_{22})}{(m_{11} + m_{12})n_c + (m_{21} + m_{22})}$$
(11)

[0024]

ここで、 m_{ij} (i, jは1又は2)は下記式(12)で表される。

【数15】

$$\begin{pmatrix}
m_{11} & m_{12} \\
m_{21} & m_{22}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\cos O\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin O\phi_{2} \\
-in_{2} \sin O\phi_{2} & \cos O\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos A\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}} \sin A\phi_{1} \\
-in_{1} \sin A\phi_{1} & \cos A\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos A\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin A\phi_{2} \\
-in_{2} \sin A\phi_{2} & \cos A\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos B\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}} \sin B\phi_{1} \\
-in_{1} \sin B\phi_{1} & \cos B\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos B\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin B\phi_{2} \\
-in_{2} \sin B\phi_{2} & \cos B\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos C\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}} \sin C\phi_{1} \\
-in_{1} \sin C\phi_{1} & \cos C\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos C\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin C\phi_{2} \\
-in_{2} \sin C\phi_{2} & \cos C\phi_{2}
\end{pmatrix} (12)$$

なお、O, A, B, Cは、第1層膜11の膜厚Od2、第2層膜12の膜厚Ad1、第3層膜13の膜厚Ad2、第4層膜14の膜厚Bd1、第5層膜15の膜厚Bd2、第6層膜16の膜厚Cd1、第7層膜17の膜厚Cd2とした場合の、それぞれの2層膜(ペア)の寄与率を表すパラメータである。

[0025]

実施の形態1.

本発明の実施の形態1に係る半導体光素子について、図5及び図6を用いて説明する。図5は、単層反射膜に代えて7層反射膜を設けた場合の概略断面図である。この半導体光素子は、例えば、半導体レーザ素子、光変調器、光スイッチ等である。この半導体光素子は、光が導波する導波層の端面部に所定波長を中心とした広い波長帯域にわたって低反射率を有する多層反射膜を設けている。このように低反射率の多層反射膜を設けることにより、例えば、半導体レーザ素子の場合にはいわゆる戻り光によるノイズ等の発生を低減することができる。また、光変調器及び光スイッチの場合には、信号を低損失で透過させることができる。また、この多層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率を有するので、発振波長が変化した場合や、信号の中心波長が変化した場合にも反射特性の波長依存性を抑制できる。

[0026]

以下、半導体光素子の端面部に設けた7層反射膜20について図5を用いて説

明する。図5は、半導体光素子の端面部に設けた7層反射膜20の構成を示す概略断面図である。この半導体光素子では、導波層10(等価屈折率nc=3.37)の端面部に、アルミナの第1層膜11(屈折率n2=1.62、膜厚Od2)、酸化タンタルの第2層膜12(屈折率n1=2.057、膜厚Ad1)、アルミナの第3層膜13(屈折率n2=1.62、膜厚Ad2)、酸化タンタルの第4層膜14(屈折率n1=2.057、膜厚Bd1)、アルミナの第5層膜15(屈折率n2=1.62、膜厚Bd2)、酸化タンタルの第6層膜16(屈折率n1=2.057、膜厚Cd1)、アルミナの第7層膜17(屈折率n2=1.62、膜厚Cd2)が順に積層されている。また、第7層膜17は大気等の自由空間5と接している。

[0027]

この半導体光素子の端面部に設けられた 7層反射膜 2 0 の反射特性について説明する。まず、設定波長 $\lambda=9$ 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 2%とする。各パラメータを、O=0.2、A=2.2、B=2.0、C=2.0とした場合、酸化タンタル及びアルミナの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 が、それぞれ ϕ 1 = 0.45 8 4 4、 ϕ 2 = 1.1 4 9 3 2 である場合に波長 9 8 0 n mで反射率 2%が得られる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は、Od 2/Ad 1/Ad 2/Bd 1/Bd 2/Cd 1/Cd 2=22.13 n m/76.47 n m/243.44 n m/69.52 n m/221.31 n mである。全体の膜厚(dtotal= Σ di)は 9 2 3.7 n mである。また、それぞれの膜の屈折率 niと膜厚 diとの積 nidiの総和 Σ nidiは、1590.57 n mであり、所定波長 9 8 0 n mの 1/4 波長(= 2 4 5 n m)の約6.49倍と非常に厚い。即ち、導波する光の所定波長 9 8 0 n mについて、その 5/4 波長よりも厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0028]

図6は、この7層反射膜20の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。ここで設定反射率のおよそ+1%が目標反射率である。この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって目標反射率の

3%前後の平坦部分が得られている。即ち、波長968 n mから1210 n mにわたって反射率は極小値の1.3%から4.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980 n mの反射率2.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は242 n mである。この波長帯域幅を設定波長 λ (= 980 n m) で割った値は約0.246である。

[0029]

ここで、比較のために導波光の所定波長 980 n mについて 5/4 波長の厚さの仮想単層反射膜を仮定する。設定条件は、波長 980 n mで極小反射率 4% をとるように、nc=3. 37、n1=1. 449 である。この場合、極小反射率を基準として +2%、すなわち反射率 $4\% \sim 6\%$ の波長範囲は 951 n m ~ 10 11 n m であり、その波長帯域幅は 60 n m である。この波長帯域幅の広さの目安として、導波光の所定波長 980 n m で割ると 0.061 が得られる。

[0030]

そこで、この実施の形態1に係る7層反射膜について、上記仮想単層反射膜と比較すると、導波光の波長での反射率+2%のとなる波長帯域幅をその波長で割った商は、0.246であり、仮想単層反射膜の0.061よりはるかに大きい。したがって、この7層反射膜は上述のように導波光の所定波長980nmについて5/4波長より厚い膜厚であるにもかかわらず、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0031]

実施の形態2.

本発明の実施の形態 2 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 7 を用いて説明する。図 7 は、この 7 層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。この半導体光素子は、実施の形態 1 に係る半導体光素子と比較すると、多層膜の構成において共通するが、設定波長 λ が 8 7 9 n mで設定反射率 R (λ) を 2. 0%としている点で相違する。各パラメータを、O=0. 2、A=2. 2、B=2. 0、C=2. 0とした場合、酸化タンタル及びアルミナの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 が、それぞれ ϕ 1 = 0. 4 5 8 4 4、 ϕ 2 = 1. 1 4 9 3 2 である

場合に波長879nmで反射率2%が得られる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は〇d2/Аd1/Аd2/Вd1/Вd2/Сd1/Сd2=19. 85 nm/68. 59 nm/218. 35 nm/62. 36 nm/198. 50 nm/62. 36 nm/198. 50 nm/62. 36 nm/198. 50 nmである。全体の膜厚(dtotal= Σ di)は828. 51 nmである。また、それぞれの膜の屈折率 niと膜厚diとの積 nidiの総和 Σ nidiは、1426. 66 nmであり、所定波長980 nmについて1/4 波長(= 245 nm)の約5. 82 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0032]

図7は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長861nmから1098nmにわたって反射率は極小値の1.3%から4.0%の範囲内に収まっている。この場合、導波光の所定波長980nmを略中心として平坦部分が得られる。また、設定波長879nmの反射率2.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅Δλは237nmである。この波長帯域幅を設定波長879nmで割った値は約0.270であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、上述のように導波光の所定波長980nmについて5/4波長より厚い膜厚であるにもかかわらず、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。なお、ここで「所定波長」とは、導波層を導波する光の波長であって、この場合には980nmの光としている。一方、「設定波長」とは、上記所定波長を低反射率の平坦部の略中心となるように設定する波長である。

[0033]

次に、極小反射率を基準として+2.0%となる波長帯域の広さについて、この7層反射膜と仮想単層反射膜とを比較検討する。この7層反射膜の極小反射率は1.3%である。そこで、極小反射率を基準として+2.0%となる波長範囲、つまり反射率3.3%以下の範囲は波長866nmから1089nmである。

即ち、波長帯域幅としては223 n m である。一方、仮想単層反射膜によって同一の極小反射率を実現しようとする場合、実効屈折率 $n_c=3$. 37 であるので、単層膜の屈折率 n_f は 1. 637 又は 2. 058 とすればよい。例えば、図8に屈折率 $n_f=1$. 637 であって、膜厚 d=5 λ / $(4n_f)$ の仮想単層反射膜の波長依存性を示す。この仮想単層反射膜の極小反射率 1. 3% を基準として極小反射率 +2. 0% 以内となる範囲は、波長 952 n m から 1009 n m である。即ち、波長帯域幅としては 57 n m である。したがって、7 層反射膜は、膜厚 d=5 λ / $(4n_f)$ の仮想単層反射膜に比べて低反射率の波長帯域が非常に広い。

[0034]

実施の形態3.

本発明の実施の形態 3 に係る 7層反射膜を備えた半導体光素子について、図9を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=9$ 80 n mで設定反射率 R(λ)を 3.0%としている点で相違する。また、パラメータは O=0.2、A=2.4、B=2.0,C=2.0としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=0.518834、 ϕ 2=0.789695とすることによって波長 980 n mで反射率 3.0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は Od2/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=15.21nm/94.42nm/182.47nm/78.68nm/152.06nm/78.68n

[0035]

図9は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの 横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の3% 前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長841nm



から1014nmにわたって反射率は2.5%から5.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率3.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、 $2.0\%\sim5.0\%$ の範囲の連続した波長帯域幅は173nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.17であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる

[0036]

実施の形態4.

本発明の実施の形態 4 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図10を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 3 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1$ 0 3 5 n mで設定反射率 R(λ)を 3.0%としている点で相違する。また、パラメータは O=0.2、A=2.4、B=2.0,C=2.0としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1=0.5 1 8 8 3 4、 ϕ 2=0.7 8 9 6 9 5 とすることによって波長 1 0 3 5 n mで反射率 3.0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は O d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2=16.06 n m / 9 9.72 n m / 1 9 2.72 n m / 8 3.10 n m / 160.60 n m / 8 3.10 n m / 160.60 n m / 8 3.10 n m / 160.50 n m / 8 3.10 n m / 160.60 n m / 8 3 1 0 n m / 160 n m / 8 3 1 0 n m / 160 n m / 8 3 1 0 n m / 160 n m / 8 3 1 0 n m / 160 n m / 8 3 1 0 n m / 160 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3 1 0 n m / 8 3

[0037]

図10は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長888nmから1071nmにわたって反射率は2.5%から5.0%の範囲内に収まっ

ている。また、設定波長1035nmの設定反射率3.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は183nmである。この波長帯域幅を設定波長1035nmで割った値は約0.177であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0038]

実施の形態 5.

[0039]

図11は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長834nmから10121nmにわたって反射率は3.5%から6.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率4.0%を基準として、-1



. 0%から+2. 0%の範囲、即ち、3. $0\%\sim6$. 0%の範囲の連続した波長帯域幅は178 n mである。この波長帯域幅を設定波長 980 n mで割った値は約0. 182であり、仮想単層反射膜の場合の0. 061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0040]

実施の形態 6.

本発明の実施の形態 6 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図12を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1040$ n mで設定反射率 R (λ) を 4.0% としている点で相違する。また、パラメータはO=0.15、A=2.5、B=2.0,C=2.0 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.5 2 0 8 2、 ϕ 2 = 0.76 7 3 3 7 とすることによって波長 1 0 4 0 n mで反射率 4.0% とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚はOd2/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=11.76 n m/104.77 n m/196.00 n m/83.82 n m/156.80 n m/83.82 n m/156.80 n m/83.82 n m/156.80 n mである。全体の膜厚(dtotal=Σdi)は793.77 n mである。それぞれの膜の屈折率 n i と 膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、1404.95 n mであり、所定波長 980 n mの1/4 波長(=245 n m)の約5.73 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0041]

図12は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長885nmから1074nmにわたって反射率は3.5%から6.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1040nmの設定反射率4.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長



帯域幅は189nmである。この波長帯域幅を設定波長1040nmで割った値は約0.182であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0042]

実施の形態7.

本発明の実施の形態 7 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 1 3 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 9 8 0 n mで目標反射率 5 . 0%としている点で相違する。また、パラメータは O=0 . 1 5、A=2 . 5、B=2 . 0,C=2 . 0としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0 . 5 4 1 0 2 2、 ϕ 2 = 0 . 7 4 1 3 9 7 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 5 . 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は O d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 1 0 . 7 1 n m / 1 0 2 . 5 6 n m / 1 7 8 . 4 5 n m / 8 2 . 0 5 n m / 1 4 2 . 7 6 n m / 8 3 8 / 8 / 8 / 9 8 0 n m / 9 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 4 / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 1 8 / 9 8 0 n m / 1 9 / 9 8 0 n m / 1 9 / 9 8 0 n m / 1 9 / 9 8 0 n m / 1 9 / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m / 9 8 0 n m /

[0043]

図13は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長843nmから1013nmにわたって反射率は4.6%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率5.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、4.0%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は170nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.173であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、こ



の7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることが わかる。

[0044]

実施の形態8.

[0045]

図14は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長890 nmから1070 nmにわたって反射率は4.6%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1035 nmの設定反射率5.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、4.0%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は170 nmである。この波長帯域幅を設定波長1035 nmで割った値は約0.164であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。



[0046]

実施の形態9.

本発明の実施の形態9に係る7層反射膜を備えた半導体光素子について、図1 5及び図16を用いて説明する。図15は、この半導体光素子の端面部の反射膜 として、第1層膜に酸化タンタル膜を用いた7層反射膜30を設けた場合の構成 を示す概略断面図である。この半導体光素子は、実施の形態1に係る半導体光素 子と比較すると、7層反射膜30が導波層10側から酸化タンタル21/アルミ ナ22/酸化タンタル23/アルミナ24/酸化タンタル25/アルミナ26/ 酸化タンタル27の順に積層されており、導波層10側の第1層膜21が酸化タ ンタルである点で相違する。具体的には、7層反射膜30は、導波層10側から 順に、酸化タンタルの第1層膜21(屈折率n2=2.037、膜厚Od2)、 アルミナの第2層膜22(屈折率n1=1.62、膜厚Ad1)、酸化タンタル の第3層膜23 (屈折率 n 2 = 2. 037、膜厚Ad2)、アルミナの第4層膜 24 (屈折率 n 1 = 1. 62、膜厚 B d 1)、酸化タンタルの第5層膜25 (屈 折率n2=2.037、膜厚Bd2)、アルミナの第6層膜26(屈折率n1= 1.62、膜厚Cd1)、酸化タンタルの第7層膜27(屈折率n₂=2.03 7、膜厚Cd2)とが積層されている。なお、アルミナと酸化タンタルとが交互 に積層されている点で実施の形態1に係る半導体光素子と共通する。

$[0\ 0\ 4\ 7]$

この半導体光素子の端面部の 7層反射膜 3 0 において、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 2. 0%とする。この場合、各パラメータを O = 1. 1 5、A = 1. 8 2、B = 1. 9 7、C = 2. 0 6 とすると、アルミナ及び酸化タンタルの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 がそれぞれ ϕ 1 = 0. 6 4 5 8 2 1、 ϕ 2 = 1. 4 5 2 0 4 1 の場合に波長 9 8 0 n mで反射率を 2%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は、O d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 1 2 6. 6 2 n m / 1 1 3. 1 7 n m / 2 0 0. 3 8 n m / 1 2 2. 4 9 n m / 2 1 6. 9 0 n m / 1 2 8. 0 9 n m / 2 2 6. 8 1 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d $_i$)は 1 1 3 4. 4 6 n m である。それぞれの膜の屈折率 n $_i$ と膜厚 d $_i$ との積 n $_i$ d $_i$ の総和 Σ n $_i$ d $_i$ は、2 1



74.63 n m であり、所定波長 980 n m の 1/4 波長(=245 n m)の約8.88 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0048]

図16は、この7層反射膜30の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長996nmから1119nmにわたって反射率は1.5%から4.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率2.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は157nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.160であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0049]

実施の形態10.



22倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0050]

図17は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長924nmから1037nmにわたって反射率は1.5%から4.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長908nmの設定反射率2.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は145nmである。この波長帯域幅を設定波長908nmで割った値は約0.160であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0051]

実施の形態11.

ける放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0052]

図18は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長962nmから1053nmにわたって反射率は2.6%から5.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率3.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は91nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.093であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0053]

実施の形態12.



[0054]

図19は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長962nmから1053nmにわたって反射率は2.6%から5.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長953nmの設定反射率3.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は89nmである。この波長帯域幅を設定波長953nmで割った値は約0.093であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0055]

実施の形態13.

[0056]

図20は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、反射率は3.7%から6.0%の範囲内に収まっている。また、波長980nmの設定反射率4.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は190nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.093であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0057]

実施の形態14.

[0058]

図21は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約

5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長891 nmから1069nmにわたって反射率は3.7%から6.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長912nmの設定反射率4.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は178nmである。この波長帯域幅を設定波長912nmで割った値は約0.195であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0059]

実施の形態15.

[0060]

図22は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、反射率は4

. 7%から7. 0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定 反射率5. 0%を基準として、-1. 0%から+2. 0%の範囲、即ち、4. 0%~7. 0%の範囲の連続した波長帯域幅は190nmである。この波長帯域幅 を設定波長980nmで割った値は約0. 194であり、仮想単層反射膜の場合の0. 061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって 低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0061]

実施の形態16.

[0062]

図23は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長891 nmから1068nmにわたって反射率は4.7%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長910nmの設定反射率5.0%を基準として、-1



. 0%から+2. 0%の範囲、即ち、4. 0%~7. 0%の範囲の連続した波長帯域幅は177nmである。この波長帯域幅を設定波長910nmで割った値は約0. 195であり、仮想単層反射膜の場合の0. 061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0063]

[0064]

【表1】

表1

	多層反射膜の特性					
実	多層反射膜	設定波長 λ	極小反	Σ n _i d _i ,	R (λ) の	Δλ/λ
施	の構成	設定反射率	射率	波長 980nm	•	
の		R (λ)		の 1/4 波長	となる波長	
形				(245nm) と	帯域Δλ	
態				の対比		
1	7層膜	980nm	1.3%	1590.57nm	242nm	242/980=
		2 %		6.49 倍		0.246
2	7層膜	879nm	1.3%	1426.66nm	237nm	237/879=
		2 %		5.82 倍		0.270
3	7層膜	980nm	2.5%	1330.83nm	173nm	173/980=
	-	3 %		5.43 倍		0.177
4	7層膜	1035nm	2.5%	1405.57nm	183nm	183/1035=
		3 %		5.74 倍		0.177
5	7層膜	980nm	3.5%	1323.92nm	178nm	178/980=
		4 %		5.40 倍		0.182
6	7層膜	1040nm	3.5%	1405.95nm	189nm	189/1040=
		4 %		5.73 倍		0.182
7	7層膜	980nm	4.6%	1391.41nm	170nm	170/980=
		5 %		5.38 倍		0.173
8	7層膜	1035nm	4.6%	1391.41nm	170nm	170/1035=
L		5%		5.68 倍		0.164
9	7層膜	980nm	1.5%	2174.63nm	·157nm	157/980=
		2 %		8.88 倍		0.160
10	7層膜	908nm	1.5%	2014.81nm	145nm	145/908=
	a = n#+	2 %	0.007	8.22 倍	01	0.160
11	7層膜	980nm	2.6%	2201.59nm	91nm	91/980=
10	7 F2 IIII	3 %	2.6%	8.99 倍	00	0.093
12	7層膜	953nm 3 %	2.5%	2140.93nm 8.74 倍	89nm	89/953= 0.093
10	7 园 胜		9.70/		100	
13	7層膜	980nm 4 %	3.7%	2211.73nm 9.03 倍	190nm	190/980= 0.194
14	7 民時	912nm	3.7%	9.05 倍 2059.26nm	178nm	178/912=
14	7層膜	912nm 4 %	5.1%	2059.26nm 8.41 倍	1 18nm	0.195
15	7 民性	980nm	4.7%	0.41 倍 2213.24nm	190nm	190/980=
19	7層膜	980nm 5 %	4.1%	2213.24nm 9.03 倍	TAOUIU	0.194
16	7層膜	910nm	4.7%	9.05 信 2055.16nm	177nm	177/910=
10	1 化管膜	5 %	4.170	2055.16nm 8.39 倍	1111111	0.195
L	<u>l</u>	J 70	L	0.05 百	L	0.130

[0065]

実施の形態17.

本発明の実施の形態17に係る6層反射膜を備えた半導体光素子について図2

4及び図25を用いて説明する。図24は、半導体光素子の端面部の反射膜として、単層反射膜に代えて6層反射膜40を設けた場合の構成を示す概略断面図である。この半導体光素子は、実施の形態1に係る半導体光素子と比較すると、多層反射膜が6層反射膜40で構成されている点で相違する。この6層反射膜40の反射率が所定波長で前記仮想単層膜の反射率と同一に設定する条件について検討する。6層反射膜40の場合にも上記7層反射膜と同様に、振幅反射率は下記式(13)で表される。

【数16】

$$r = \frac{(m_{11} + m_{12})n_c - (m_{21} + m_{22})}{(m_{11} + m_{12})n_c + (m_{21} + m_{22})}$$
(13)

[0066]

ここで、m;;(i, jは1又は2)は下記式(14)で表される。

【数17】

$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos A\phi_1 & -\frac{i}{n_1} \sin A\phi_1 \\ -in_1 \sin A\phi_1 & \cos A\phi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos A\phi_2 & -\frac{i}{n_2} \sin A\phi_2 \\ -in_2 \sin A\phi_2 & \cos A\phi_2 \end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix} \cos B\phi_1 & -\frac{i}{n_1} \sin B\phi_1 \\ -in_1 \sin B\phi_1 & \cos B\phi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos B\phi_2 & -\frac{i}{n_2} \sin B\phi_2 \\ -in_2 \sin B\phi_2 & \cos B\phi_2 \end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix} \cos C\phi_1 & -\frac{i}{n_1} \sin C\phi_1 \\ -in_1 \sin C\phi_1 & \cos C\phi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos C\phi_2 & -\frac{i}{n_2} \sin C\phi_2 \\ -in_2 \sin C\phi_2 & \cos C\phi_2 \end{pmatrix} (14)$$

なお、A, B, Cは、第1層膜31の膜厚Ad1、第2層膜32の膜厚Ad2、第3層膜33の膜厚Bd1、第4層膜34の膜厚Bd2、第5層膜35の膜厚Cd1、第6層膜36の膜厚Cd2とした場合の、それぞれの2層膜(ペア)の寄与率を表すパラメータである。

[0067]

以下、半導体光素子の端面部に6層反射膜40を設けた場合について説明する。図24は、端面部に設けた6層反射膜40の構成を示す概略断面図である。この半導体光素子では、導波層10(等価屈折率nc=3.37)の端面部に順に、酸化タンタルの第1層膜31(屈折率n₁=2.057、膜厚Ad1)、アル

ミナの第2層膜32(屈折率 $n_2=1$. 62、膜厚Ad2)、酸化タンタルの第3層膜33(屈折率 $n_1=2$. 057、膜厚Bd1)、アルミナの第4層膜34(屈折率 $n_2=1$. 62、膜厚Bd2)、酸化タンタルの第5層膜35(屈折率 $n_1=2$. 057、膜厚Cd1)、アルミナの第6層膜36(屈折率 $n_2=1$. 62、膜厚Cd2)が積層されている。さらに、この6層反射膜40は、空気等の自由空間5に接している。

[0068]

[0069]

図25は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長877mmから1017nmにわたって反射率は極小値の1.4%から4.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長980nmの反射率2.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は140nmである。この波長帯域幅を所定波長980nmで割った値は約0.143であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有してい

ページ: 33/

ることがわかる。

[0070]

実施の形態18.

本発明の実施の形態 18 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 26 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 17 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1014$ n mで設定反射率 $R(\lambda)$ を 2.0%としている点で相違する。また、パラメータは A=2.0、B=2.0、C=2.0としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ $1=0.792828、<math>\phi$ 2=0.715471とすることによって波長 1014 n mで反射率 2.0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は A d 1/A d 1/B 1/

[0071]

図26は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の約3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長907nmから1053nmにわたって反射率は1.4%から4.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1014nmの設定反射率2.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は146nmである。この波長帯域幅を設定波長1014nmで割った値は約0.144であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この6層反射膜40は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0072]

実施の形態19.

本発明の実施の形態 19 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 27 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 17 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=980$ n mで設定反射率 $R(\lambda)$ を 3.0% としている点で相違する。また、パラメータは A=1.94、 B=1.90、 C=2.2 としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ $1=0.948585、<math>\phi$ 2=0.476939 とすることによって波長 980 n mで反射率 3.0% とすることができる。この場合、6 層反射膜のそれぞれの膜厚は A d 1/A d 1/B d 1/B d 1/C 1/C d 1/C 1

[0073]

図27は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の約4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長806mから1009nmにわたって反射率は2.3%から5.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率3.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は203nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.207であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この6層反射膜40は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0074]

実施の形態20.

本発明の実施の形態20に係る6層反射膜を備えた半導体光素子について、図

28を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 19に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1052$ nmで設定反射率 R (λ) を 3.0%としている点で相違する。また、パラメータは A=1.94、B=1.90、C=2.2としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=0.948585、 ϕ 2=0.476939とすることによって波長 1052 nmで反射率 3.0%とすることができる。この場合、6層反射膜のそれぞれの膜厚は Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=150.64 nm/96.17 nm/147.54 nm/94.19 nm/170.83 nm/109.06 nmである。全体の膜厚($d_{total}=\Sigma d_{i}$)は 768.43 nmである。また、それぞれの膜の屈折率 n_{i} と膜厚 d_{i} との積 n_{i} d_{i} の総和 Σ n_{i} d_{i} $d_$

[0075]

図28は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の約4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、反射率は2.3%から5.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1052nmの設定反射率3.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は218nmである。この波長帯域幅を設定波長1052nmで割った値は約0.207であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この6層反射膜40は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0076]

実施の形態21.

本発明の実施の形態 21 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 29 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 17 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=980$ n mで設定反射率 R (λ) を 4.0%としている点で相違する。また、パラメータは A=1.94、 B=1.90、 C=2

. 2としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 9 8 5 6 1、 ϕ 2 = 0. 4 1 7 5 4 5 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 4. 0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚はA d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 1 4 4 . 9 8 n m / 7 7. 9 9 n m / 1 4 1. 9 9 n m / 7 6. 3 8 n m / 1 6 4. 4 1 n m / 1 8 8. 4 4 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 7 9 4. 1 9 n m である。また、それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、1 4 8 3. 8 4 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6. 0 6 倍と非常に厚い。このため、端面における 放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0077]

図29は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の約5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長791nmから1020nmにわたって反射率は3.3%から6.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率4.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は229nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.234であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この6層反射膜40は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0078]

実施の形態22.

って波長1075nmで反射率4.0%とすることができる。この場合、6層反射膜のそれぞれの膜厚はAd1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=159.04nm/85.55nm/155.76nm/83.79nm/180.35nm/97.02nmである。全体の膜厚(dtotal= Σ di)は761.51nmである。また、それぞれの膜の屈折率niと膜厚diとの積nidiの総和 Σ nidiは、1450.03nmであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約5.92倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0079]

図30は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の約5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長854nmから1105nmにわたって反射率は3.3%から6.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1075nmの設定反射率4.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は251nmである。この波長帯域幅を設定波長1075nmで割った値は約0.233であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この6層反射膜40は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0800]

実施の形態23.

本発明の実施の形態 2 3 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 3 1 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 7 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=9$ 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 5 . 0%としている点で相違する。また、パラメータは A=2 . 0 4 、 B=1 . 9 2 、 C=2 . 2 としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1=0 . 9 3 7 9 3、 ϕ 2=0 . 4 3 3 8 7 9 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 5 . 0%とすることができる。この場合、 6 層反射膜のそれぞれの膜厚は A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2=1 4 5

. $08\,\mathrm{nm}/85$. $22\,\mathrm{nm}/136$. $55\,\mathrm{nm}/80$. $21\,\mathrm{nm}/156$. $46\,\mathrm{nm}/91$. $90\,\mathrm{nm}$ である。全体の膜厚($d_{total}=\Sigma d_i$)は695. $42\,\mathrm{nm}$ である。また、それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σn_i d_i は、1318. $03\,\mathrm{nm}$ であり、所定波長 $980\,\mathrm{nm}$ の1/4波長($=245\,\mathrm{nm}$)の約5. 38倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0081]

図31は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の約6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長787mから1009nmにわたって反射率は4.6%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率5.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、4.0%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は222nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.227であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この6層反射膜40は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0082]

実施の形態24.

758.58 n m である。また、それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i は、1437.73 n m であり、所定波長 980 n m の 1/4 波長(= 245 n m)の約5.87倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0083]

図32は、この6層反射膜40の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、目標反射率の約6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長858nmから1101nmにわたって反射率は4.6%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1069nmの設定反射率5.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、4.0%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は243nmである。この波長帯域幅を設定波長1069nmで割った値は約0.227であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この6層反射膜40は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0084]

[0085]

【表2】

表 2

	多層反射膜の特性						
実	多層反射	設定波長λ	極小反	$\Sigma n_i d_i$	R (λ) の	Δλ/λ	
施	膜の構成	設定反射率	射率	波長 980nm	-1.0~2.0%		
の		R (λ)		の 1/4 波長	となる波長		
形				(245nm) と	帯域∆λ		
態				の対比			
17	6層膜	980nm	1.4%	1411.50nm	140nm	140/980=	
		2 %		5.76 倍		0.143	
18	6 層膜	1014nm	1.4%	1460.47nm	146nm	146/1014=	
		2 %		5.96 倍		0.144	
19	6 層膜	980nm	2.3%	1342.95nm	203nm	203/980=	
		3 %		5.48 倍		0.207	
20	6 層膜	1014nm	2.3%	1449.81nm	218nm	218/1014=	
		3 %		5.92 倍		0.207	
21	6 層膜	980nm	3.3%	1483.84nm	229nm	229/980=	
		4 %		6.06 倍		0.234	
22	6 層膜	1075nm	3.3%	1450.03nm	251nm	251/1075=	
		4 %		5.92 倍		0.233	
23	6 層膜	980nm	4.6%	1318.03nm	222nm	222/980=	
		5 %		5.38 倍		0.227	
24	6 層膜	1069nm	4.6%	1437.73nm	243nm	243/1069=	
		5 %		5.87 倍		0.164	

[0086]

実施の形態25.

本発明の実施の形態25に係る3種類の膜を含む7層反射膜を備えた半導体光素子について図33及び図34を用いて説明する。図33は、半導体光素子の端面部の反射膜として、単層反射膜に代えて3種類の膜からなる7層反射膜50を設けた場合の構成を示す概略断面図である。この半導体光素子は、実施の形態1に係る半導体光素子と比較すると、多層反射膜が3種類の膜からなる7層反射膜50で構成されている点で相違する。さらに詳細には、導波層10に接する第1層膜が窒化アルミニウム膜41である点で相違する。なお、第2層膜から第7層膜にかけては酸化タンタル及びアルミナが交互に積層されている点で共通する。

[0087]

この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率が所定波長で上記仮想単層膜の 反射率と同一に設定する条件について検討する。ここでは、導波層10に接する 第1層膜に第3の種類の膜を用いた場合について検討する。この第3の膜の位相 変化 ϕ 3 は、下記式(15)で表される。

【数18】

$$\phi_3 = \frac{2\pi}{\lambda} n_3 d_3 \tag{1.5}$$

[0088]

そこで、この3種類の膜からなる7層反射膜50の振幅反射率は、上記7層反射膜、6層反射膜と同様に下記式(16)で表される。

【数19】

$$r = \frac{\left(m_{11} + m_{12}\right)n_c - \left(m_{21} + m_{22}\right)}{\left(m_{11} + m_{12}\right)n_c + \left(m_{21} + m_{22}\right)} \tag{1 6}$$

[0089]

ここで、m_{ii}(i, jは1又は2)は下記式(17)で表される。

【数20】

$$\begin{pmatrix}
m_{11} & m_{12} \\
m_{21} & m_{22}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\cos\phi_{3} & -\frac{i}{n_{3}}\sin\phi_{3} \\
-in_{3}\sin\phi_{3} & \cos\phi_{3}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos A\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}}\sin A\phi_{1} \\
-in_{1}\sin A\phi_{1} & \cos A\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos A\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}}\sin A\phi_{2} \\
-in_{2}\sin A\phi_{2} & \cos A\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos B\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}}\sin B\phi_{1} \\
-in_{1}\sin B\phi_{1} & \cos B\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos B\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}}\sin B\phi_{2} \\
-in_{2}\sin B\phi_{2} & \cos B\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos C\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}}\sin C\phi_{1} \\
-in_{1}\sin C\phi_{1} & \cos C\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos C\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}}\sin C\phi_{2} \\
-in_{2}\sin C\phi_{2} & \cos C\phi_{2}
\end{pmatrix} (17)$$

なお、A, B, Cは、第2層膜42の膜厚Ad1、第3層膜43の膜厚Ad2、第4層膜44の膜厚Bd1、第5層膜45の膜厚Bd2、第6層膜46の膜厚Cd1、第7層膜47の膜厚Cd2とした場合の、それぞれの2層膜(ペア)の寄与率を表すパラメータである。

[0090]

以下、半導体光素子の端面部に3種類の膜を含む7層反射膜50を設けた場合について説明する。図33は、端面部に設けた3種類の膜を含む7層反射膜の構成を示す概略断面図である。この半導体光素子では、導波層10(等価屈折率 n c = 3.37)の端面部に順に、窒化アルミニウム(A1N)の第1層膜41(屈折率 n 3 = 2.072、膜厚 d 3 = 50 n m)、酸化タンタルの第2層膜42(屈折率 n 1 = 2.057、膜厚 Ad1)、アルミナの第3層膜43(屈折率 n 2 = 1.62、膜厚 Ad2)、酸化タンタルの第4層膜44(屈折率 n 1 = 2.057、膜厚 Bd1)、アルミナの第5層膜45(屈折率 n 2 = 1.62、膜厚 Bd2)、酸化タンタルの第6層膜46(屈折率 n 1 = 2.057、膜厚 Cd1)、アルミナの第7層膜47(屈折率 n 2 = 1.62、膜厚 Cd2)が積層されている。さらに、この7層反射膜50は、空気等の自由空間5に接している。

[0091]

まず、窒化アルミニウム、酸化タンタル、アルミナの 3 種類の膜を含む 7 層反射膜の熱特性について説明する。この 3 種類の膜の熱伝導率は、順に、約 1.8 W/(c m・K)、約 0.1 W/(c m・K)、約 0.2 W/(c m・K)なので、窒化アルミニウムが最も熱伝導率が高い。このため導波層 10 の熱を迅速に外部に放熱させることができる。

[0092]

次に、この半導体光素子の端面部の3種類の膜を含む7層反射膜50の反射特性について説明する。まず、設定波長 $\lambda=980$ n mで設定反射率R(λ)を2.0%とする。各パラメータを、A=1.0、B=2.0、C=2.0とした場合、酸化タンタル及びアルミナの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2が、それぞれ ϕ 1=1.23574、 ϕ 2=0.727856である場合に波長980 n mで反射率2%が得られる。なお、窒化アルミニウムの第1層膜41の厚みd3は予め50 n mとして、 ϕ 3は既知の定数として用い、変数には ϕ 1及び ϕ 2のみを用いた。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は、d3/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=50 n m/93.7 n m/70.08 n m/187.40 n m/140.15 n mである。全体の

膜厚($d_{total} = \Sigma d_i$)は868.88 nmである。また、それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σn_i d_i は、1634.92 nmであり、 $\lambda / 4$ (=245 nm)の約6.67倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0093]

図34は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長952nmから1194nmにわたって反射率は極小値の1.6%から4.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長980nmの反射率2.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は242nmである。この波長帯域幅を所定波長980nmで割った値は約0.247であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0094]

実施の形態26.

mであり、所定波長 980 n mの 1/4 波長(=245 n m)の約6.07倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0095]

図35は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長872nmから1086nmにわたって反射率は1.5%から4.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長897nmの設定反射率2.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は214nmである。この波長帯域幅を設定波長897nmで割った値は約0.239であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜50は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0096]

実施の形態27.

と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を 抑制できる。

[0097]

図36は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長953nmから1195nmにわたって反射率は2.6%から5.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率3.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は242nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.247であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜50は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0098]

実施の形態28.

本発明の実施の形態 2 8 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図3 7 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 2 7 と比較すると、その構成において共通するが、設定波長 λ = 8 9 6 n mで設定反射率 R (λ) を 3. 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1. 0、B = 2. 0、C = 2. 0としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 1. 2 3 5 7 4、 ϕ 2 = 0. 7 2 7 8 5 6 とすることによって波長 8 9 6 n mで反射率 3. 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は、d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 / 8 1. 0 8 n m / 6 8. 1 5 n m / 1 6 2. 1 6 n m / 1 3 6. 3 1 n m / 1 6 2. 1 6 n m / 1 3 6. 3 1 n m / 1 6 2. 1 6 n m / 1 3 6. 3 1 n m / 1 6 2. 1 6 n m / 1 3 6. 3 1 n m / 1 6 2. 1 6 n m / 1 3 6. 3 1 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i) は 7 9 6. 1 7 n m である。また、それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、1 4 8 9. 5 6 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6. 0 8 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を

抑制できる。

[0099]

図37は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長872nmから1089nmにわたって反射率は2.5%から5.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長896nmの設定反射率3.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は217nmである。この波長帯域幅を設定波長896nmで割った値は約0.242であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜50は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0100]

実施の形態29.

本発明の実施の形態 2 9 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 3 8 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 2 5 と比較すると、その構成において共通するが、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率R(λ)を 4 . 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1 . 0、B = 2 . 0、C = 2 . 0としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 1 . 1 7 4 5 9、 ϕ 2 = 0 . 7 9 8 8 7 4 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 4 . 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は、d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 / 8 9 . 0 6 n m / 7 6 . 9 1 n m / 1 7 8 . 1 3 n m / 1 5 3 . 8 3 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は8 7 9 . 8 9 n m である。また、それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、1 6 4 2 . 6 3 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6 . 7 0 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0101]

図38は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長953nmから1198nmにわたって反射率は3.6%から6.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率4.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は245nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.250であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜50は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0102]

実施の形態30.

本発明の実施の形態30に係る3種類の膜を含む7層反射膜を備えた半導体光素子について、図39を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態29に係る半導体光素子と比較すると、その構成において共通するが、設定波長 $\lambda=893$ nmで設定反射率R(λ)を4.0%としている点で相違する。また、パラメータはA=1.0、B=2.0、C=2.0としている。さらに、アルミナ及び酸化タンタルのそれぞれの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=1.14262、 ϕ 2=0.805876とすることによって波長893nmで反射率4.0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は、d3/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=50/78.95nm/70.70nm/157.90nm/141.40nm/157.90nm/1420.00nm/1420.

[0103]

図39は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長870nmから1090nmにわたって反射率は3.4%から6.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長893nmの設定反射率4.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は220nmである。この波長帯域幅を設定波長893nmで割った値は約0.246であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜50は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0104]

実施の形態31.

[0105]

図40は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示す

グラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の約6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長952nmから1201nmにわたって反射率は4.6%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの設定反射率5.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、4.0%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は249nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.254であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜50は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0106]

実施の形態32.

[0107]

図41は、この3種類の膜を含む7層反射膜50の反射率の波長依存性を示す グラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射 膜は、目標反射率の約6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長867nmから1093nmにわたって反射率は4.4%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長890nmの設定反射率5.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、4.0%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は226nmである。この波長帯域幅を設定波長890nmで割った値は約0.254であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そこで、この7層反射膜50は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0108]

[0109]

【表3】

表3

	多層反射膜の特性						
実	多層反射膜	設定波長λ	極小反	$\Sigma n_i d_i$	R (λ) の	Δλ/λ	
施	の構成	設定反射率	射率	波長 980nm	-1.0~2.0%		
の		R (λ)		の 1/4 波長	となる波長		
形				(245nm) と	帯域Δλ		
態				の対比			
25	7層膜	980nm	1.6%	1634.92nm	242nm	242/980=	
	(3種類)	2 %		6.67 倍		0.247	
26	7層膜	897nm	1.5%	1487.24nm	214nm	214/897=	
	(3種類)	2 %		6.07 倍		0.239	
27	7層膜	980nm	2.6%	1638.64nm	242nm	242/980=	
	(3種類)	3 %		6.69 倍		0.247	
28	7層膜	896nm	2.5%	1489.56nm	217nm	217/896=	
	(3種類)	3 %		6.08 倍		0.242	
29	7層膜	980nm	3.6%	1642.63nm	245nm	245/980=	
	(3種類)	4 %		6.70 倍		0.250	
30	7層膜	893nm	3.4%	1488.27nm	220nm	220/893=	
	(3種類)	4 %		6.07 倍		0.246	
31	7層膜	980nm	4.6%	1646.79nm	249nm	249/980=	
	(3種類)	5 %		6.72 倍		0.254	
32	7層膜	890nm	4.4%	1486.93nm	226nm	226/890=	
	(3種類)	5 %		6.07 倍		0.254	

[0110]

実施の形態33.

本発明の実施の形態33に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について図42及び43を用いて説明する。図42は、半導体光素子の端面部の反射膜として、単層反射膜に代えて9層反射膜60を設けた場合の構成を示す概略断面図である。この半導体光素子は、実施の形態1に係る半導体光素子と比較すると、多層反射膜が9層反射膜60で構成されている点で相違する。この9層反射膜60の反射率が所定波長で前記仮想単層膜の反射率と同一にする条件について検討する。9層反射膜60の振幅反射率は、上記4層反射膜及び7層反射膜と同様に下記式(18)で表される。

【数21】

$$r = \frac{(m_{11} + m_{12})n_c - (m_{21} + m_{22})}{(m_{11} + m_{12})n_c + (m_{21} + m_{22})}$$
(18)

[0111]

ここで、 m_{ij} (i, jは1又は2)は下記式(19)で表される。

【数22】

$$\begin{pmatrix}
m_{11} & m_{12} \\
m_{21} & m_{22}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\cos O\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin O\phi_{2} \\
-in_{2} \sin O\phi_{2} & \cos O\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos A\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}} \sin A\phi_{1} \\
-in_{1} \sin A\phi_{1} & \cos A\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos A\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin A\phi_{2} \\
-in_{2} \sin A\phi_{2} & \cos A\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos B\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}} \sin B\phi_{1} \\
-in_{1} \sin B\phi_{1} & \cos B\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos B\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin B\phi_{2} \\
-in_{2} \sin B\phi_{2} & \cos B\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos C\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}} \sin C\phi_{1} \\
-in_{1} \sin C\phi_{1} & \cos C\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos C\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin C\phi_{2} \\
-in_{2} \sin C\phi_{2} & \cos C\phi_{2}
\end{pmatrix}$$

$$\times \begin{pmatrix}
\cos D\phi_{1} & -\frac{i}{n_{1}} \sin D\phi_{1} \\
-in_{1} \sin D\phi_{1} & \cos D\phi_{1}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
\cos D\phi_{2} & -\frac{i}{n_{2}} \sin D\phi_{2} \\
-in_{2} \sin D\phi_{2} & \cos D\phi_{2}
\end{pmatrix} (19)$$

なお、O, A, B, C, Dは、第1層膜51の膜厚Od2、第2層膜52の膜厚Ad1、第3層膜63の膜厚Ad2、第4層膜54の膜厚Bd1、第5層膜55の膜厚Bd2、第6層膜56の膜厚Cd1、第7層膜57の膜厚Cd2、第8層膜58の膜厚Dd1、第9層膜59の膜厚Dd2において、第1層膜31を除き、それぞれの2層膜(ペア)の寄与率を表すパラメータである。

[0112]

以下、半導体光素子の端面部に 9層反射膜 6 0 を設けた場合について説明する。図4 2 は、端面部に設けた 9層反射膜の構成を示す概略断面図である。この半導体光素子では、導波層 1 0 (等価屈折率 n c = 3. 3 7) の端面部に順に、アルミナの第 1 層膜 5 1 (屈折率 n 2 = 1. 6 2、膜厚 O d 2)、酸化タンタルの第 2 層膜 5 2 (屈折率 n 1 = 2. 0 5 7、膜厚 A d 1)、アルミナの第 3 層膜 5 3 (屈折率 n 2 = 1. 6 2、膜厚 A d 2)、酸化タンタルの第 4 層膜 5 4 (屈折率 n 1 = 2. 0 5 7、膜厚 B d 1)、アルミナの第 5 層膜 5 5 (屈折率 n 2 = 1. 6 2、膜厚 B d 2)、酸化タンタルの第 6 層膜 5 6 (屈折率 n 1 = 2. 0 5 7、膜厚 C d 1)、アルミナの第 7 層膜 5 7 (屈折率 n 2 = 1. 6 2、膜厚 C d 2

)、酸化タンタルの第6層膜56(屈折率 n₁ = 2.057、膜厚Cd1)、アルミナの第7層膜57(屈折率 n₂ = 1.62、膜厚Cd2)、酸化タンタルの第8層膜58(屈折率 n₁ = 2.057、膜厚Cd1)、アルミナの第9層膜59(屈折率 n₂ = 1.62、膜厚Cd2)が積層されている。さらに、この9層反射膜60は、空気等の自由空間5に接している。

[0113]

この半導体光素子の端面部の 9層反射膜 6 0 の反射特性について説明する。まず、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R(λ)を 2%とする。各パラメータを、O=0.2、A=2.7、B=2.0、C=2.0、D=2.0とした場合、酸化タンタル及びアルミナの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 が、それぞれ ϕ 1 = 0.3 5 7 6 9、 ϕ 2 = 0.9 5 8 0 7 7 である場合に波長 9 8 0 n mで反射率 2%が得られる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚は、Od 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 / D d 1 / D d 2 = 1 8.4 5 n m / 7 3.2 3 n m / 2 4 9.0 6 n m / 5 4.2 4 n m / 1 8 4.4 9 n m / 5 4.2 4 n m /

[0114]

図43は、この9層反射膜60の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、目標反射率の3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長877mmから1007nmにわたって反射率は極小値の1.6%から4.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長980nmの反射率2.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は130nmである。この波長帯域幅を所定波長980nmで割った値は約0.133であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そ

こで、この9層反射膜60は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0115]

実施の形態34.

本発明の実施の形態34に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 4 4 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 3 3 と比較すると、そ の構成において共通するが、設定波長衤=1020nmで設定反射率R(衤)を 0%としている点で相違する。また、パラメータはO=0.2,A=2.7 、B=2.0、C=2.0、D=2.0としている。さらに、アルミナ及び酸化 タンタルのそれぞれの位相変化は1及びは2を、は1=0.35769、は2= 0.958077とすることによって波長1020nmで反射率2.0%とする ことができる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚は、0 d 2 / A d 1 / A d 2/B d 1/B d 2/C d 1/C d 2/D d 1/D d 2 = 19. 20 n m/76. 22 nm/259. 22 nm/56. 46 nm/192. 02 nm/56. 46 nm/192.02 nm/56.46 nm/192.02 nmである。全体 の膜厚($d_{total} = \Sigma d_i$)は1100.08nmである。また、それぞれ の膜の屈折率n;と膜厚d;との積n;d;の総和Σn;d;は、1889.4 6 nmであり、所定波長980 nmの1/4波長 (= 245 nm) の約7.71 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇 を抑制できる。

[0116]

図44は、この9層反射膜60の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、目標反射率の約3%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長912nmから1048nmにわたって反射率は1.6%から4.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1020nmの設定反射率2.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、1.0%~4.0%の範囲の連続した波長帯域幅は136nmである。この波長帯域幅を設定波長1020nmで割った値は約0.133であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。

そこで、この9層反射膜60は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有 していることがわかる。

[0117]

実施の形態35.

本発明の実施の形態35に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 45を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態33に係る半導体光素 子と比較すると、その構成において共通するが、設定波長 $\lambda = 980$ nmで設定 反射率R(λ)を3.0%としている点で相違する。また、各パラメータを、O =0.2、A=2.7、B=2.0、C=2.0、D=2.0とした場合、酸化 タンタル及びアルミナの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2が、それぞれ ϕ 1=0.3773 48、 φ 2 = 0. 9 3 5 4 1 6 である場合に波長 9 8 0 n m で 反射率 3 % が 得ら れる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚は、Od2/Ad1/Ad2/B d 1/B d 2/C d 1/C d 2/D d 1/D d 2 = 18.01 nm/77.25nm/243.16nm/57.22nm/180.12nm/57.22nm /180.12nm/57.22nm/180.12nmである。全体の膜厚 ($d_{total} = \sum d_i$)は1050.44nmである。また、それぞれの膜の屈 折率niと膜厚diとの積nidiの総和∑n;diは、1810.49nmで あり、所定波長980nmの1/4波長 (=245nm) の約7. 49倍と非常 に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制で きる。

[0118]

図45は、この9層反射膜60の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、目標反射率の4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長882nmから1007nmにわたって反射率は極小値の2.6%から5.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長980nmの反射率3.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は125nmである。この波長帯域幅を所定波長980nmで割った値は約0.128であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そ

こで、この9層反射膜60は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0119]

実施の形態36.

本発明の実施の形態36に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 46を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態35に係る半導体光素 子と比較すると、その構成において共通するが、設定波長 λ = 1 0 1 7 n m で設 定反射率R(λ)を3.0%としている点で相違する。また、各パラメータを、 O=0.2、A=2.7、B=2.0、C=2.0、D=2.0とした場合、酸 化タンタル及びアルミナの位相変化 φ 1 及び φ 2 が、それぞれ φ 1 = 0 . 3 7 7 3 4 8 、 φ 2 = 0 . 9 3 5 4 1 6 である場合に波長 1 0 1 7 n mで反射率 3 %が 得られる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚は、0d2/Ad1/Ad2 /Bd1/Bd2/Cd1/Cd2/Dd1/Dd2=18.69nm/80.17 nm/252.35 nm/59.39 nm/186.92 nm/59.39 nm/186.92nm/59.39nm/186.92nmである。全体の膜 厚 $(d_{t,0,t,a}) = \Sigma d_i$ は 1090.14 nmである。また、それぞれの膜 の屈折率n;と膜厚d;との積n;d;の総和Σn;d;は、1878.92n mであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm) の約7.67倍と 非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑 制できる。

[0120]

図46は、この9層反射膜60の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、目標反射率の4%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長915nmから1045nmにわたって反射率は極小値の2.6%から5.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長1017nmの反射率3.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、2.0%~5.0%の範囲の連続した波長帯域幅は130nmである。この波長帯域幅を所定波長1017nmで割った値は約0.128であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい

。そこで、この9層反射膜60は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を 有していることがわかる。

[0121]

実施の形態37.

本発明の実施の形態37に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 47を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態33に係る半導体光素 子と比較すると、その構成において共通するが、設定波長λ=980nmで設定 反射率R (λ)を4.0%としている点で相違する。また、各パラメータを、O =0.15、A=2.8、B=2.0、C=2.0、D=2.0とした場合、酸 化タンタル及びアルミナの位相変化φ1及びφ2が、それぞれφ1=0.387 25、 φ 2 = 0. 9 1 1 3 6 9 である場合に波長 9 8 0 n m で反射率 4 % が得ら れる。この場合、 9 層反射膜のそれぞれの膜厚は、 O d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1/B d 2/C d 1/C d 2/D d 1/D d 2 = 1 3. 16 n m/8 2. 2 2 nm/245.69nm/58.73nm/175.49nm/58.73nm /175.49nm/58.73nm/175.49nmである。全体の膜厚($d_{total} = \sum d_i$)は1043.73nmである。また、それぞれの膜の屈 折率niと膜厚diとの積nidiの総和Σnidiは、1803.77nmで あり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約7.36倍と非常 に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制で きる。

[0122]

図47は、この9層反射膜60の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、目標反射率の5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長883nmから1006nmにわたって反射率は極小値の3.6%から6.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長980nmの反射率4.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は123nmである。この波長帯域幅を所定波長980nmで割った値は約0.126であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。そ

こで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0123]

実施の形態38.

本発明の実施の形態38に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 4 8 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 3 7 に係る半導体光素 子と比較すると、その構成において共通するが、設定波長λ=1017nmで設 定反射率R(λ)を4.0%としている点で相違する。また、各パラメータを、 O=0.15、A=2.8、B=2.0、C=2.0、D=2.0とした場合、 酸化タンタル及びアルミナの位相変化41及び42が、それぞれ41=0.38 7 2 5 、 φ 2 = 0 . 9 1 1 3 6 9 である場合に波長 1 0 1 7 n m で反射率 4 % が 得られる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚は、0d2/Ad1/Ad2 /Bd1/Bd2/Cd1/Cd2/Dd1/Dd2=13.66nm/85.32 nm / 245. 96 nm / 60. 94 nm / 182. 12 nm / 60. 94nm/182.12nm/60.94nm/182.12nmである。全体の膜 厚($d_{total} = \Sigma d_i$)は1083.12 nmである。また、それぞれの膜 の屈折率niと膜厚diとの積nidiの総和Σn;diは、1871.83n mであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約7.64倍と 非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑 制できる。

[0124]

図48は、この9層反射膜60の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、目標反射率の5%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長916nmから1044nmにわたって反射率は極小値の3.6%から6.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長1017nmの反射率4.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、3.0%~6.0%の範囲の連続した波長帯域幅は128nmである。この波長帯域幅を所定波長1017nmで割った値は約0.126であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい

。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0125]

実施の形態39.

本発明の実施の形態39に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 49を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態33に係る半導体光素 子と比較すると、その構成において共通するが、設定波長λ=980nmで設定 反射率 R (λ)を 5.0%としている点で相違する。また、各パラメータを、O =0.10、A=2.9、B=2.0、C=2.0、D=2.0とした場合、酸 化タンタル及びアルミナの位相変化φ1及びφ2が、それぞれφ1=0.397 5 1 9 、 φ 2 = 0 . 8 8 6 9 9 2 である場合に波長 9 8 0 n mで反射率 5 %が得 られる。この場合、 9 層反射膜のそれぞれの膜厚は、 O d 2 / A d 1 / A d 2 / Bd1/Bd2/Cd1/Cd2/Dd1/Dd2=8.54nm/87.41nm/247.66nm/60.28nm/170.80nm/60.28nm /170.80nm/60.28nm/170.80nmである。全体の膜厚($d_{total} = \sum d_i$) は1036.85 n m である。また、それぞれの膜の屈 折率n;と膜厚d;との積n;d;の総和Σn;d;は、1801.04nmで あり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約7.35倍と非常 に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制で きる。

[0126]

図49は、この9層反射膜60の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、目標反射率の約6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長890nmから1006nmにわたって反射率は極小値の4.6%から7.0%の範囲内に収まっている。また、所定波長980nmの反射率5.0%を基準として、-1.0%から+2.0%の範囲、即ち、4.0%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は116nmである。この波長帯域幅を所定波長980nmで割った値は約0.118であり、仮想単層反射膜の場合の0.061より大きい。

ページ: 60/

そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0127]

実施の形態40.

本発明の実施の形態40に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 50を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態39に係る半導体光素 子と比較すると、その構成において共通するが、設定波長 $\lambda = 1013$ nmで設 定反射率R (λ)を5.0%としている点で相違する。また、各パラメータを、 O=0.10、A=2.9、B=2.0、C=2.0、D=2.0とした場合、 酸化タンタル及びアルミナの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2が、それぞれ ϕ 1=0.39 7519、φ2=0.886992である場合に波長1013nmで反射率5% が得られる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚は、0 d 2 / A d 1 / A d 2/B d 1/B d 2/C d 1/C d 2/D d 1/D d 2 = 8.83 n m/9 0.35 nm / 256.00 nm / 62.31 nm / 176.55 nm / 62.31nm/176.55nm/62.31nm/176.55nmである。全体の膜 厚(d _{t o t a l} = Σ d _i)は 1 0 7 1 . 7 6 n m である。また、それぞれの膜 の屈折率n;と膜厚d;との積n;d;の総和Σn;d;は、1857.42n mであり、所定波長980nmの1/4波長 (=245nm) の約7.58倍と 非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑 制できる。

[0128]

図 5 0 は、この 9 層反射膜 6 0 の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この 9 層反射膜は、目標反射率の 6 % 前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長 9 2 0 n m から 1 0 4 0 n m にわたって反射率は極小値の 4 . 6 % から 7 . 0 % の範囲内に収まっている。また、設定波長 1 0 1 3 n m の反射率 5 . 0 % を基準として、-1. 0 % から +2. 0 % の範囲、即ち、4. 0 % -7. 0 % の範囲の連続した波長帯域幅 Δ λ は 1 2 0 n m である。この波長帯域幅を設定波長 λ = 1 0 1 3 n m で割った値は約 0 . 1 1 8 であり、仮想単層反射膜の場合の 0 . 0 6 1 よ

り大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦 部を有していることがわかる。

[0129]

[0130]

【表4】

表 4

	多層反射膜の特性						
実	多層反射	設定波長λ	極小反	Σ n $_{i}$ d $_{i}$.	R (λ) Ø	Δλ/λ	
施	膜の構成	設定反射率	射率	波長 980nm の	-1.0~2.0%		
の		R (λ)		1/4 波 長	となる波長		
形				(245nm) との	帯域Δλ		
態				対比			
33	9層膜	980nm	1.4%	1815.34nm	130nm	130/980=	
		2 %		7.41 倍		0.133	
34	9層膜	1020nm	1.4%	1889.46nm	136nm	136/1020=	
		2 %		7.71 倍		0.133	
35	9層膜	980nm	2.6%	1810.49nm	125nm	125/980=	
		3 %		.7.49 倍		0.128	
36	9層膜	1017nm	2.6%	1878.92nm	130nm	130/1017=	
L		3 %		7.67 倍		0.128	
37	9層膜	980nm	3.6%	1803.77nm	123nm	123/980=	
		4 %		7.36 倍		0.126	
38	9 層膜	1017nm	3.6%	1871.83nm	128nm	128/1017=	
		4 %		7.64 倍		0.126	
39	9層膜	980nm	4.6%	1801.04nm	116nm	116/980=	
		5 %		7.35 倍		0.118	
40	9層膜	1013nm	4.6%	1857.42nm	120nm	120/1013=	
		5 %		7.58 倍		0.118	

[0 1 3 1]

実施の形態41.

本発明の実施の形態3に係る7層反射膜を備えた半導体光素子について、図5

[0132]

図51は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長828nmから1009nmにわたって反射率は5.4%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率6.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、5.0%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は181nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.185であり、仮想単層反射膜の場合の0.062より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0133]

実施の形態42.

本発明の実施の形態42に係る7層反射膜を備えた半導体光素子について、図52を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態41に係る半導体光素

子と比較すると、設定波長 $\lambda=1045$ n mで設定反射率 R(λ)を6.0%としている点で相違する。また、パラメータはO=0.15、A=1.95、B=2.0, C=2.0としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.541022、 ϕ 2 = 0.741397とすることによって波長1045 n mで反射率6.0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚はO d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 8.91 n m / 133.28 n m / 115.77 n m / 136.70 n m / 118.74 n m / 136.76 8.84 n m / 136.86 / 2 4 n m / 2 6 8.84 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 4 n m / 3 6 8 8 9 8 0 m / 3 6 8 8 9 0 m / 3 6 8 8 9 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 8 9 8 0 n m / 3 6 9 8 0 n m / 3 6 9 8 0 n m / 4 / 4 0 m / 5 8 1 6 8 9 8 0 n m / 3 6 9 8 0 n m / 4 / 4 0 m / 5 8 1 6 8 9 8 0 n m / 3 6 9 8 0 n m / 4 / 4 n m / 5 8 1 6 8 9 8 0 n m / 4 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 6 8 1 6 / 5 0 / 5 0 / 6 8 1 6 / 5 0 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 7 0 n m / 1 1 8 / 7 0 n m / 1 8 / 9 / 1 1 8 / 9 / 1 1 8 / 9 / 1 1 8 / 1 1 8 / 9 / 1 1 8 / 1

[0134]

図52は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長883 nmから1076 nmにわたって反射率は5.4%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1045 nmの設定反射率6.0%を基準として、一1.0%から+2.0%の範囲、即ち、反射率5.0%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は193 nmである。この波長帯域幅を設定波長1045 nmで割った値は約0.185であり、仮想単層反射膜の場合の0.062より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0135]

以下に、実施の形態 4 1 と実施の形態 4 2 とに係る半導体光素子の多層反射膜の特性について、表 5 に示した。表 5 には、多層反射膜の特性として、多層反射膜の構成、設定波長 λ 及び設定反射率 R (λ)、極小反射率、Σ n i d i 及び所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長 (2 4 5 n m) との対比、R (λ) の − 1.0 ~

+2.0%の範囲となる波長帯域幅 $\Delta\lambda$ 、 $\Delta\lambda/\lambda$ について示した。

[0136]

【表 5】

表 5

	多層反射膜の特性						
実	多層反射	設定波長λ	極小反	$\Sigma n_i d_i$	R (λ) の	Δλ/λ	
施	膜の構成	設定反射率	射率	波長 980nm の	-1.0~2.0%		
の		R (λ)		1/4 波 長	となる波長		
形				(245nm) との	帯域Δλ		
態				対比			
41	7層膜	980nm 6 %	5.4%	1334.70nm 5.45 倍	181nm	181/980= 0.185	
42	7層膜	1045nm 6 %	5.4%	1423.24nm 5.81 倍	193nm	193/1045= 0.185	

[0137]

実施の形態43.

[0138]

図53は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長813nmから994nmにわたって反射率は5.0%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率6.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は181nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.185である。

[0139]

ここで、比較のために導波光の所定波長980nmについて5/4波長の厚さの仮想単層反射膜を仮定する。設定条件は、波長980nmで極小反射率4%をとるように、nc=3.37、nl=1.449である。この場合、極小反射率を基準として+2.5%、すなわち反射率4% \sim 6.5%の波長範囲は949nm \sim 1013nmであり、その波長帯域幅は64nmである。この波長帯域幅の広さの目安として、導波光の所定波長980nmで割ると0.065が得られる

[0140]

そこで、この実施の形態 4 3 に係る 7 層反射膜について、上記仮想単層反射膜と比較すると、導波光の波長での反射率 + 2.5%となる波長帯域幅をその波長で割った商は、0.185であり、仮想単層反射膜の0.065よりはるかに大きい。そこで、この7 層反射膜は、広い波長帯域にわたって平坦部を有していることがわかる。

[0141]

実施の形態44.

本発明の実施の形態 44 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 54 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 43 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1063$ n mで設定反射率 R (λ) を 6.0% としている点で相違する。また、パラメータは 0=0.20、A=1.97、B=

2. 35, C=2. 10としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=0. 79703、 ϕ 2=0. 528684とすることによって波長1063nmで反射率6. 0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚はOd2/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=11. 04nm/129. 14nm/108. 77nm/154. 05nm/129. 75nm/137. 66nm/115. 95nm である。全体の膜厚(d101al= Σ 11diの総和 Σ 11diは、1457. Σ 12nmであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約5. Σ 13倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

$[0 \ 1 \ 4 \ 2]$

図54は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、目標反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長882nmから1078nmにわたって反射率は5.0%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1063nmの設定反射率6.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は196nmである。この波長帯域幅を設定波長1063nmで割った値は約0.184であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって平坦部を有していることがわかる。

[0143]

実施の形態45.

本発明の実施の形態 45 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 55 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=980$ n mで設定反射率 $R(\lambda)$ を 7.0 %としている点で相違する。また、パラメータは O=0.17、A=1.97、B=2.35, C=2.05 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれ

の位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 8 0 7 6 3、 ϕ 2 = 0. 5 2 5 8 0 3 と することによって波長 9 8 0 n mで反射率 7. 0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は O d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 8. 6 1 n m / 1 2 0. 6 4 n m / 9 9. 7 3 n m / 1 4 3. 9 1 n m / 1 1 8. 9 7 n m / 1 2 5. 5 4 n m / 1 0 3. 7 8 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 7 2 1. 1 8 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、 1 3 3 8. 7 8 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 5. 4 6 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0144]

図55は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長797nmから993nmにわたって反射率は5.9%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率6.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は196nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.200であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0145]

実施の形態46.

 反射膜のそれぞれの膜厚はO d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 9. 4 2 n m / 1 3 2. 0 9 n m / 1 0 9. 1 9 n m / 1 5 7. 5 7 n m / 1 3 0. 2 6 n m / 1 3 7. 4 5 n m / 1 1 3. 6 3 n m である。全体の膜厚(d t o t a 1 = Σ d i)は 7 8 9. 6 1 n m である。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d i との積 n_i d i の総和 Σ n_i d i は、 1 4 6 5. 8 2 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 5. 9 8 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0146]

図56は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長872 nmから1088 nmにわたって反射率は5.9%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1073 nmの設定反射率7.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は196 nmである。この波長帯域幅を設定波長1073 nmで割った値は約0.183であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0147]

実施の形態47.

 C d 1 / C d 2 = 8.69 nm / 120.54 nm / 100.75 nm / 143. 79 nm / 120.19 nm / 122.38 nm / 102.29 nmである。全体の膜厚($d_{total} = \Sigma d_i$)は718.63 nmである。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σn_i d_i は、1333.17 nmであり、所定波長 980 nmの1 / 4 波長(<math>=245 nm)の約5.44倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0148]

図57は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長786nmから994nmにわたって反射率は7.0%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率8.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は208nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.212であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0 1 4 9]

実施の形態48.

本発明の実施の形態 48 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 58 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 47 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1079$ n mで設定反射率 $R(\lambda)$ を 8.0% としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.806965、 ϕ 2 = 0.531203とすることによって波長 1079 n mで反射率 8.0% とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は 0 d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 9.57 n m / 132.72 n m / 110.93 n m / 158.32 n m / 132.33 n m / 134.74 n m / 112.62 n m である。全体の

膜厚($d_{total}=\Sigma d_i$)は791.23 nmである。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i は、1467.86 nmであり、所定波長 980 nmの 1/4 波長(=245 nm)の約5.99 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0150]

図58は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長866nmから1094nmにわたって反射率は7.0%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1079nmの設定反射率8.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は228nmである。この波長帯域幅を設定波長1079nmで割った値は約0.211であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたって平坦部を有していることがわかる。

[0151]

実施の形態49.

 の膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i は、1330.6 5 n m であり、所定波長 980 n m の 1/4 波長(=245 n m)の約5.43 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0152]

図59は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長793nmから994nmにわたって反射率は8.1%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率8.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続した波長帯域幅は202nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.206であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0153]

実施の形態50.

本発明の実施の形態 50 に係る 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 60 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 49 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1075$ n mで設定反射率 $R(\lambda)$ を 9.0% としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ $1=0.734549、<math>\phi$ 2=0.580342 とすることによって波長 1075 n mで反射率 9.0% とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は 0 d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2=12.26 n m / 125.25 n m / 125.65 n m / 146.63 n m / 147.10 n m / 119.14 n m / 119.52 n m である。全体の膜厚(100 c 100 c

に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0154]

図60は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長870nmから1090nmにわたって反射率は8.1%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1075nmの設定反射率9.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続した波長帯域幅は220nmである。この波長帯域幅を設定波長1075nmで割った値は約0.205であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたって平坦部を有していることがわかる。

[0155]

実施の形態51.

昇を抑制できる。

[0156]

図61は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の10%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長773nmから994nmにわたって反射率は9.0%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率10.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は221nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.226であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0157]

実施の形態52.

[0158]

図62は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の10%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長857nmから1102nmにわたって反射率は9.0%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1087nmの設定反射率10.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は245nmである。この波長帯域幅を設定波長1087nmで割った値は約0.225であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0159]

実施の形態53.

[0160]

図63は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフ

の横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の11%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長764nmから994nmにわたって反射率は10.2%から12.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率11.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は230nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.235であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0161]

実施の形態54.

[0162]

図64は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の11%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長851

nmから1108nmにわたって反射率は10.2%から12.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1092nmの設定反射率11.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は257nmである。この波長帯域幅を設定波長1092nmで割った値は約0.235であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0163]

実施の形態55.

[0164]

図65は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長751nmから995nmにわたって反射率は10.9%から13.0%の範囲内に収

まっている。また、設定波長 980 n mの反射率 12.0%を基準として、-1. 5%から +1.0%の範囲、即ち、反射率 10.5% ~ 13.0 %の範囲の連続した波長帯域幅は 244 n mである。この波長帯域幅を設定波長 980 n mで割った値は約 0.249であり、仮想単層反射膜の場合の 0.065より大きい。そこで、この 7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0165]

実施の形態56.

$[0\ 1\ 6\ 6\]$

図66は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長842nmから1117nmにわたって反射率は10.9%から13.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1100nmの設定反射率12.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率10.5%~13.0%の

範囲の連続した波長帯域幅は275 n mである。この波長帯域幅を設定波長1100 n mで割った値は約0.250であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0167]

[0168]

【表6】

表 6

	多層反射膜の特性							
実	多層反射	設定波長 λ	極小反	Σ n i d i ,	R (λ) Ø	Δλ/λ		
施	膜の構成	設定反射率	射率	波長 980nm の	-1.5~1.0%			
の		R (λ)	u.	1/4 波 長	となる波長			
形				(245nm) との	帯域Δλ			
態				対比				
43	7層膜	980nm	5.0%	1350.16nm	181nm	181/980=		
		6 %		5.51 倍		0.185		
44	7層膜	1063nm	5.0%	1457.82nm	196nm	196/1063=		
		6%		5.95 倍		0.184		
45	7層膜	980nm	5.9%	1338.78nm	196nm	196/980=		
		7 %		5.46 倍		0.200		
46	7層膜	1073nm	5.9%	1465.82nm	196nm	196/1073=		
		7 %		5.98 倍		0.183		
47	7層膜	980nm	7.0%	1333.17nm	208nm	208/980=		
		8 %		5.44 倍		0.212		
48	7層膜	1079nm	7.0%	1467.86nm	228nm	228/1079=		
		8%		5.99 倍		0.211		
49	7層膜	980nm	8.1%	1330.65nm	202nm	202/980=		
		9 %		5.43 倍		0.206		
50	7層膜	1075nm	8.1%	1459.67nm	220nm	220/1075=		
		9 %		5.96 倍		0.205		
51	7 層膜	980nm	9.0%	1326.67nm	$221\mathrm{nm}$	221/980=		
		10%		5.41 倍		0.226		
52	7層膜	1087nm	9.0%	1471.49nm	245nm	245/1087=		
		10%		6.01 倍		0.225		
53	7層膜	980nm	10.2%	1320.69nm	230nm	230/980=		
<u></u>		1 1 %		5.39 倍		0.235		
54	7層膜	1092nm	10.2%	1471.66nm	257nm	257/1092=		
		1 1 %		6.01 倍		0.235		
55	7 層膜	980nm	10.9%	1314.76nm	244nm	244/980=		
		1 2 %		5.37 倍		0.249		
56	7 層膜	1100nm	10.9%	1475.74nm	275nm	275/1100=		
		12%		6.02 倍		0.250		

[0169]

実施の形態57.

本発明の実施の形態57に係る6層反射膜を備えた半導体光素子について、図67を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態17に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 980 n mで設定反射率 R (λ) を 6.0%とし

ており、パラメータはA=1.50、B=1.92, C=2.2としている点で相違する。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=1.16473、 ϕ 2=0.715823とすることによって波長980nmで反射率6.0%とすることができる。この場合、6層反射膜のそれぞれの膜厚はAd1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=132.47 nm/103.38nm/169.57nm/132.32nm/194.30 nm/151.62nmである。全体の膜厚($d_{total}=\Sigma d_{i}$)は883.66nmである。それぞれの膜の屈折率 n_{i} と膜厚 d_{i} との積 n_{i} d_{i} の総和 Σn_{i} d_{i} d_{i}

[0170]

図67は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長966nmから1219nmにわたって反射率は5.0%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率6.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は253nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.258であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0171]

実施の形態58.

って波長879nmで反射率6.0%とすることができる。この場合、6層反射膜のそれぞれの膜厚はAd1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=118.82nm/92.72nm/152.09nm/118.69nm/174.27nm/136.00nmである。全体の膜厚(dtotal= Σ di)は792.59nmである。それぞれの膜の屈折率niと膜厚diとの積nidiの総和 Σ nidiは、1478.54nmであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約6.03倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0172]

図68は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長866nmから1093nmにわたって反射率は5.0%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長879nmの設定反射率6.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は227nmである。この波長帯域幅を設定波長879nmで割った値は約0.258であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0173]

実施の形態59.

8. $7.3 \, \text{nm}/107$. $45 \, \text{nm}/167$. $35 \, \text{nm}/139$. $69 \, \text{nm}/18$ 8. $80 \, \text{nm}/157$. $59 \, \text{nm}$ である。全体の膜厚($d_{total}=\Sigma d_i$)は889. $61 \, \text{nm}$ である。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σn_i d_i は、1653. $06 \, \text{nm}$ であり、所定波長 $980 \, \text{nm}$ の1/4波長($=245 \, \text{nm}$)の約6. $75 \, \text{倍と非常に厚い}$ 。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0174]

図69は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長964nmから1219nmにわたって反射率は6.4%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率7.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は255nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.260であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0175]

実施の形態60.

本発明の実施の形態 6 0 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図7 0 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 5 9 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=880$ n mで設定反射率 R(λ)を 7.0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 1.1 3 1 8 1、 ϕ 2 = 0.7 4 4 0 1 8 とすることによって波長 8 8 0 n mで反射率 7.0%とすることができる。この場合、6 層反射膜のそれぞれの膜厚は A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 1 1 5.5 9 n m / 9 6.4 9 n m / 1 5 0.2 7 n m / 1 2 5.4 3 n m / 1 6 9.5 4 n m / 1 4 1.5 1 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 7 9 8.8 3 n m である。それぞれの膜の屈折率 n j と膜厚 d j との積 n j d j

の総和 Σ n_id_iは、1484.37nmであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約6.06倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0176]

図70は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長866nmから1094nmにわたって反射率は6.4%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長880nmの設定反射率7.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は228nmである。この波長帯域幅を設定波長880nmで割った値は約0.259であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0177]

実施の形態61.

本発明の実施の形態 6 1 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 7 1 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 7 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=9$ 8 0 n mで設定反射率R(λ)を8.0%としている点で相違する。また、パラメータはA=1.52、B=1.95,C=2.20としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 1.09941、 ϕ 2 = 0.769346とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率8.0%とすることができる。この場合、6 層反射膜のそれぞれの膜厚はAd1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=126.71 n m/112.59 n m/162.56 n m/144.44 n m/183.40 n m/162.96 n mである。全体の膜厚(d to tal= Σ di)は892.66 n mである。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i

放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0178]

図71は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長964nmから1223nmにわたって反射率は7.4%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率8.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は259nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.264であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0179]

実施の形態62.

[0180]

図72は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフ

の横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長864nmから1096nmにわたって反射率は7.4%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長878nmの設定反射率8.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は232nmである。この波長帯域幅を設定波長878nmで割った値は約0.264であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0181]

実施の形態63.

[0182]

図73は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長963n

mから1235nmにわたって反射率は8.4%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率9.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続した波長帯域幅は272nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.278であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0183]

実施の形態64.

[0184]

図74は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長859nmから1101nmにわたって反射率は8.4%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長874nmの設定反射率9.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続

した波長帯域幅は242nmである。この波長帯域幅を設定波長874nmで割った値は約0.244であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0185]

実施の形態65.

[0186]

図75は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の10%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長963nmから1233nmにわたって反射率は9.5%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率8.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は270nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.276であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そ

こで、この6層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0187]

実施の形態66.

[0188]

図76は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の10%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長859nmから1100nmにわたって反射率は9.5%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長874nmの設定反射率10.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は241nmである。この波長帯域幅を設定波長874nmで割った値は約0.276であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0189]

実施の形態67.

本発明の実施の形態 6 7 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 7 7 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 7 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=9$ 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 1 1. 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1. 6 5、B = 2. 0 5,C = 2. 2 0 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 9 3 1 1 2 1、 ϕ 2 = 0. 8 6 2 3 9 7 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 1 1. 0%とすることができる。この場合、6 層反射膜のそれぞれの膜厚は A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 1 1 6. 4 9 n m / 1 3 7. 0 0 n m / 1 4 4 . 7 3 n m / 1 7 0. 2 1 n m / 1 5 5. 3 3 n m / 1 8 2. 6 7 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 9 0 6. 4 3 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、 1 6 5 0. 4 5 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6. 7 4 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0190]

図77は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の11%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長963nmから1233nmにわたって反射率は10.4%から12.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率11.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は270nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.276であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0191]

実施の形態68.

本発明の実施の形態68に係る6層反射膜を備えた半導体光素子について、図

78を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 67に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=875$ n m で設定反射率 $R(\lambda)$ を 11 . 0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0 . 9 3 1 1 2 1 、 ϕ 2 = 0 . 8 6 2 3 9 7 とすることによって波長 875 n m で反射率 11 . 0%とすることができる。この場合、6層反射膜のそれぞれの膜厚は A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 104 . 01 n m / 122 . 32 n m / 129 . 23 n m / 151 . 98 n m / 138 . 68 n m / 163 . 10 n m である。全体の膜厚(d t o t a

[0192]

図78は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の11%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長859nmから1100nmにわたって反射率は10.4%から12.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長875nmの設定反射率11.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は241nmである。この波長帯域幅を設定波長875nmで割った値は約0.275であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0193]

実施の形態69.

本発明の実施の形態 6 9 に係る 6 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 7 9 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 7 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 1 2. 0% としている点で相違する。また、パラメータは A = 1. 7 0、 B = 2. 0 7, C =

[0194]

図79は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長961nmから1240nmにわたって反射率は11.5%から13.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率12.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率10.5%~13.0%の範囲の連続した波長帯域幅は279nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.285であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0195]

実施の形態70.

層反射膜のそれぞれの膜厚はAd1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2 = 97.99 nm/136.45 nm/119.32 nm/166.14 nm/123.93 nm/172.56 nmである。全体の膜厚($d_{total} = \Sigma d_{i}$)は816.56 nmである。それぞれの膜の屈折率 n_{i} と膜厚 d_{i} との積 n_{i} d_{i} の総和 Σn_{i} d_{i} d_{i} d

[0196]

図80は、この6層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この6層反射膜は、設定反射率の12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長856nmから1103nmにわたって反射率は11.5%から13.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長873nmの設定反射率12.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率10.5%~13.0%の範囲の連続した波長帯域幅は247nmである。この波長帯域幅を設定波長873nmで割った値は約0.283であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この6層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0197]

以下に、実施の形態 57 から実施の形態 70 に係る半導体光素子の多層反射膜の特性について、表 7 に示した。表 7 には、多層反射膜の特性として、多層反射膜の構成、設定波長 λ 及び設定反射率 $R(\lambda)$ 、極小反射率、 Σ n i d i 及び所定波長 980 n mの 1/4 波長(245 n m)との対比、 $R(\lambda)$ の-1.5 ~ +1.0%の範囲となる波長帯域幅 Δ λ 、 Δ λ/λ について示した。

[0198]

【表7】

表 7

	多層反射膜の特性								
実	多層反射	設定波長λ	極小反	Σ n _i d _i ,	R (λ) の	Δλ/λ			
施	膜の構成	設定反射率	射率	波長 980nmの	-1.5~1.0%				
Ø		R (λ)		1/4 波 長	となる波長				
形				(245nm) との	帯域Δλ				
態				対比					
57	6 層膜	980nm	5.0%	1648.43nm	253nm	253/980=			
		6 %	ļ	6.73 倍		0.258			
58	6 層膜	879nm	5.0%	1478.54nm	227nm	227/879=			
		6 %		6.03 倍		0.258			
59	6 層膜	980nm	6.4%	1653.06nm	255nm	255/980=			
		7 %		6.75 倍		0.260			
60	6 層膜	880nm	6.4%	1484.37nm	228nm	228/880=			
		7 %		6.06 倍		0.259			
61	6層膜	980nm	7.4%	1652.67nm	259nm	259/980=			
		8 %	=	6.75 倍		0.264			
62	6層膜	878nm	7.4%	1480.65nm	232nm	232/878=			
		8 %		6.04 倍		0.264			
63	6層膜	980nm	8.4%	1656.11nm	272nm	272/980=			
		9 %		6.76 倍		0.278			
64	6層膜	874nm	8.4%	1476.95nm	242nm	242/874=			
		9 %		6.03 倍		0.244			
65	6 層膜	980nm	9.5%	1653.97nm	270nm	270/980=			
		10%		6.75 倍		0.276			
66	6 層膜	874nm	9.5%	1475.04nm	241nm	241/874=			
		10%		6.02 倍		0.276			
67	6 層膜	980nm	10.4%	1650.45nm	270nm	270/980=			
		11%		6.74 倍		0.276			
68	6 層膜	875nm	10.4%	1473.63nm	241nm	241/875=			
		11%		6.01 倍		0.275			
69	6 層膜	980nm	11.5%	1652.07nm	279nm	279/980=			
		12%		6.74 倍		0.285			
70	6 層膜	873nm	11.5%	1471.67nm	247nm	247/873=			
		12%		6.01 倍		0.283			

[0199]

実施の形態71.

本発明の実施の形態71に係る3種類の膜を含む7層反射膜を備えた半導体光素子について、図81を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態25 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 980 n m で設定反射率R (λ)を6.0%としている点で相違する。また、パラメータはA=1.05、B=2.00, C=2.00としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=1.09082、 ϕ 2=0.85958とすることによって波長980nmで反射率6.0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚はd3/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=50nm/86.85nm/86.90nm/165.42nm/165.52nm/165.42nm/165.52nm/165.42nm/165.52nm/165.42nm/165.52nmである。全体の膜厚(dtotal= Σ di)は885.63nmである。それぞれの膜の屈折率niと膜厚diとの積nidiの総和 Σ nidiは、1639.85nmであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約6.69倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる

[0200]

図81は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長965 nmから1186 nmにわたって反射率は5.4%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980 nmの反射率6.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は221 nmである。この波長帯域幅を設定波長980 nmで割った値は約0.226であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0201]

実施の形態72.

本発明の実施の形態72に係る3種類の膜を含む7層反射膜を備えた半導体光素子について、図82を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態71に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 889 n m で設定反射率R (λ) を6.0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれ

ぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 1. 0 5 8 8 1、 ϕ 2 = 0. 8 6 6 4 3 6 とすることによって波長 8 8 9 n mで反射率 6. 0% とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 7 6. 4 7 n m / 7 9. 4 6 n m / 1 4 5. 6 6 n m / 1 5 1. 3 5 n m / 1 4 5. 6 6 n m / 1 5 1. 3 5 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 7 9 9. 9 5 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、 1 4 7 9. 2 4 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6. 0 4 倍 と 非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0202]

図82は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長877nmから1081nmにわたって反射率は5.2%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長889nmの設定反射率6.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は204nmである。この波長帯域幅を設定波長889nmで割った値は約0.229であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0203]

実施の形態73.

本発明の実施の形態 7 3 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 8 3 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 2 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 7. 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1. 1 0、B = 2. 0 5, C = 2. 0 0 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 1. 0 1 2 0 8、 ϕ 2 = 0. 8 9 6 8 6

7とすることによって波長980nmで反射率7.0%とすることができる。この場合、7層反射膜のそれぞれの膜厚はd3/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2=50nm/84.41nm/94.98nm/157.32nm/177.02nm/143.48nm/172.70nmである。全体の膜厚(dtotal= Σ di)は879.91nmである。それぞれの膜の屈折率niと膜厚diとの積nidiの総和 Σ nidiは、1636.96nmであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約6.68倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0204]

図83は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長965 nmから1194 nmにわたって反射率は6.4%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980 nmの反射率7.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は229 nmである。この波長帯域幅を設定波長980 nmで割った値は約0.234であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0205]

実施の形態74.

本発明の実施の形態 7 4 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 8 4 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 7 3 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=8$ 8 6 n mで設定反射率 R (λ) を 7. 0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 9 7 9 7 4、 ϕ 2 = 0. 9 0 4 3 1 9 とすることによって波長 8 8 6 n mで反射率 7. 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2

/C d 1/C d 2=50 n m/73. 88 n m/86. 59 n m/137. 68 n m/161. 37 n m/134. 33 n m/157. 43 n m である。全体の膜厚(d t o t a $1=\Sigma$ d i)は801. 28 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、1471. 83 n m であり、所定波長 980 n m の 1/4 波長(=245 n m)の約6. 01 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0206]

図84は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長874nmから1085nmにわたって反射率は6.0%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長886nmの設定反射率7.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は211nmである。この波長帯域幅を設定波長886nmで割った値は約0.238であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0207]

実施の形態75.

本発明の実施の形態 7 5 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 8 5 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 2 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=9$ 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 8. 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1. 1 0、B = 2. 05, C = 2. 00としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 9 9 1 7 7 5、 ϕ 2 = 0. 9 2 3 7 3 6 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 8. 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 8 2. 7 2 n m / 9 7. 8 3 n m / 1 5 4. 1

 $6\,n\,m/1\,8\,2$. $3\,2\,n\,m/1\,5\,0$. $4\,0\,n\,m/1\,7\,7$. $8\,7\,n\,m$ である。全体の膜厚($d_{t\,0\,t\,a\,l}=\Sigma\,d_i$)は $8\,9\,5$. $3\,n\,m$ である。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 $\Sigma\,n_i$ d_i は、 $1\,6\,4\,2$. $2\,3\,n\,m$ であり、所定波長 $9\,8\,0\,n\,m$ の 1/4 波長($=2\,4\,5\,n\,m$)の約 6. $7\,0$ 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0208]

図85は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長964nmから1204nmにわたって反射率は7.5%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率8.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は240nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.245であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0209]

実施の形態76.

本発明の実施の形態 7 6 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 8 6 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 7 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=8$ 8 1 n m で設定反射率 R (λ) を 8. 0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 9 5 8 9 9 2、 ϕ 2 = 0. 9 3 0 3 0 6 とすることによって波長 8 8 1 n m で反射率 8. 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 7 1. 9 1 n m / 8 8. 5 7 n m / 1 3 4. 0 1 n m / 1 6 5. 0 7 n m / 1 3 0. 7 4 n m / 1 6 1. 0 4 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i) は 8 0 1. 3 4 n m である。それぞれの膜の屈

折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i は、1 4 6 7. 8 9 n mであり、所定波長 9 8 0 n mの 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 5. 9 9 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0210]

図86は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長869nmから1090nmにわたって反射率は7.1%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長881nmの設定反射率8.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は221nmである。この波長帯域幅を設定波長881nmで割った値は約0.251であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0211]

実施の形態77.

あり、所定波長 980 n mの 1/4 波長(=245 n m)の約6. 71 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0212]

図87は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長965 nmから1220 nmにわたって反射率は8.4%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980 nmの反射率9.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続した波長帯域幅は255 nmである。この波長帯域幅を設定波長980 nmで割った値は約0.260であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0213]

実施の形態78.

本発明の実施の形態 7 8 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 8 8 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 7 7 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=8$ 7 4 n mで設定反射率 R (λ) を 9.0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.9 0 0 3 3 7、 ϕ 2 = 0.9 3 5 2 2 2 とすることによって波長 8 7 4 n mで反射率 9.0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 7 0.0 2 n m / 9 2.3 5 n m / 1 2 7.8 6 n m / 1 6 8.6 4 n m / 1 2 4.8 1 n m / 1 6 4.6 2 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 7 9 8.3 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、1 4 5 6.8 6 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 5.9 5 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制でき

る。

[0214]

図88は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長863nmから1096nmにわたって反射率は7.9%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長874nmの設定反射率9.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続した波長帯域幅は233nmである。この波長帯域幅を設定波長874nmで割った値は約0.267であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0215]

実施の形態79.

本発明の実施の形態 7 9 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 8 9 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 2 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 1 0 . 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1 . 1 5 、 B = 2 . 1 0 , C = 2 . 0 5 としている。 さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0 . 9 1 4 1 4 8 、 ϕ 2 = 0 . 9 5 5 3 5 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 1 0 . 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 7 9 . 7 1 n m / 1 0 5 . 7 8 n m / 1 4 5 . 5 6 n m / 1 9 3 . 1 6 n m / 1 4 2 . 1 0 n m / 1 8 8 . 5 6 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 9 0 4 . 8 7 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、 1 6 4 9 . 0 3 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6 . 7 3 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0216]

図89は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の10%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長963nmから1235nmにわたって反射率は9.6%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率10.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は272nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.278であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0217]

実施の形態80.

本発明の実施の形態 80 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 90 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 79 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=868$ n m で設定反射率 R (λ)を 10.0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ $1=0.879123、<math>\phi$ 2=0.96166 とすることによって波長 868 n m で反射率 10.0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は 100%とすることができる。この場合、10 不層反射膜のそれぞれの膜厚は 100%とすることができる。この場合、100%とすることができる。この場合、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%により、100%に関係できる。

[0218]

. 図90は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフ

の横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長856 nmから1102 nmにわたって反射率は8.7%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長868 nmの設定反射率10.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は246 nmである。この波長帯域幅を設定波長868 nmで割った値は約0.283であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0219]

実施の形態81.

本発明の実施の形態 8 1 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図9 1 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 2 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 1 1. 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1. 1 7、B = 2. 1 0, C = 2. 0 5 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 8 8 1 4 4 4、 ϕ 2 = 0. 9 8 3 9 5 7 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 1 1. 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 7 8. 2 0 n m / 1 1 0. 8 4 n m / 1 4 0. 3 5 n m / 1 9 8. 9 4 n m / 1 3 7. 0 1 n m / 1 9 4. 2 1 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 9 0 9. 5 5 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、 1 6 5 1. 4 5 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6. 7 4 倍 と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0220]

図91は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の1

1%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長963 nmから1254 nmにわたって反射率は10.4%から12.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980 nmの反射率11.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は291 nmである。この波長帯域幅を設定波長980 nmで割った値は約0.297であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0221]

実施の形態82.

本発明の実施の形態 8 2 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 9 2 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 9 1 に係る半導体光素子と比較すると、パラメータ A = 1.15、B = 2.10、C = 2.05とし、設定波長 λ = 8 6 2 n mで設定反射率 R(λ)を 1 1.0%としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.8 5 6 7 3 8、 ϕ 2 = 0.9 8 9 6 2 3 とすることによって波長 8 6 2 n mで反射率 1 1.0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 6 5.7 1 n m / 9 6.3 8 n m / 1 1 9.9 9 n m / 1 7 6.00 n m / 1 1 7.1 4 n m / 1 7 1.8 1 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d $_i$)は 7 9 7.0 3 n m である。それぞれの膜の屈折率 n $_i$ と膜厚 d $_i$ との積 n $_i$ d $_i$ の総和 Σ n $_i$ d $_i$ は、 1 4 4 6.1 3 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 5.9 0 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0222]

図92は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の11%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長850nmから1110nmにわたって反射率は9.5から12.0%の範囲内に収ま

っている。また、設定波長862 n m の設定反射率11.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は260 n m である。この波長帯域幅を設定波長862 n m で割った値は約0.302 であり、仮想単層反射膜の場合の0.065 より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0223]

実施の形態83.

本発明の実施の形態 8 3 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図9 3 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 2 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 1 2 . 0%としている点で相違する。また、パラメータは A = 1 . 2 2 、 B = 2 . 1 3 , C = 2 . 0 5 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0 . 8 1 5 0 0 5 、 ϕ 2 = 1 . 0 2 5 1 8 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 1 2 . 0%とすることができる。この場合、7 層反射膜のそれぞれの膜厚は d 3 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 = 5 0 n m / 7 5 . 3 9 n m / 1 2 0 . 4 2 n m / 1 3 1 . 6 3 n m / 2 1 0 . 2 4 n m / 1 2 6 . 6 9 n m / 2 0 2 . 3 4 n m である。全体の膜厚(d t o t a l = Σ d i)は 9 1 6 . 7 1 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、 1 6 5 3 . 5 0 n m であり、所定波長 9 8 0 n m の 1 / 4 波長(= 2 4 5 n m)の約 6 . 7 5 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0224]

図93は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長962nmから1275nmにわたって反射率は10.7%から13.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率12.0%を基準として、一

1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率10.5%~13.0%の範囲の連続した波長帯域幅は313nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.319であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0225]

実施の形態84.

本発明の実施の形態 8 4 に係る 3 種類の膜を含む 7 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 9 4 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 8 3 に係る半導体光素子と比較すると、パラメータは A=1. 1 3、B=2. 1 0、C=2. 0 5 とし、設定波長 $\lambda=8$ 5 3 n mで設定反射率 R (λ) を 1 2. 0 % としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 8 4 2 4 6 5、 ϕ 2 = 1. 0 2 0 3 8 とすることによって波長 8 5 3 n mで反射率 1 2. 0 %とすることができる。この場合、 7 層反射膜のそれぞれの膜厚は 1 3 1 4 1 4 1 6 1 7 1 8 1 8 1 9 1 8 1 9 1 8 1 9 1 8 1 9 1 9 1 9 1 5 1 7 1 1 3 1 9 1 8 1 9 1 9 1 7 1 1 3 1 9 1 8 1 9 1 9 1 7 1 1 3 1 9 1 8 1 9 1 9 1 7 1 9 1 5 7 1 9 1 7 1 9 1 7 9 1 9 1 7 1 9

[0226]

図94は、この7層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この7層反射膜は、設定反射率の12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長838nmから1116nmにわたって反射率は10.6%から13.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長853nmの設定反射率12.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率10.5%~13.0%の範囲の連続した波長帯域幅は278nmである。この波長帯域幅を設定波長853

nmで割った値は約0.326であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この7層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0227]

以下に、実施の形態 7 1 から実施の形態 8 4 に係る半導体光素子の多層反射膜の特性について、表 8 に示した。表 8 には、多層反射膜の特性として、多層反射膜の構成、設定波長 λ 及び設定反射率 R (λ)、極小反射率、 Σ n i d i 及び所定波長 9 8 0 n mの 1 / 4 波長 (2 4 5 n m) との対比、R (λ)の-1.5~+1.0%の範囲となる波長帯域幅 Δ λ 、 Δ λ / λ について示した。

[0228]

【表8】

表8

	多層反射膜の特性							
実	多層反射	設定波長λ	極小反	$\sum n_i d_i$	R (λ) Ø	Δλ/λ		
施	膜の構成	設定反射率	射率	波長 980nmの	-1.5~1.0%			
の		R (λ)		1/4 波 長	となる波長			
形		·		(245nm) との	帯域Δλ			
態				対比				
71	7層膜	980nm	5.4%	1639.85nm	221nm	221/980=		
	(3種類)	6 %		6.69 倍		0.226		
72	7層膜	889nm	5.2%	1479.24nm	204nm	204/889=		
	(3種類)	6 %		6.04 倍		0.229		
73	7層膜	980nm	6.4%	1636.96nm	229nm	229/980=		
	(3種類)	7 %		6.68 倍		0.234		
74	7層膜	886nm	6.0%	1471.83nm	211nm	211/886=		
	(3種類)	7 %		6.01 倍		0.238		
75	7層膜	980nm	7.5%	1642.23nm	240nm	240/980=		
	(3種類)	8 %		6.70 倍		0.245		
76	7層膜	881nm	7.1%	1467.89nm	221nm	221/881=		
	(3種類)	8 %		5.99 倍		0.251		
77	7層膜	980nm	8.4%	1643.29nm	255nm	255/980=		
	(3種類)	9 %		6.71 倍		0.260		
78	7層膜	874nm	7.9%	1456.86nm	233nm	233/874=		
	(3種類)	9 %		5.95 倍		0.267		
79	7層膜	980nm	9.6%	1649.03nm	272nm	272/980=		
	(3種類)	10%		6.73 倍		0.278		
80	7層膜	868nm	8.7%	1451.38nm	246nm	246/868=		
	(3種類)	10%		5.92 倍		0.283		
81	7層膜	980nm	10.4%	1651.45nm	291nm	291/980=		
	(3種類)	11%		6.74 倍		0.297		
82	7層膜	862nm	9.5%	1446.13nm	260nm	260/862=		
	(3種類)	1 1 %		5.90 倍		0.320		
83	7層膜	980nm	10.7%	1653.50nm	313nm	313/980=		
	(3種類)	1 2 %		6.75 倍		0.319		
84	7層膜	853nm	10.6%	1438.90nm	278nm	278/853=		
	(3種類)	1 2 %		5.87 倍		0.326		

[0229]

実施の形態85.

本発明の実施の形態 8 5 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 9 5 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 3 3 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 6.0%とし

ている点で相違する。また、パラメータはO=0. 10、A=2. 7、B=2. 1, C=2. 0、D=2. 0 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=0. 429458、 ϕ 2=0. 889116とすることによって波長980nmで反射率6. 0%とすることができる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚はOd2/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2/Dd1/Dd2=8. 56nm/87. 92nm/231. 13nm/68. 38nm/179. 77nm/65. 13nm/171. 21nmである。全体の膜厚(dt0tal= Σ di)は1048. 44nmである。それぞれの膜の屈折率niと膜厚diとの積nidiの総和 Σ nidiは、1823. 70nmであり、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約7. 44倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0230]

図95は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長893nmから993nmにわたって反射率は5.1%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率6.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は100nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.102であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0231]

実施の形態86.

本発明の実施の形態 8 6 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 9 6 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 8 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda = 1$ 0 1 8 n mで設定反射率 R (λ) を 6. 0 % としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化

 ϕ 1及び ϕ 2を、 ϕ 1=0.429458、 ϕ 2=0.889116とすることによって波長1018nmで反射率6.0%とすることができる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚はOd2/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2/Dd1/Dd2=8.89nm/91.33nm/240.09nm/71.04nm/186.74nm/67.65nm/177.85nm/67.65n

[0232]

図96は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の6%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長928nmから1031nmにわたって反射率は5.1%から7.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1018nmの設定反射率6.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率4.5%~7.0%の範囲の連続した波長帯域幅は103nmである。この波長帯域幅を設定波長1018nmで割った値は約0.101であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0233]

実施の形態87.

本発明の実施の形態 8 7 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 9 7 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 3 3 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 λ = 9 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 7. 0%としている点で相違する。また、パラメータは O = 0. 1 0、A = 2. 7、B = 2. 15, C = 1. 9、D = 1. 9としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 4 1 3 8 3 1、 ϕ 2 = 0. 9

1752とすることによって波長 980 n mで反射率 7.0%とすることができる。この場合、 9層反射膜のそれぞれの膜厚は O d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 / D d 1 / D d 2 = 8.83 n m / 84.72 n m / 238.51 n m / 65.90 n m / 185.51 n m / 59.62 n m / 167.84 n m である。全体の膜厚(d t o t a 1 = Σ d i) は 1038.39 n m である。それぞれの膜の屈折率 n i と膜厚 d i との積 n i d i の総和 Σ n i d i は、 1800.12 n m であり、所定波長 980 n m の 1 / 4 波長(= 245 n m)の約 7.35 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0234]

図97は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長898nmから993nmにわたって反射率は6.3%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率7.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は95nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.097であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる

[0235]

実施の形態88.

本発明の実施の形態 8 8 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 9 8 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 8 7 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1$ 0 1 6 n mで設定反射率 R (λ) を 7. 0% としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 4 1 3 8 3 1、 ϕ 2 = 0. 9 1 7 5 2 とすることによって波長 1 0 1 6 n mで反射率 7. 0% とすることができる。この場合、9 層反射膜のそれぞれの膜厚は O d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 /

 $C d 2/D d 1/D d 2 = 9. 16 n m/87. 83 n m/247. 27 n m/68. 32 n m/192. 32 n m/61. 81 n m/174. 01 n m/61. 81 n m/174. 01 n m/61. 81 n m/174. 01 n m である。全体の膜厚(<math>d_{total} = \Sigma d_i$)は 1076.54 n m である。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σn_i d_i は、1866. 25 n m であり、所定波長 980 n m の 1/4 波長(=245 n m)の約7. 62 倍と非常に厚い。このため、端面における 放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0236]

図98は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の7%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長931nmから1029nmにわたって反射率は6.3%から8.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1016nmの設定反射率7.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率5.5%~8.0%の範囲の連続した波長帯域幅は98nmである。この波長帯域幅を設定波長1016nmで割った値は約0.096であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0237]

実施の形態89.

本発明の実施の形態 8 9 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 9 9 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 3 3 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=9$ 8 0 n mで設定反射率 R (λ) を 8. 0%としている点で相違する。また、パラメータは O=0. 1 0、A=2. 7 0、B=2. 1 0, C=2. 0 5、D=1. 8 0 としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0. 3 9 5 1 0 3、 ϕ 2 = 0. 9 3 3 5 9 3 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 8. 0%とすることができる。この場合、9 層反射膜のそれぞれの膜厚は Od 2 / Ad 1 / Ad 2 / Bd 1 / Bd 2 / Cd 1 / Cd 2 / Dd 1 / Dd 2 = 8. 9 9 n m / 8 0. 8

 $9\,n\,m/2\,4\,2$. $6\,9\,n\,m/6\,2$. $9\,1\,n\,m/1\,8\,8$. $7\,6\,n\,m/6\,1$. $4\,2\,n\,m/1\,8\,4$. $2\,7\,n\,m/5\,3$. $9\,3\,n\,m/1\,6\,1$. $7\,9\,n\,m$ である。全体の膜厚($d_{t\,o\,t\,a\,l}=\Sigma\,d_{i}$)は $1\,0\,4\,5$. $6\,5\,n\,m$ である。それぞれの膜の屈折率 n_{i} と膜厚 d_{i} との積 n_{i} d_{i} の総和 $\Sigma\,n_{i}$ d_{i} は、 $1\,8\,0\,7$. $2\,0\,n\,m$ であり、所定波長 $9\,8\,0\,n\,m$ の 1/4 波長($=2\,4\,5\,n\,m$)の約 7. $3\,8$ 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる

[0238]

図99は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長886 nmから991 nmにわたって反射率は7.0%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980 nmの反射率8.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は105 nmである。この波長帯域幅を設定波長980 nmで割った値は約0.107であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0239]

実施の形態90.

本発明の実施の形態 9 0 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 100を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 8 9 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1023$ n mで設定反射率 R (λ) を 8 . 0% としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0 . 3 9 5 1 0 3、 ϕ 2 = 0 . 9 3 3 5 9 3 とすることによって波長 1023 n mで反射率 8 . 0% とすることができる。この場合、9 層反射膜のそれぞれの膜厚は 0 d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 / D d 1 / D d 2 = 9 . 3 8 n m / 8 4 . 4 4 n m / 2 5 3 . 3 4 n m / 6 5 . 6 7 n m / 1 9 7 . 0 4 n m / 6 4 . 1 1 n m / 1 9 2 . 3 5 n m /

 $56.29\,\mathrm{nm}/168.89\,\mathrm{nm}$ である。全体の膜厚($d_{total}=\Sigma d_i$)は $1091.51\,\mathrm{nm}$ である。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σn_i d_i は、 $1886.46\,\mathrm{nm}$ であり、所定波長 $980\,\mathrm{nm}$ の 1/4 波長($=245\,\mathrm{nm}$)の約7.70倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0240]

図100は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の8%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長925 nmから1034nmにわたって反射率は7.0%から9.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1023nmの設定反射率8.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率6.5%~9.0%の範囲の連続した波長帯域幅は109nmである。この波長帯域幅を設定波長1023nmで割った値は約0.107であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0241]

実施の形態91.

本発明の実施の形態 9 1 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 101を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 33 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=980$ n mで設定反射率 R (λ) を 9.0% としている点で相違する。また、パラメータは 0=0.10、A=2.70、B=2.10,C=2.15、D=1.75としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.3 9 2 6 4 6、 ϕ 2 = 0.9 3 0 7 4 1 とすることによって波長 9 8 0 n mで反射率 9.0% とすることができる。この場合、9 層反射膜のそれぞれの膜厚は 0 d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 / D d 1 / D d 2 = 8.96 n m / 8 0.39 n m / 2 4 1.95 n m / 6 2.52 n m / 18 8.16 n m / 6 4.01 n m / 19 2.66 n m / 5 2.10 n m / 15 6.82 n m である。全体の膜

厚($d_{total} = \Sigma d_i$)は1047.59 nmである。それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i は、1810.29 nmであり、所定波長 980 nmの 1/4 波長(=245 nm)の約7.39倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0242]

図101は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長872nmから990nmにわたって反射率は7.8%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率9.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続した波長帯域幅は118nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.120であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0243]

実施の形態92.

i d i の総和 $\Sigma n i d i は、1904.52 n m$ であり、所定波長980 n mの 1/4 波長 (=245 n m) の約7.77倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0244]

図102は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長918nmから1041nmにわたって反射率は7.8%から10.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1031nmの設定反射率9.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率7.5%~10.0%の範囲の連続した波長帯域幅は123nmである。この波長帯域幅を設定波長1031nmで割った値は約0.119であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0245]

実施の形態93.

本発明の実施の形態 9 3 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 103 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 33 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=980$ n mで設定反射率R(λ)を 10.0% としている点で相違する。また、パラメータは 0=0.10、A=2.75、B=2.10, C=2.25、D=1.75としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1=0.394052、 ϕ 2=0.907302とすることによって波長 980 n mで反射率 10.0%とすることができる。この場合、 9 層反射膜のそれぞれの膜厚は 0 d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 / D d 1 / D d 2=8.74 n m / 82 · 17 n m / 240 · 22 n m / 152 · 152 · 152 · 153

であり、所定波長 980 n m 01/4 波長 (=245 n m) の約 7.39 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0246]

図103は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の9%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長866nmから990nmにわたって反射率は8.7%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率10.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は124nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.127であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0247]

実施の形態94.

本発明の実施の形態 9 4 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 104 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 9 3 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1035$ n mで設定反射率 R (λ) を 10.0 %としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.3 9 4 0 5 2、 ϕ 2 = 0.9 0 7 3 0 2 とすることによって波長 1035 n mで反射率 10.0%とすることができる。この場合、9 層反射膜のそれぞれの膜厚は 0 d 2 / A d 1 / A d 2 / B d 1 / B d 2 / C d 1 / C d 2 / D d 1 / D d 2 = 9.2 3 n m / 8 6.7 8 n m / 2 5 3.7 1 n m / 6 6.2 7 n m / 1 9 3.7 4 n m / 7 1.0 0 n m / 2 0 7.5 8 n m / 5 5.2 2 n m / 1 6 1.4 5 n m / 5 5.2 2 n m / 1 6 1.4 5 n m / 6 6.2 / 7 n m / 6 6 / 8 n m / 6 6 / 8 n m / 5 5 / 2 2 n m / 1 6 1 / 4 5 n m / 6 6 / 7 8 n / 6 6 / 7 8 n / 6 7 8 n / 7 8 n / 6 8 n / 7 8 n / 7 8 n / 6 8 n / 7 8 n / 7 8 n / 8 n / 7 8 n / 9 8 n /

ページ: 118/

における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制できる。

[0248]

図104は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の10%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長914nmから1045nmにわたって反射率は8.7%から11.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1035nmの設定反射率10.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率8.5%~11.0%の範囲の連続した波長帯域幅は131nmである。この波長帯域幅を設定波長1035nmで割った値は約0.127であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0249]

実施の形態95.

本発明の実施の形態 9 5 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 105 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 1 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=980$ n mで設定反射率 $R(\lambda)$ を 11.0%としている点で相違する。また、パラメータは O=0.10、A=2.80、B=2.10, C=2.35、D=1.75としている。さらに、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1=0.395641、 ϕ 2=0.8841 4 とすることによって波長 980 n mで反射率 11.0%とすることができる。この場合、9 層反射膜のそれぞれの膜厚は Od2/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2/Dd1/Dd2=8.51 n m/84.00 n m/238.35 n m/63.00 n m/178.76 n m/70.50 n m/200.04 n m/52.50 n m/148.97 n mである。全体の膜厚($dt0tal=\Sigma di$)は 1044.63 n mである。それぞれの膜の屈折率 ni と 膜厚 di との積 ni di の総和 Σ ni di di に 1810.29 n mであり、所定波長 980 n mの 1/4 波長 (=245 n m)の約7.39 倍と非常に厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制でき

る。

[0250]

図105は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の11%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長856nmから990nmにわたって反射率は9.7%から12.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率11.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は134nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.137であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0251]

実施の形態96.

本発明の実施の形態 9 6 に係る 9 層反射膜を備えた半導体光素子について、図 106 を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態 9 5 に係る半導体光素子と比較すると、設定波長 $\lambda=1040$ n mで設定反射率 R (λ) を 11.0 %としている点で相違する。また、酸化タンタル及びアルミナのそれぞれの位相変化 ϕ 1 及び ϕ 2 を、 ϕ 1 = 0.3 9 5 6 4 1、 ϕ 2 = 0.8 8 4 1 4 とすることによって波長 1040 n mで反射率 11.0 %とすることができる。この場合、9 層反射膜のそれぞれの膜厚は 0d2/Ad1/Ad2/Bd1/Bd2/Cd1/Cd2/Dd1/Dd2=9.03 n m/8 9.14 n m/2 5 2.9 4 n m/6 6 .8 6 n m/18 9.7 1 n m/7 4 .8 1 n m/2 12 .2 9 n m/5 5 .7 1 n m/15 8 .0 9 n m である。全体の膜厚($d_{total}=\Sigma d_{i}$)は 1108.5 8 n m である。それぞれの膜の屈折率 n_{i} と膜厚 d_{i} との積 n_{i} d_{i} の総和 Σ n_{i} d_{i} $d_{$

[0252]

図106は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の11%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長909nmから1050nmにわたって反射率は9.7%から12.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1040nmの設定反射率11.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率9.5%~12.0%の範囲の連続した波長帯域幅は141nmである。この波長帯域幅を設定波長1040nmで割った値は約0.136であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0253]

実施の形態97.

本発明の実施の形態97に係る9層反射膜を備えた半導体光素子について、図 107を用いて説明する。この半導体光素子は、実施の形態1に係る半導体光素 子と比較すると、設定波長 $\lambda = 980$ nmで設定反射率R(λ)を12.0%と している点で相違する。また、パラメータはO=0.10、A=2.85、B= 2. 10, C=2. 42、D=1. 75としている。さらに、酸化タンタル及び アルミナのそれぞれの位相変化φ1及びφ2を、φ1=0.39697、φ2= 0. 864124とすることによって波長980nmで反射率12. 0%とする ことができる。この場合、9層反射膜のそれぞれの膜厚はОd2/Ad1/Ad 2/B d 1/B d 2/C d 1/C d 2/D d 1/D d 2 = 8. 3 2 n m/8 5.79 nm/237. 11 nm/63. 21 nm/174. 71 nm/72. 84 nm/201.34nm/52.68nm/145.60nmである。全体の膜 厚 $(d_{total} = \Sigma d_i)$ は1041.60 nmである。それぞれの膜の屈折 率niと膜厚diとの積nidiの総和Σnidiは、1807.36 nmであ り、所定波長980nmの1/4波長(=245nm)の約7.38倍と非常に 厚い。このため、端面における放熱特性が良くなり、端面温度の上昇を抑制でき る。

[0254]

図107は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長852nmから990nmにわたって反射率は10.8%から13.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長980nmの反射率12.0%を基準として、一1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率10.5%~13.0%の範囲の連続した波長帯域幅は138nmである。この波長帯域幅を設定波長980nmで割った値は約0.141であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、反射率が広い波長帯域にわたる平坦部を有していることがわかる。

[0255]

実施の形態98.

[0256]

図108は、この9層反射膜の反射率の波長依存性を示すグラフである。グラフの横軸は波長であり、縦軸は反射率である。この9層反射膜は、設定反射率の

12%前後の平坦部分が広い波長帯域にわたって得られている。即ち、波長907nmから1053nmにわたって反射率は10.8%から13.0%の範囲内に収まっている。また、設定波長1043nmの設定反射率12.0%を基準として、-1.5%から+1.0%の範囲、即ち、反射率10.5%~13.0%の範囲の連続した波長帯域幅は146nmである。この波長帯域幅を設定波長1043nmで割った値は約0.140であり、仮想単層反射膜の場合の0.065より大きい。そこで、この9層反射膜は、広い波長帯域にわたって低反射率の平坦部を有していることがわかる。

[0257]

[0258]

ページ: 123/

【表9】

表 9

	多層反射膜の特性								
実	多層反射	設定波長 λ	極小反	$\sum n_i d_i$	R (λ) Ø	Δλ/λ			
施	膜の構成	設定反射率	射率	波長 980nm の	-1.5~1.0%				
の		R (λ)		1/4 波 長	となる波長				
形				(245nm) との	帯域Δλ				
態				対比					
85	9層膜	980nm	5.1%	1823.70nm	100nm	100/980=			
		6 %		7.44 倍		0.102			
86	9層膜	1018nm	5.1%	1857.42nm	103nm	103/1018=			
	-	6 %		7.73 倍		0.101			
87	9層膜	980nm	6.3%	1800.12nm	95nm	95/980=			
		7 %		7.35 倍		0.097			
88	9層膜	1016nm	6.3%	1866.25nm	98nm	98/1016=			
		7 %		7.62 倍		0.096			
89	9層膜	980nm	7.0%	1807.20nm	105nm	105/980=			
		8 %		7.38 倍		0.107			
90	9層膜	1023nm	7.0%	1886.46nm	109nm	109/1023=			
		8 %		7.70 倍		0.107			
91	9層膜	980nm	7.8%	1810.29nm	118nm	118/980=			
		9 %		7.39 倍		0.120			
92	9層膜	1031nm	7.8%	1904.52nm	123nm	123/1031=			
		9 %		7.77 倍		0.119			
93	9層膜	980nm	8.7%	1810.50nm	124nm	124/980=			
		10%		7.39 倍		0.127			
94	9層膜	1035nm	8.7%	1912.11nm	131nm	131/1035=			
		10%		7.80 倍		0.127			
95	9層膜	980nm	9.7%	181029nm	134nm	134/980=			
		11%		7.39 倍		0.137			
96	9層膜	1040nm	9.7%	1921.11nm	141nm	141/1040=			
		11%		7.84 倍		0.136			
97	9層膜	980nm	10.8%	1807.36nm	138nm	138/980=			
		12%		7.38 倍		0.141			
98	9層膜	1043nm	10.8%	1923.51nm	146nm	146/1043=			
	<u></u>	1 2 %		7.85 倍	,	0.140			

[0259]

以上、本発明を説明する実施の形態において、7層反射膜、6層反射膜及び9層反射膜をその一例として挙げて説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。多層反射膜はこれ以外の複数層であってもよい。3種類の材料を用いる場合を示したが、4種類以上の材料の場合も予め位相条件を与えることで同様

に取り扱える。なお、3種類の材料の一例としてA1Nを厚さ50nm設けた場合を示したが材料及び膜厚はこれに限るものではない。また、一対のアルミナ及び酸化タンタルの2層膜の寄与を示すO,A,B,C,D等のパラメータの値は上記実施の形態に示した値に限定されるものではない。さらに、半導体光素子として半導体レーザ素子の場合を例に挙げたが、これに限られず、本発明は半導体光増幅器、スーパールミネセント・ダイオード、光変調器、光スイッチ等の光デバイスにも適用することができる。また、波長として980nm近傍に限定されるものではなく、可視光領域、遠赤外領域、赤外領域においても適用できる。さらに、反射率として約2~12%の反射率の場合について説明したが、極小反射率が1~32%の範囲内であれば適用できる。なお、反射率が32%の場合とは、端面部に反射膜のコーティングをしない場合のおよその反射率である。

[0260]

【発明の効果】

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 複素数表示による振幅反射率を示す複素平面図である。
- 【図2】 端面に仮想単層反射膜を有する半導体光素子の構造を示す概略断面図である。
- 【図3】 図2の仮想単層反射膜を2層膜で置き換えた場合の本発明に係る 半導体光素子の構造を示す概略断面図である。
 - 【図4】 図2の仮想単層反射膜を4層膜で置き換えた場合の本発明に係る

半導体光素子の構造を示す概略断面図である。

- 【図5】 本発明の実施の形態1に係る半導体光素子の端面部の構造を示す 概略断面図である。
- 【図6】 本発明の実施の形態1に係る半導体光素子の端面部に形成された 多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図7】 本発明の実施の形態2に係る半導体光素子の端面部に形成された 多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図8】 端面部に形成された仮想単層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図9】 本発明の実施の形態3に係る半導体光素子の端面部に形成された 多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図10】 本発明の実施の形態4に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図11】 本発明の実施の形態 5 に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図12】 本発明の実施の形態6に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図13】 本発明の実施の形態7に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図14】 本発明の実施の形態8に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図15】 本発明の実施の形態9に係る半導体光素子の端面部の構造を示す概略断面図である。
- 【図16】 本発明の実施の形態9に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図17】 本発明の実施の形態10に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図18】 本発明の実施の形態11に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。

- 【図19】 本発明の実施の形態12に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図20】 本発明の実施の形態13に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図21】 本発明の実施の形態14に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図22】 本発明の実施の形態15に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図23】 本発明の実施の形態16に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図24】 本発明の実施の形態17に係る半導体光素子の端面部の構造を示す概略断面図である。
- 【図25】 本発明の実施の形態17に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図26】 本発明の実施の形態18に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図27】 本発明の実施の形態19に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図28】 本発明の実施の形態20に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図29】 本発明の実施の形態21に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図30】 本発明の実施の形態22に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図31】 本発明の実施の形態23に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図32】 本発明の実施の形態24に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
 - 【図33】 本発明の実施の形態25に係る半導体光素子の端面部の構造を

示す概略断面図である。

- 【図34】 本発明の実施の形態25に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図35】 本発明の実施の形態26に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図36】 本発明の実施の形態27に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図37】 本発明の実施の形態28に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図38】 本発明の実施の形態29に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図39】 本発明の実施の形態30に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図40】 本発明の実施の形態31に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図41】 本発明の実施の形態32に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図42】 本発明の実施の形態33に係る半導体光素子の端面部の構造を示す概略断面図である。
- 【図43】 本発明の実施の形態33に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図44】 本発明の実施の形態34に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図45】 本発明の実施の形態35に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図46】 本発明の実施の形態36に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図47】 本発明の実施の形態37に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。

- 【図48】 本発明の実施の形態38に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図49】 本発明の実施の形態39に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図50】 本発明の実施の形態40に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図51】 本発明の実施の形態41に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図52】 本発明の実施の形態42に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図53】 本発明の実施の形態43に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図54】 本発明の実施の形態44に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図55】 本発明の実施の形態45に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図56】 本発明の実施の形態46に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図57】 本発明の実施の形態47に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図58】 本発明の実施の形態48に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図59】 本発明の実施の形態49に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図60】 本発明の実施の形態50に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図61】 本発明の実施の形態51に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
 - 【図62】 本発明の実施の形態52に係る半導体光素子の端面部に形成さ

れた多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。

- 【図63】 本発明の実施の形態53に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図64】 本発明の実施の形態54に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図65】 本発明の実施の形態55に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図66】 本発明の実施の形態56に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図67】 本発明の実施の形態57に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図68】 本発明の実施の形態58に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図69】 本発明の実施の形態59に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図70】 本発明の実施の形態60に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図71】 本発明の実施の形態61に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図72】 本発明の実施の形態62に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図73】 本発明の実施の形態63に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図74】 本発明の実施の形態64に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図75】 本発明の実施の形態65に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図76】 本発明の実施の形態66に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。

- 【図77】 本発明の実施の形態67に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図78】 本発明の実施の形態68に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図79】 本発明の実施の形態69に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図80】 本発明の実施の形態70に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図81】 本発明の実施の形態71に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図82】 本発明の実施の形態72に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図83】 本発明の実施の形態73に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図84】 本発明の実施の形態74に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図85】 本発明の実施の形態75に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図86】 本発明の実施の形態76に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図87】 本発明の実施の形態77に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図88】 本発明の実施の形態78に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図89】 本発明の実施の形態79に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図90】 本発明の実施の形態80に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
 - 【図91】 本発明の実施の形態81に係る半導体光素子の端面部に形成さ

れた多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。

- 【図92】 本発明の実施の形態82に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図93】 本発明の実施の形態83に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図94】 本発明の実施の形態84に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図95】 本発明の実施の形態85に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図96】 本発明の実施の形態86に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図97】 本発明の実施の形態87に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図98】 本発明の実施の形態88に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図99】 本発明の実施の形態89に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図100】 本発明の実施の形態90に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図101】 本発明の実施の形態91に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図102】 本発明の実施の形態92に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図103】 本発明の実施の形態93に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図104】 本発明の実施の形態94に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図105】 本発明の実施の形態95に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。

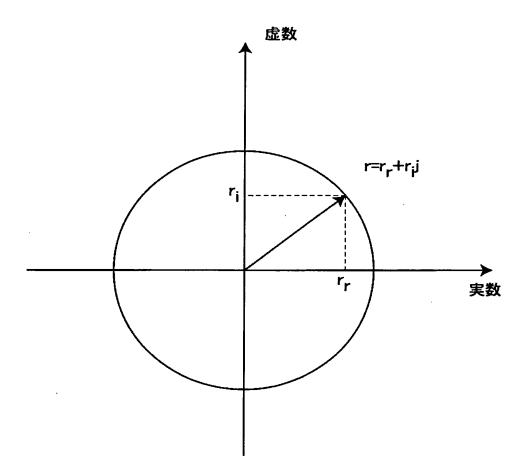
- 【図106】 本発明の実施の形態96に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図107】 本発明の実施の形態97に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。
- 【図108】 本発明の実施の形態98に係る半導体光素子の端面部に形成された多層反射膜における反射率の波長依存性を示すグラフである。

【符号の説明】

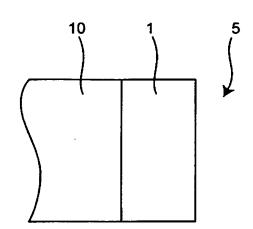
1 第1層膜、2 第2層膜、3 第3層膜、4 第4層膜、5 自由空間(空気)、10 導波層、11、21、31、41、51 第1層膜、12、22、32、42、52 第2層膜、13、23、33、43、53 第3層膜、14、24、34、44、54 第4層膜、15、25、35、45、55 第5層膜、16、26、36、46、56 第6層膜、17、27、47、57 第7層膜、20 、7層反射膜(第1層膜:アルミナ)、30 7層反射膜(第1層膜:酸化タンタル)、40 6層反射膜、50 7層反射膜(窒化アルミニウム膜を含む)、58 第8層膜、59 第9層膜、60 9層反射膜、100 導波層、101 反射膜、103 単層反射膜(膜厚 d = λ/(4 n 1))、10 4 単層反射膜(膜厚 d = 5 λ/(4 n 1))

【書類名】 図面

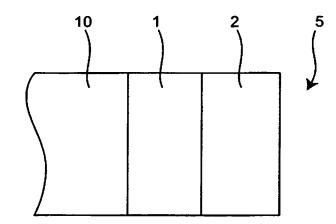
【図1】



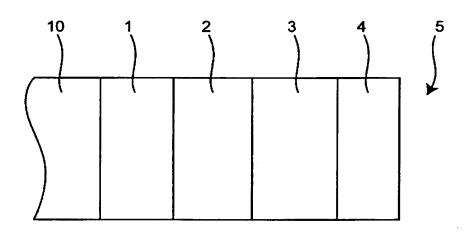
【図2】



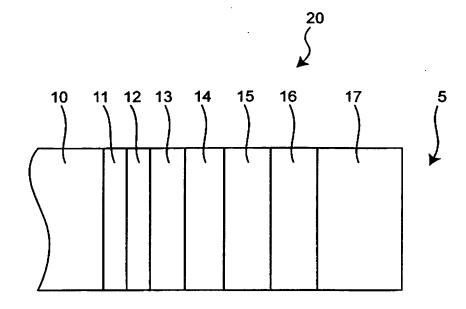
【図3】



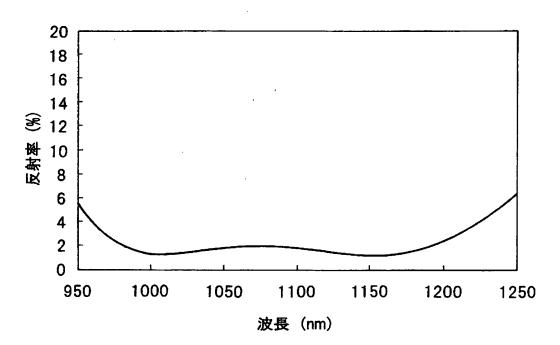
【図4】



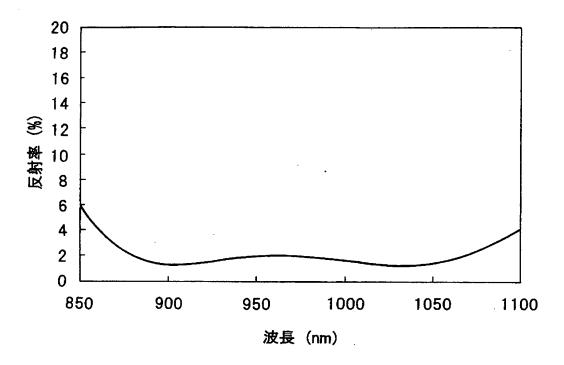
【図5】



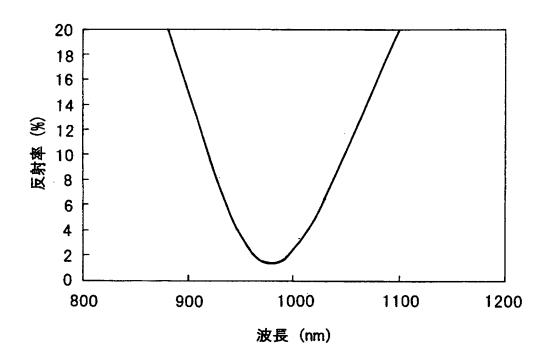
【図6】



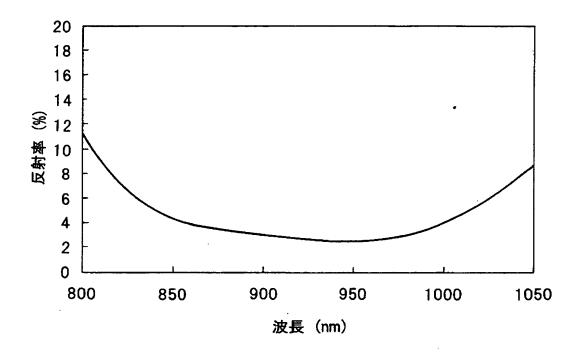
[図7]



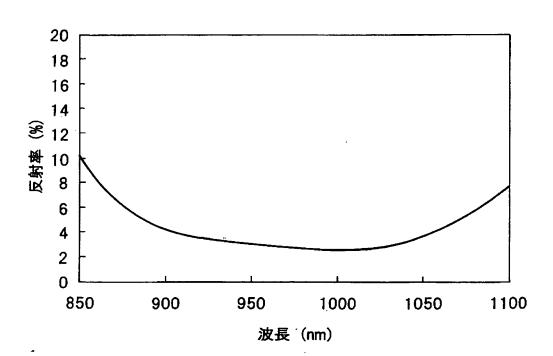
【図8】



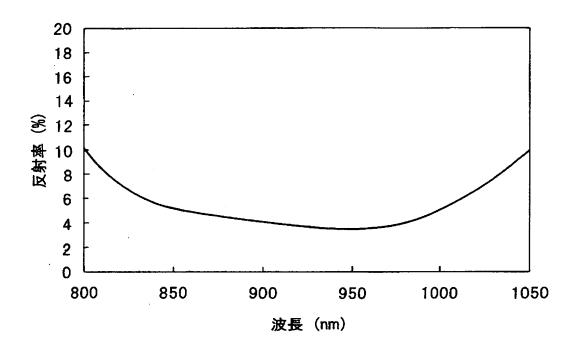
【図9】



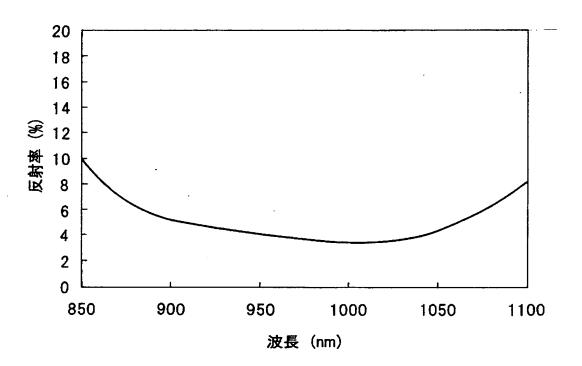
【図10】



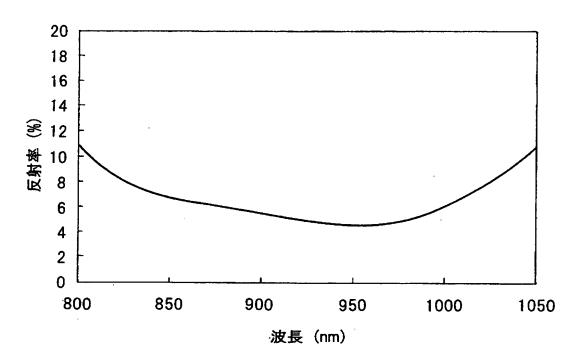
【図11】



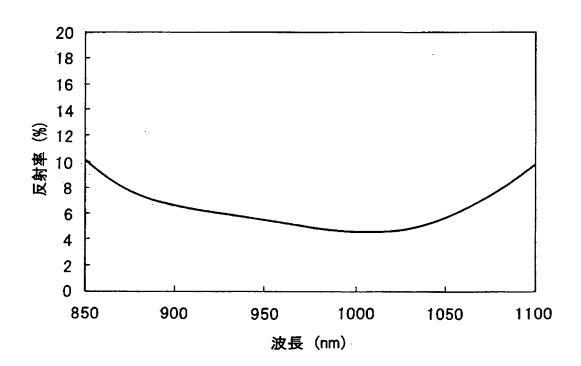
【図12】



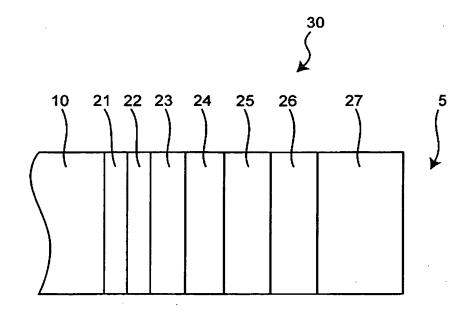




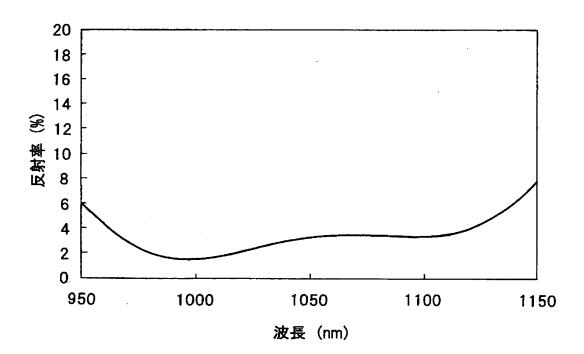
【図14】



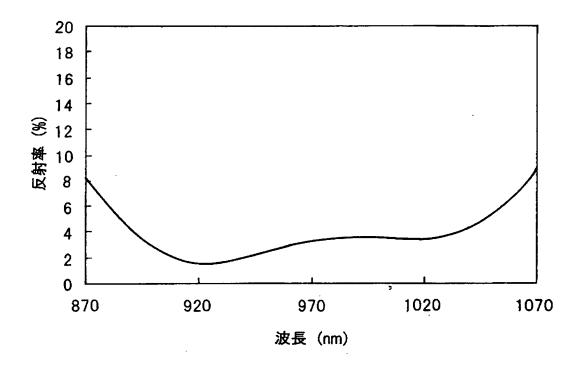
【図15】



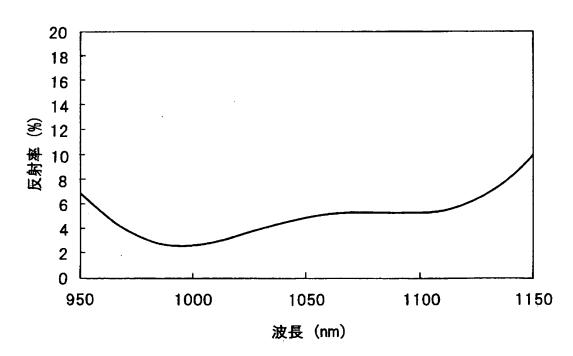
【図16】



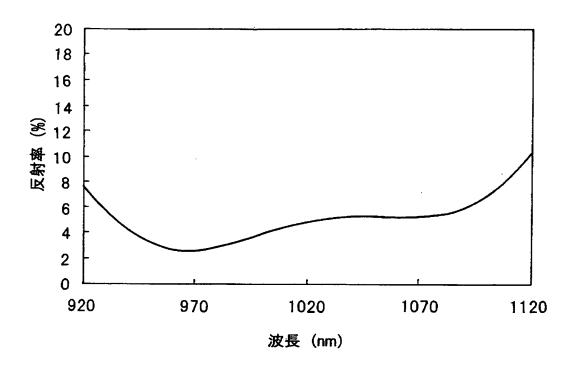
【図17】



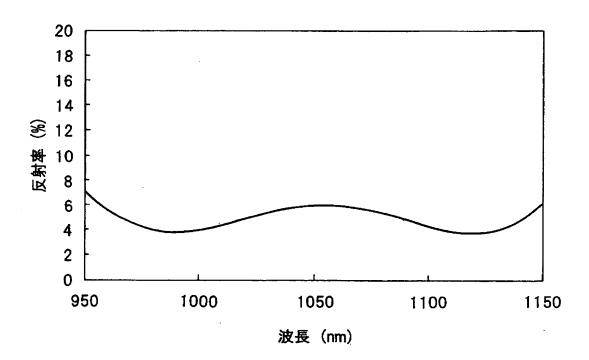
【図18】



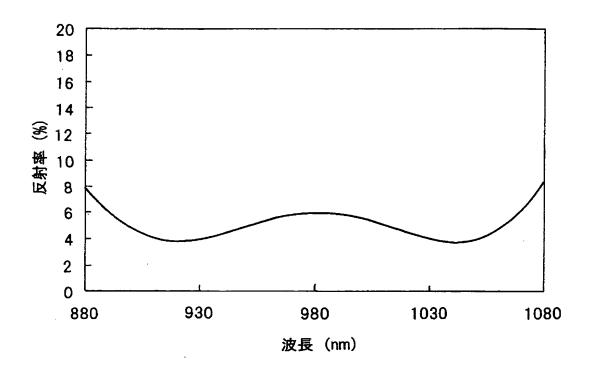
【図19】



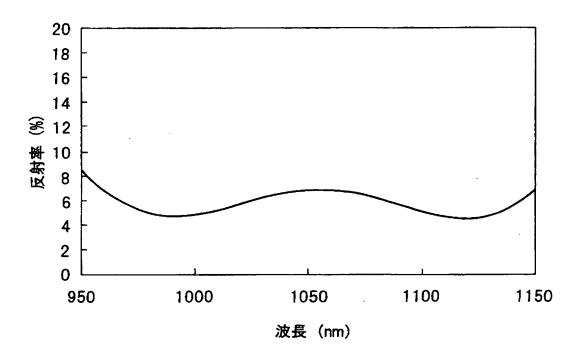
【図20】



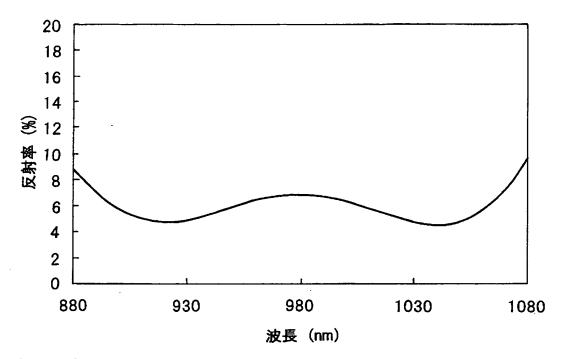
[図21]



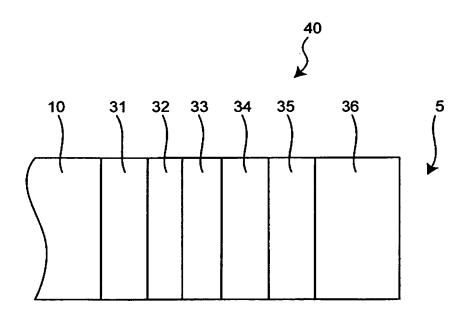
【図22】



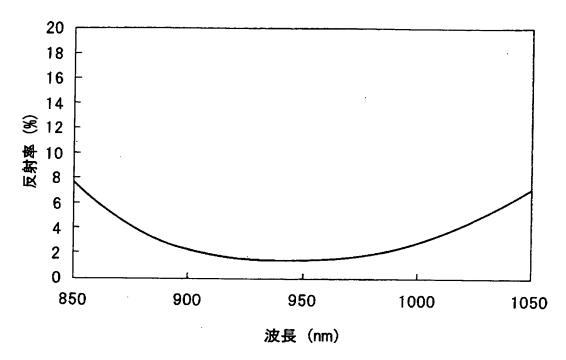
【図23】



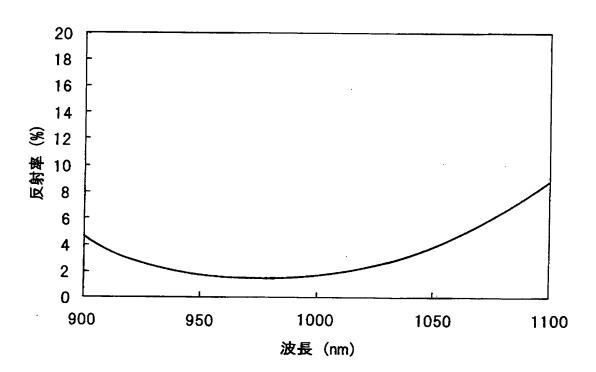
【図24】



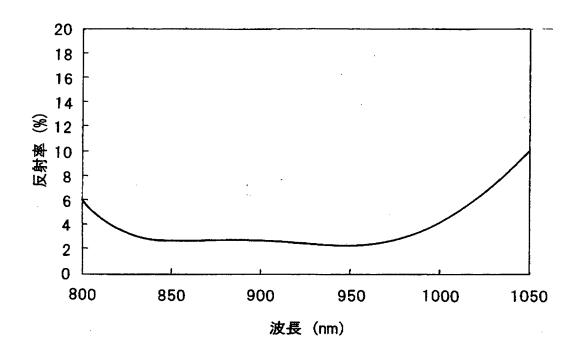
【図25】



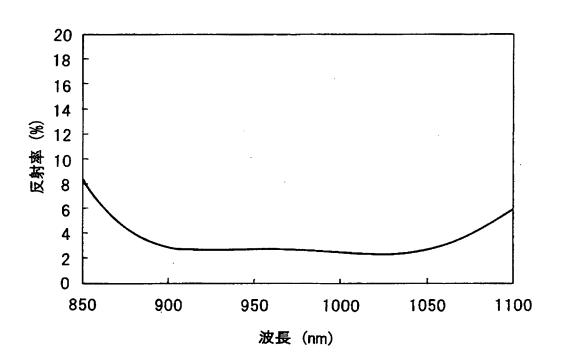
【図26】



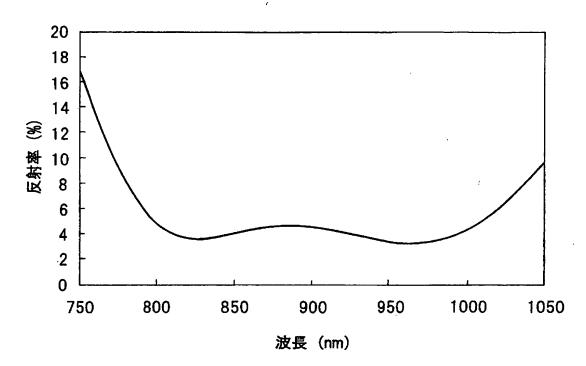
【図27】



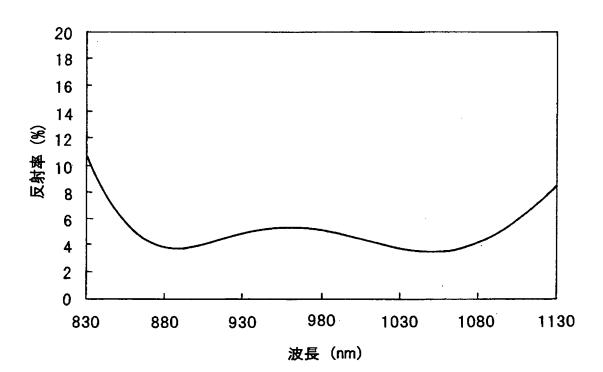
【図28】



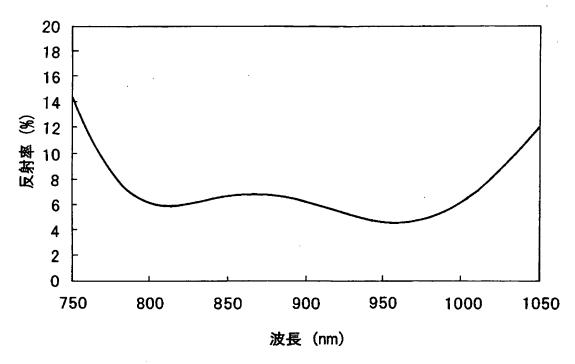
【図29】



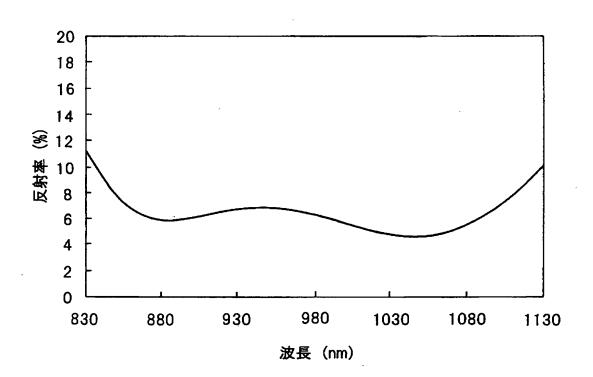
【図30】



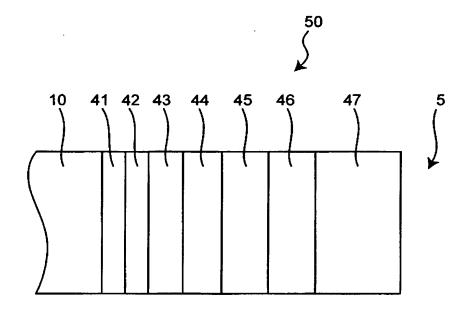
【図31】



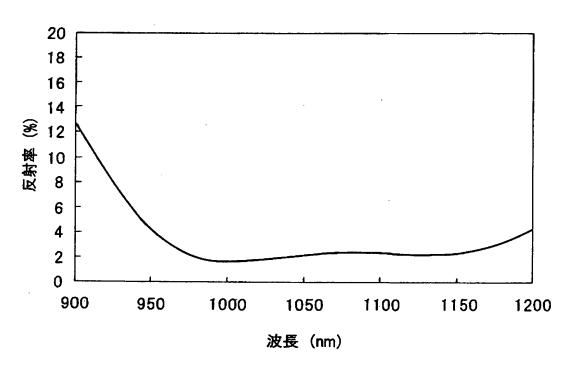
【図32】



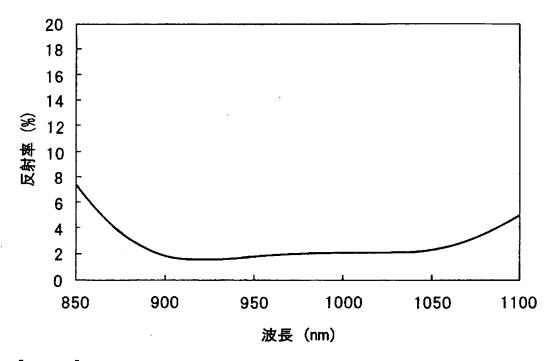
【図33】



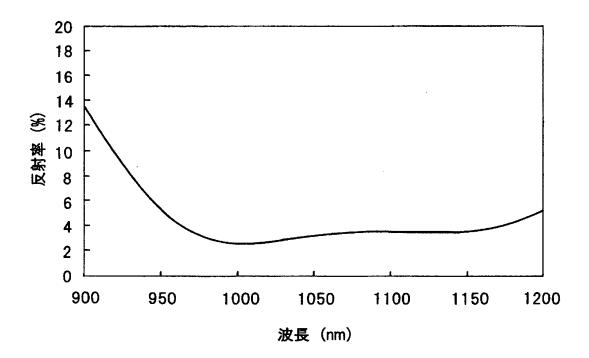
【図34】



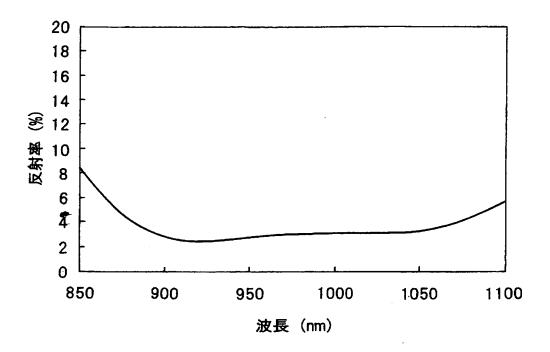
【図35】



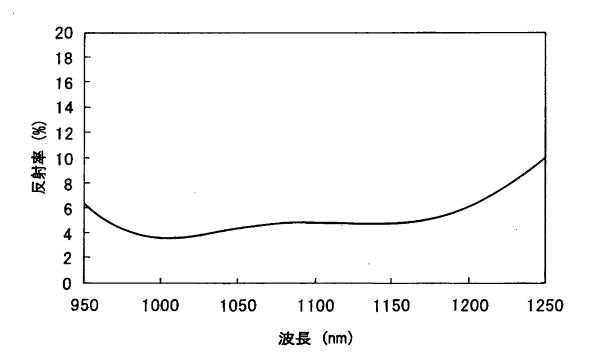
【図36】



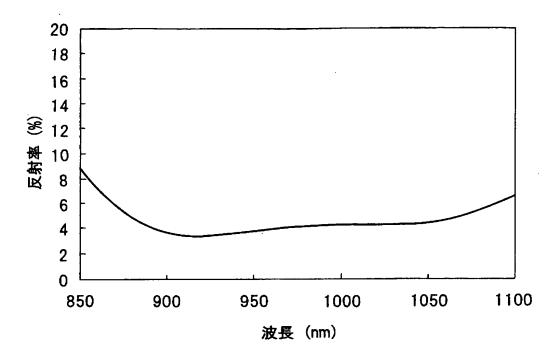
【図37】



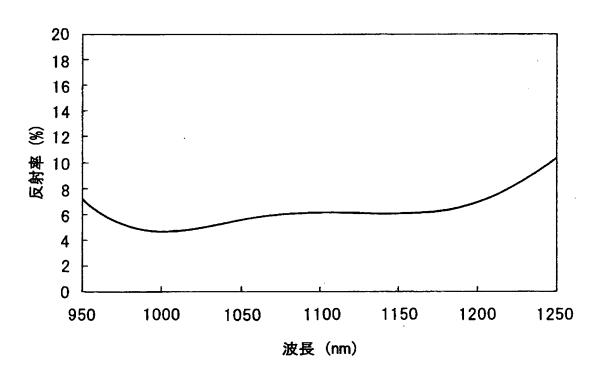
【図38】



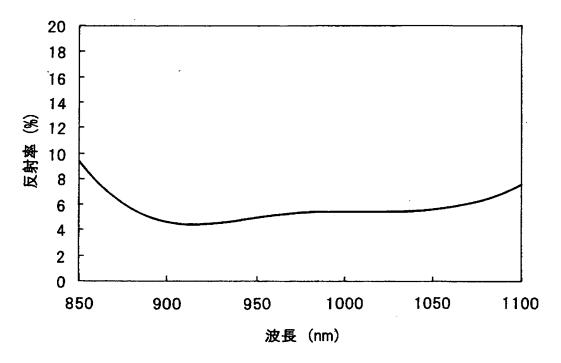
【図39】



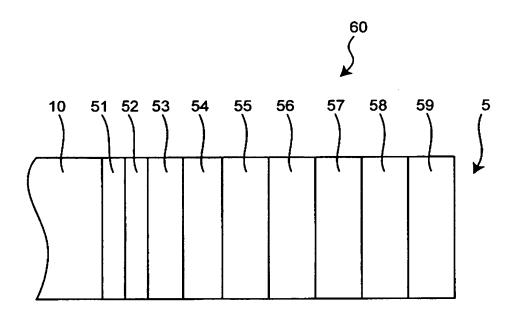
【図40】



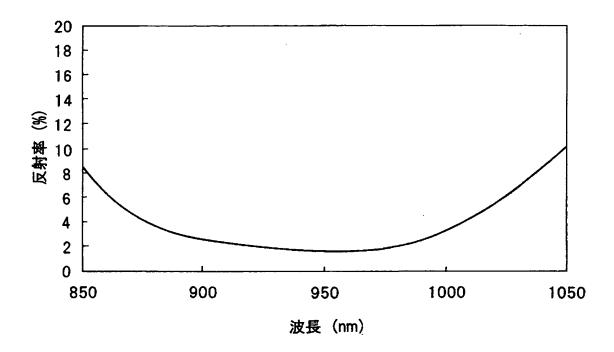
【図41】



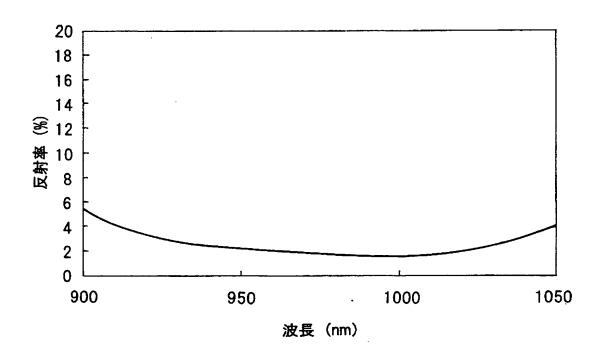
【図42】



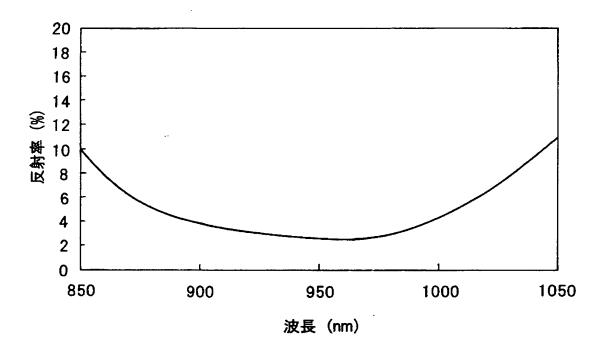
【図43】



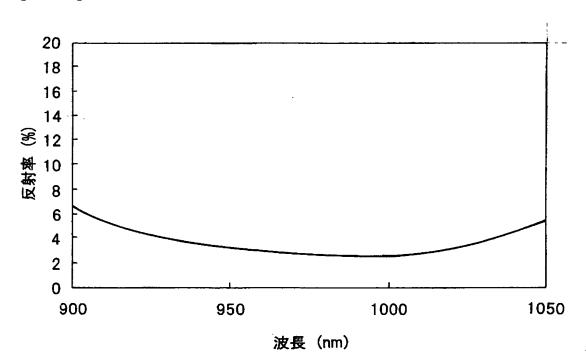
[図44]



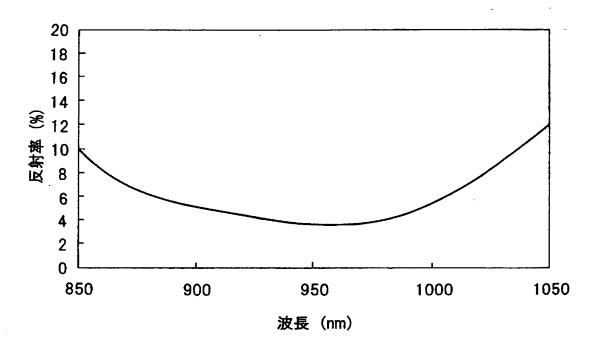
【図45】



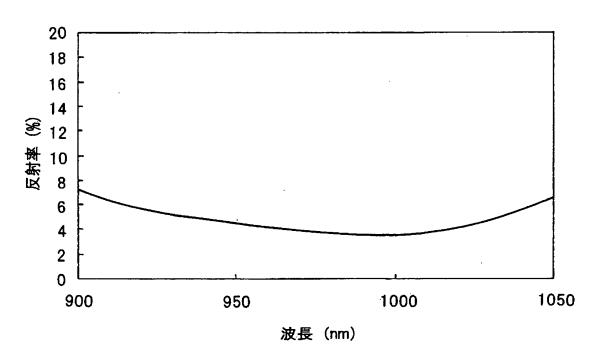
【図46】



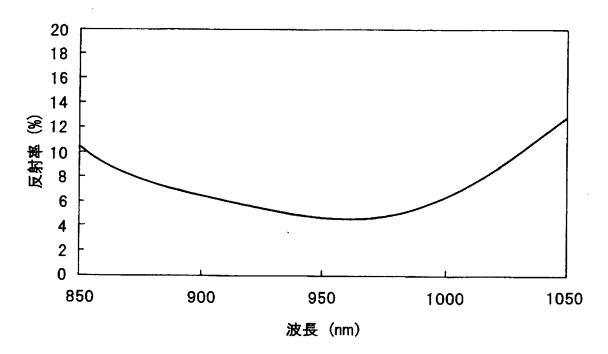
【図47】



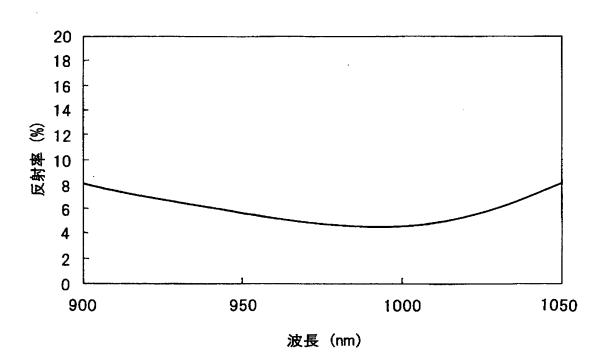
【図48】



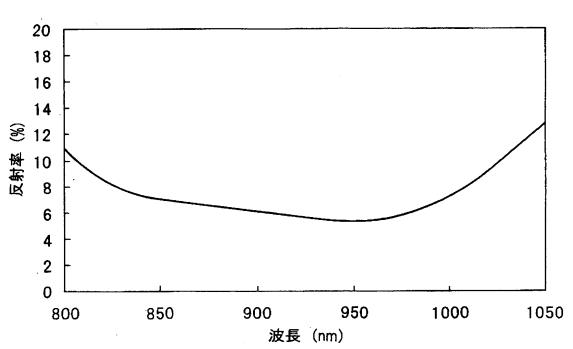




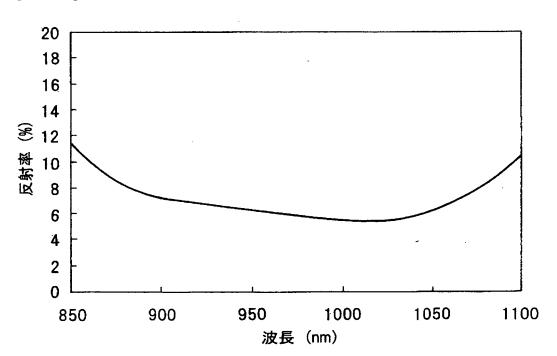
【図50】



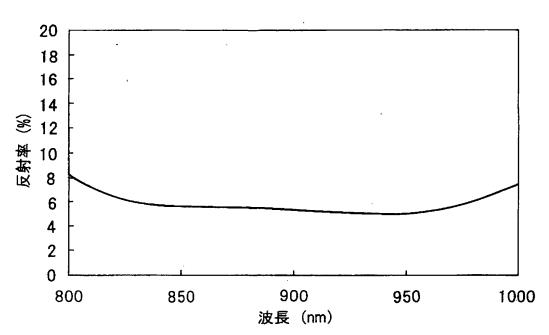




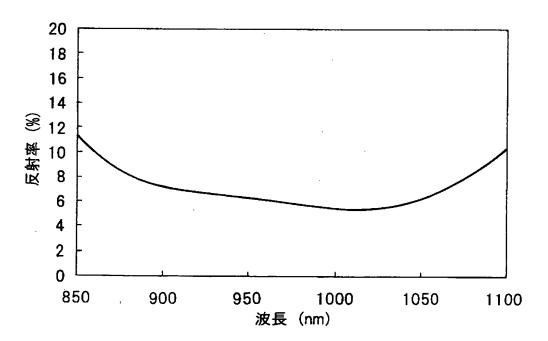
【図52】



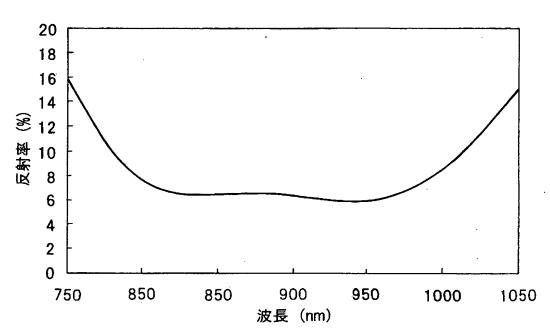




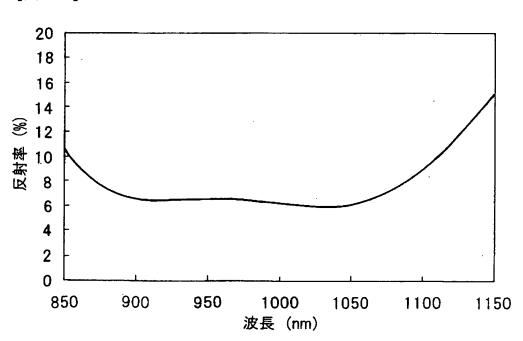
【図54】



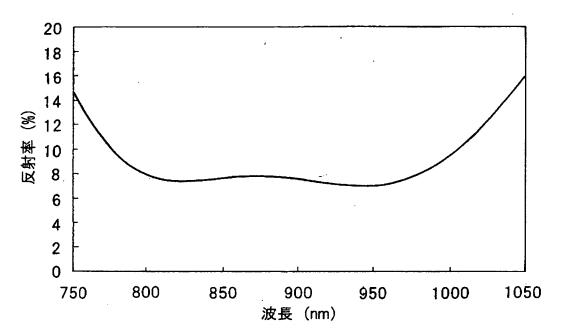




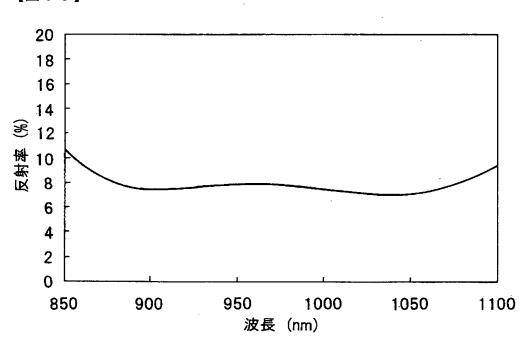
【図56】



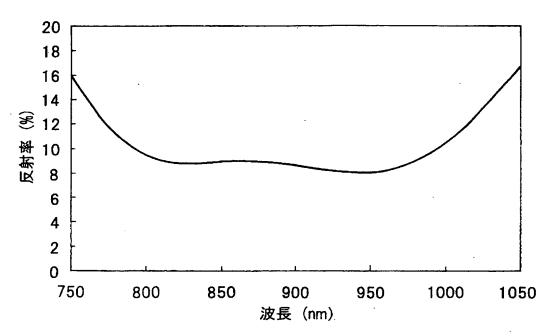




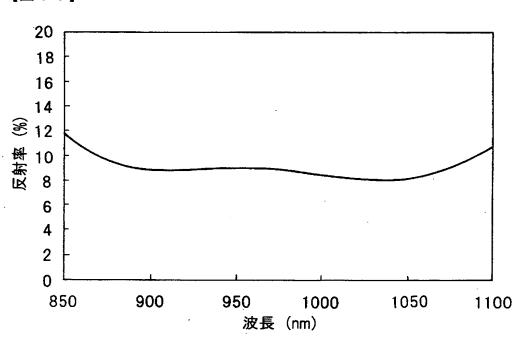
【図58】



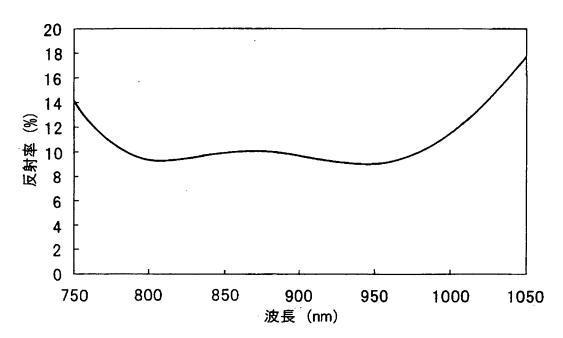
【図59】



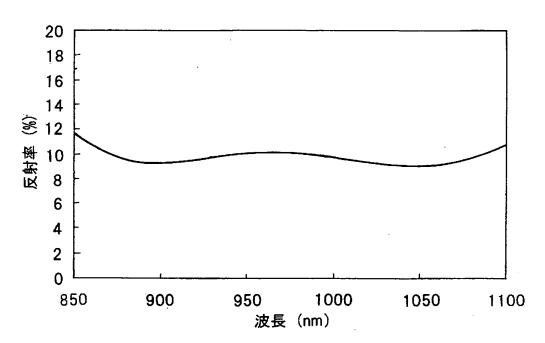
【図60】



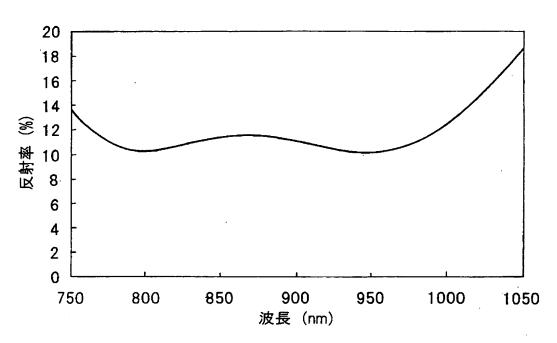




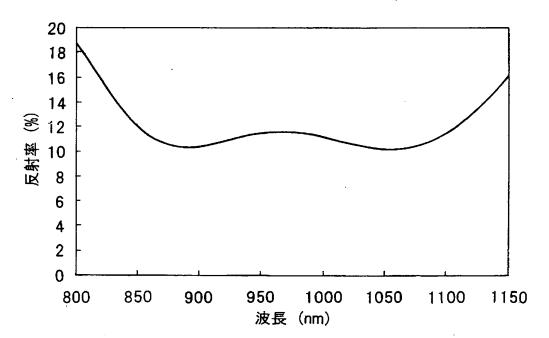
【図62】



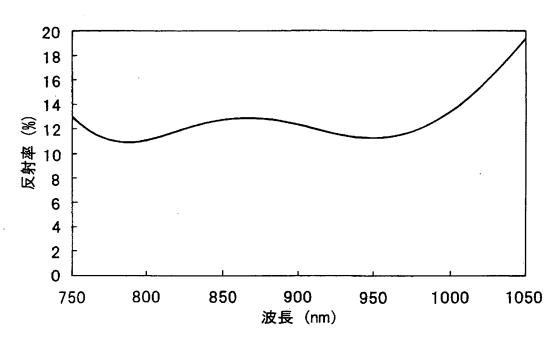




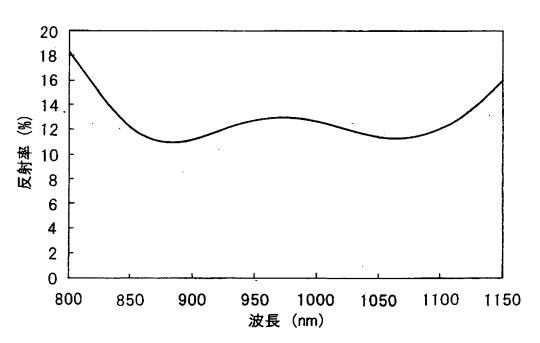
【図64】



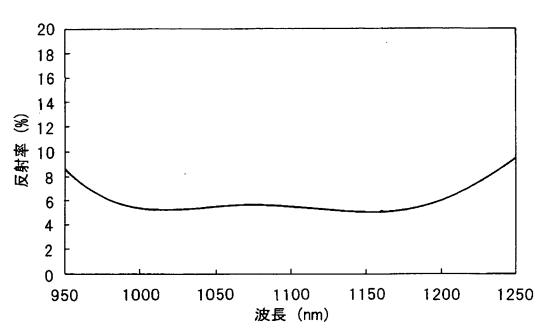




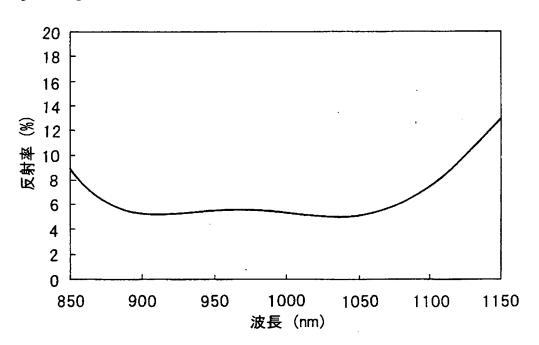
【図66】



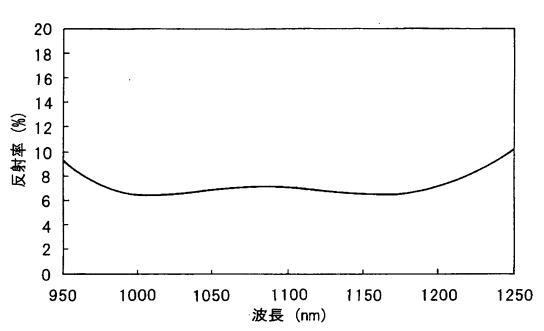




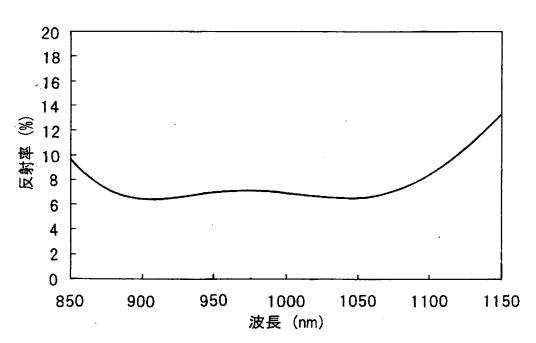
【図68】



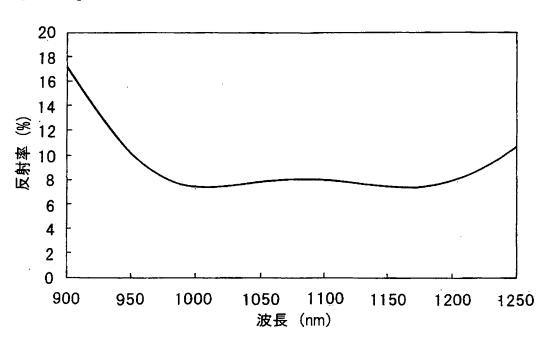




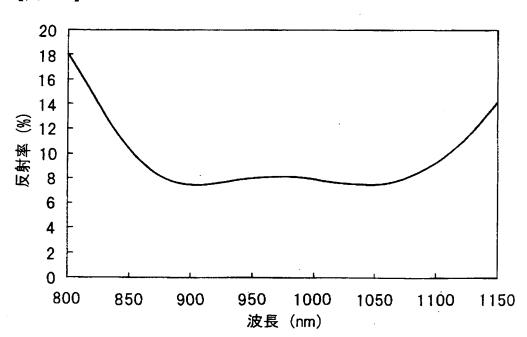
【図70】



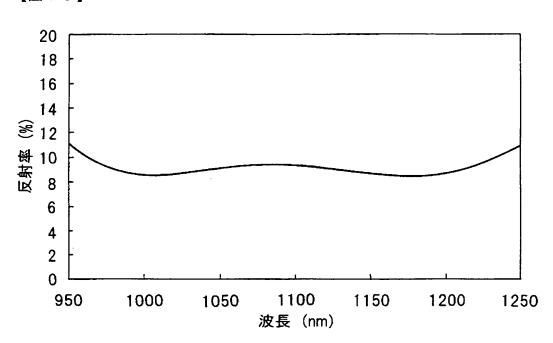




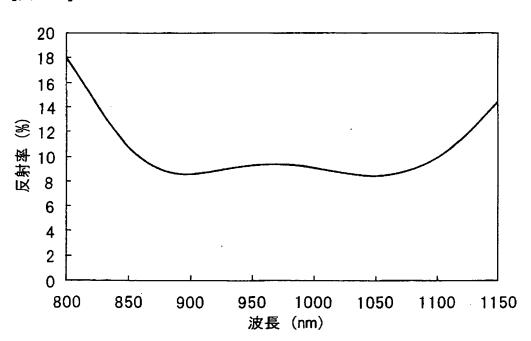
【図72】



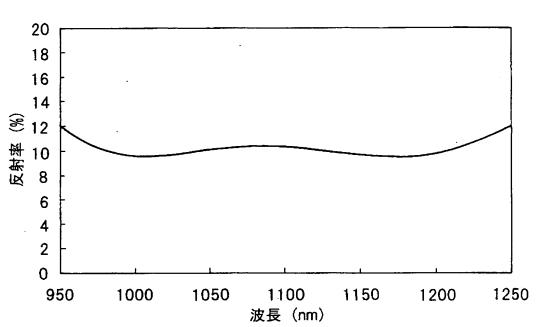




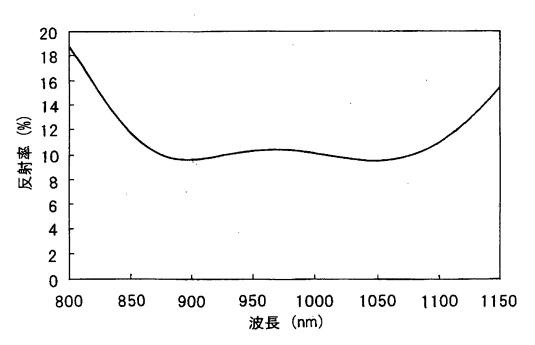
【図74】



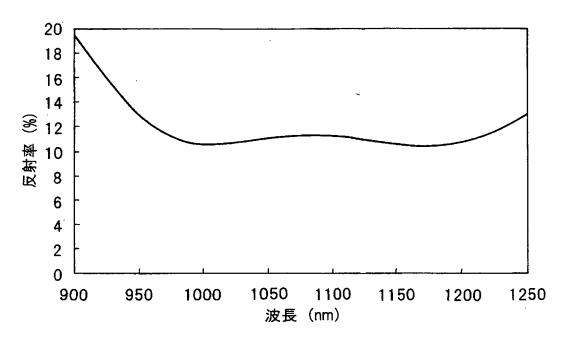




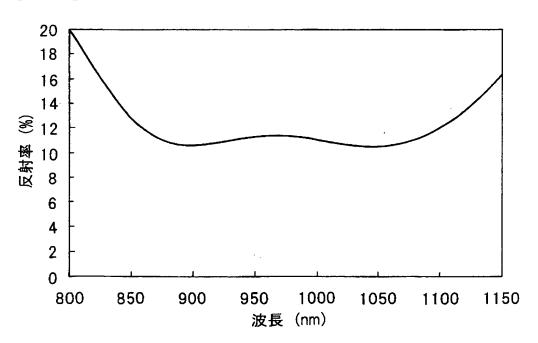
【図76】



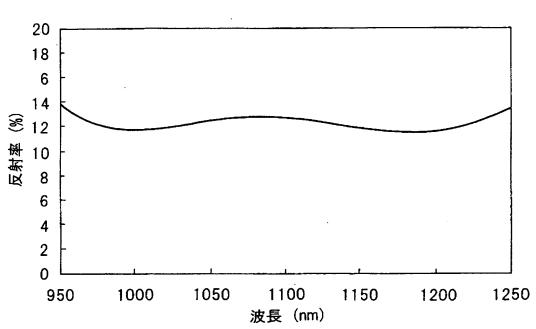




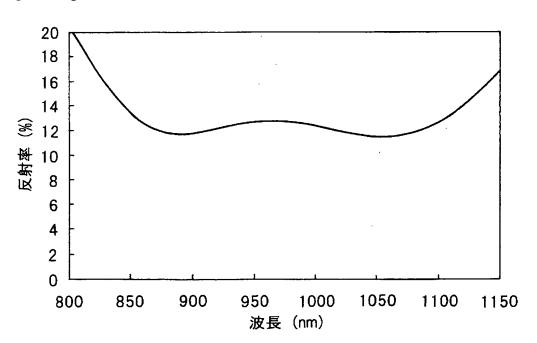
【図78】



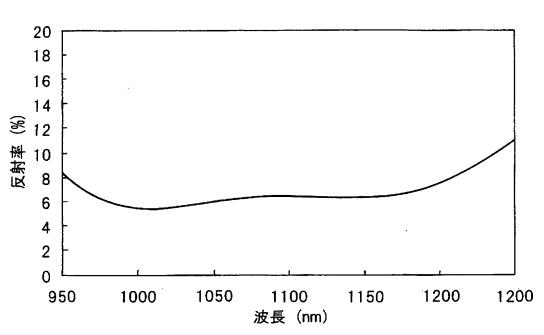




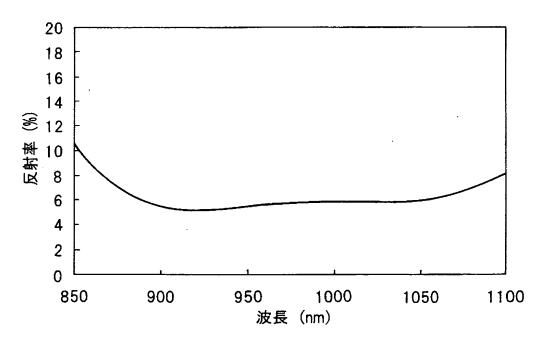
【図80】



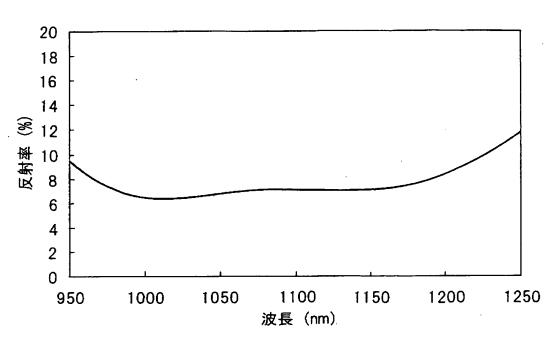




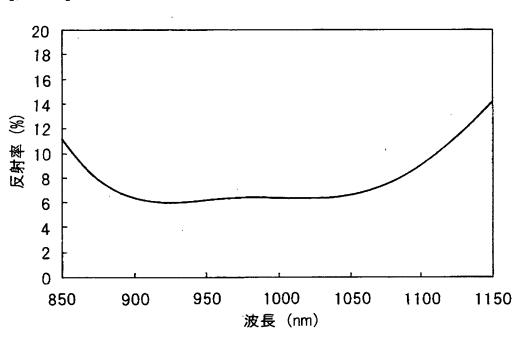
【図82】



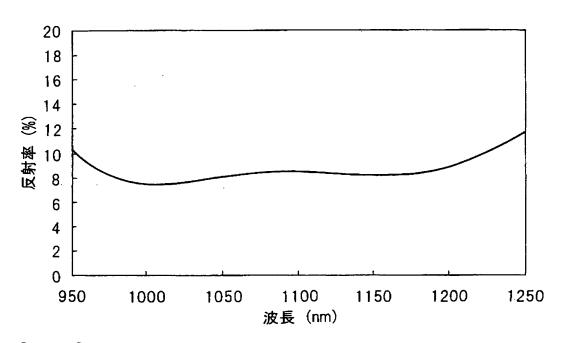




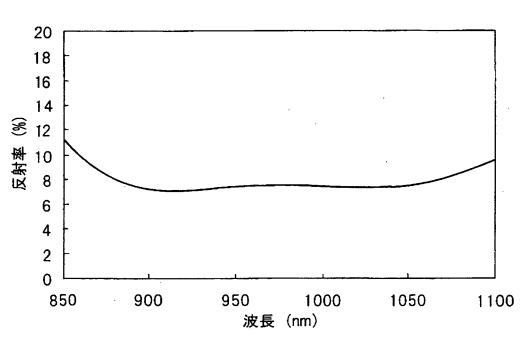
【図84】



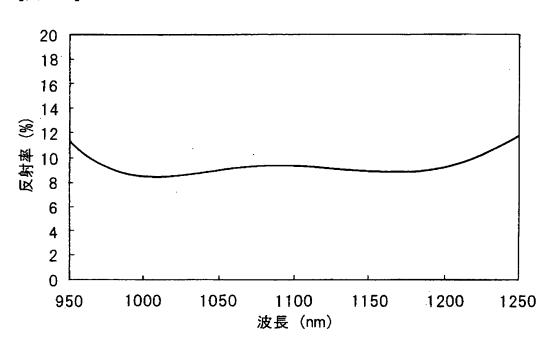




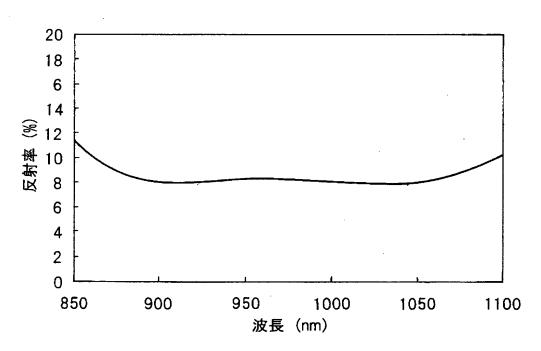
【図86】



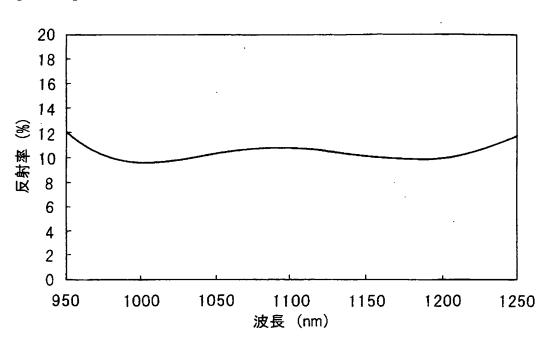




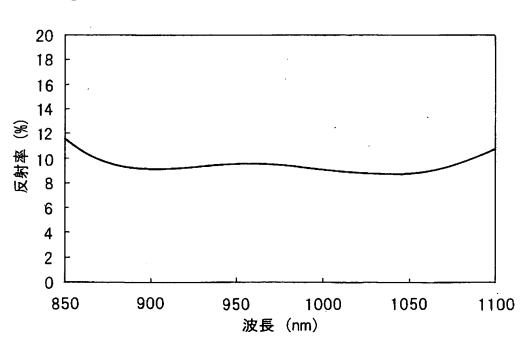
【図88】



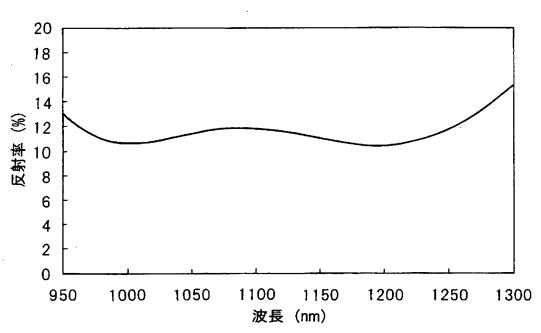




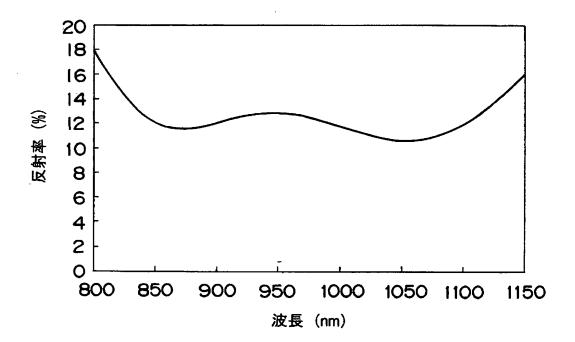
【図90】



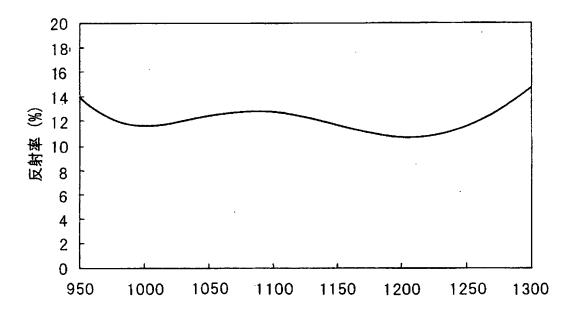




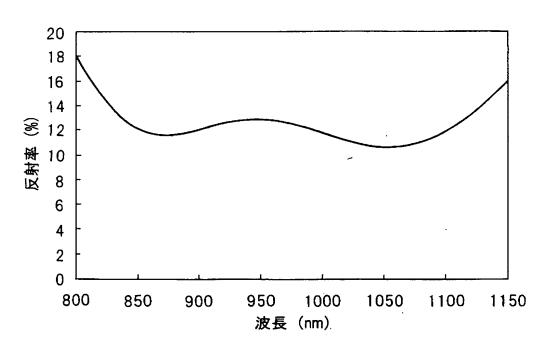
【図92】



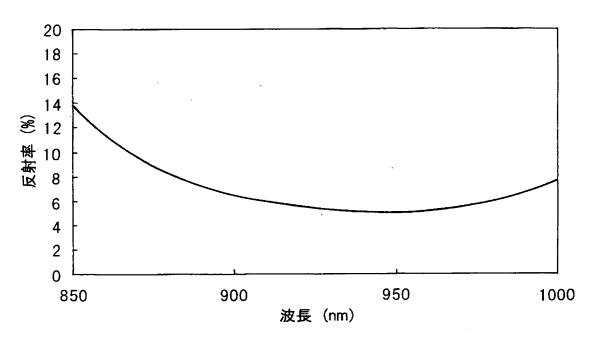
【図93】



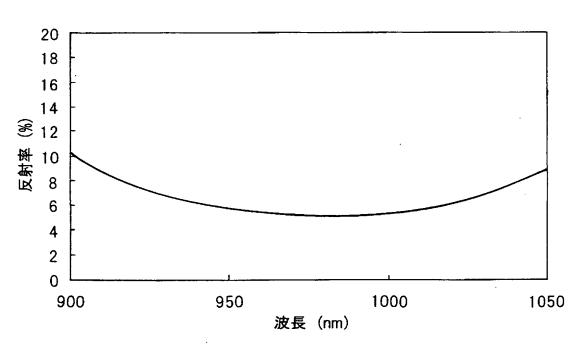
【図94】



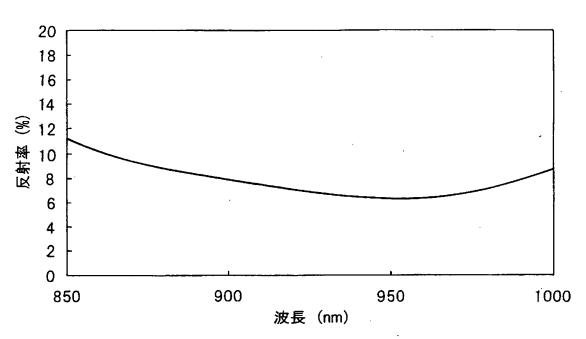




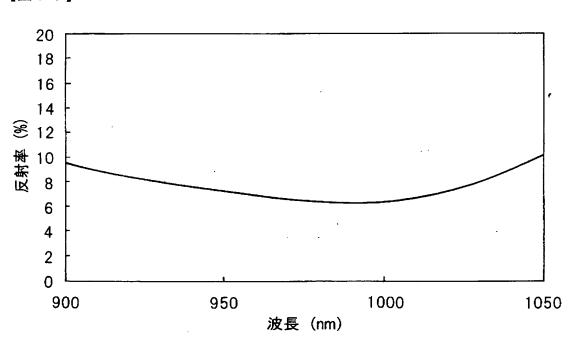
【図96】



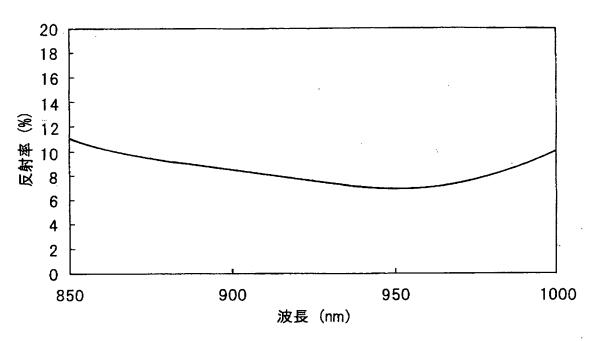




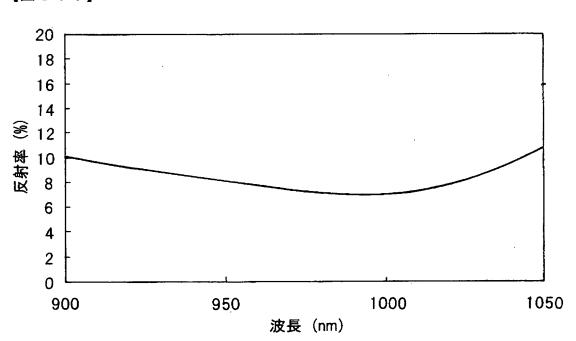
【図98】



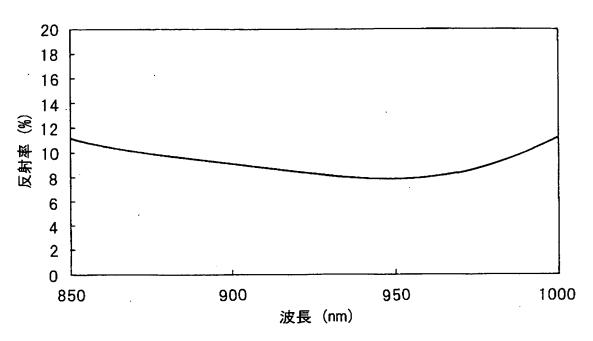




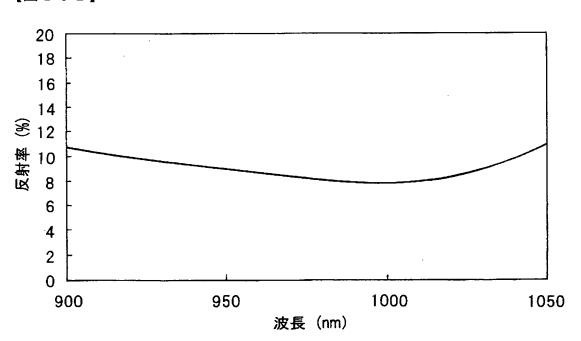
【図100】



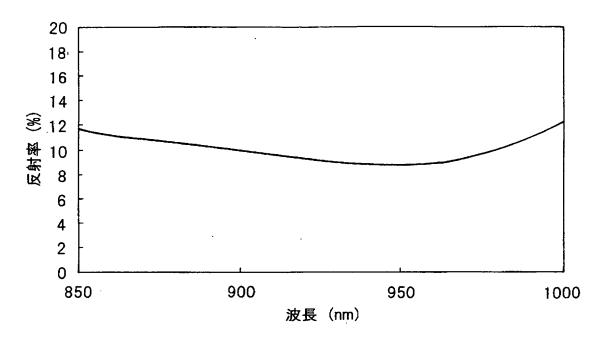




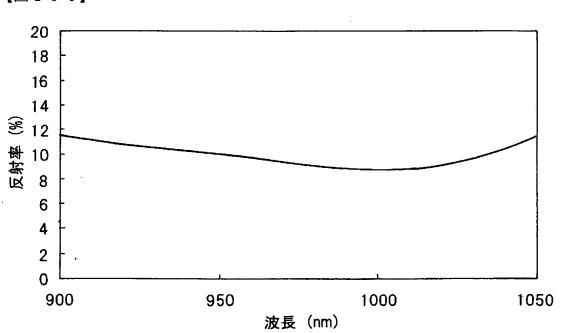
【図102】



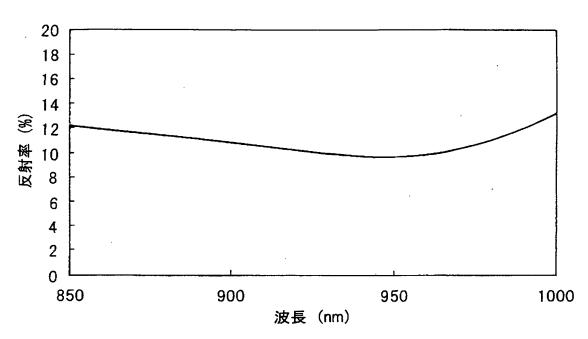




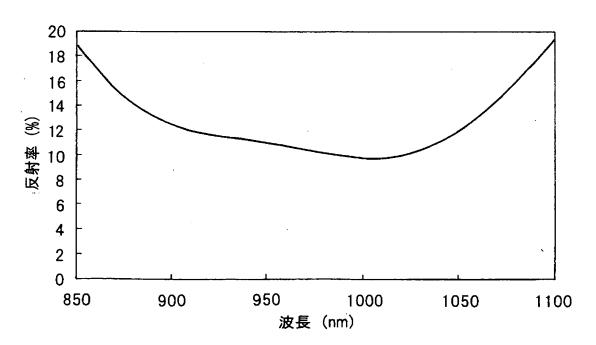
【図104】



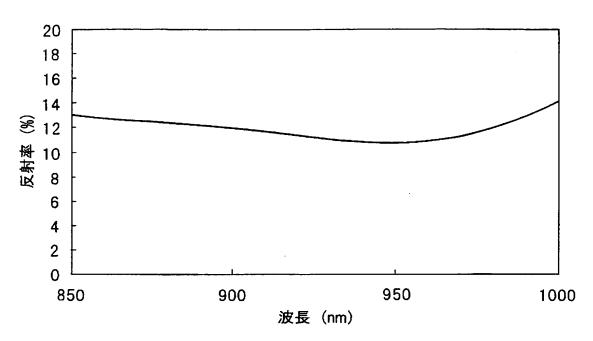




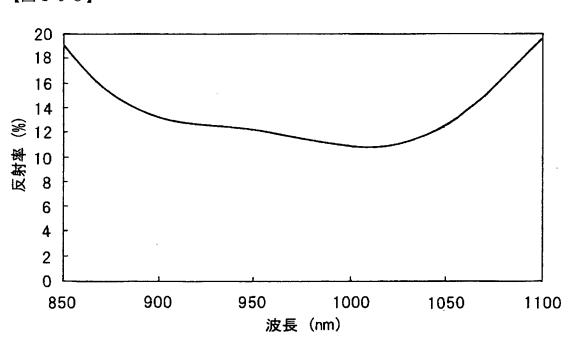
【図106】







【図108】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 広い波長帯域にわたって低反射率を有する反射膜を備えた半導体光素 子を提供する。

【解決手段】 半導体光素子は、活性層と、前記活性層を挟む2枚のクラッド層とからなる導波層10を含む積層構造体と、前記積層構造体の一対の相対する端面部のうち少なくとも一方の端面部に形成された多層反射膜20とを備え、前記多層反射膜は、それぞれの膜の屈折率 n_i と膜厚 d_i との積 n_i d_i の総和 Σ n_i d_i が、前記導波層を導波する光の波長 λ について、 Σ n_i d_i $> \lambda$ / 4 の関係を満足すると共に、前記多層反射膜は、反射率が前記波長 λ の場合の反射率 R (λ) を基準として-1%から+2.0%の範囲内となる前記波長 λ を含む連続する波長帯域幅 Δ λ を、前記波長 λ で割った値 Δ λ / λ が 0.062以上である

【選択図】

図 5

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-057238

受付番号 50300349747

書類名 特許願

担当官 第二担当上席 0091

作成日 平成15年 3月 7日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100062144

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMP

ビル 青山特許事務所

【氏名又は名称】 青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】 100086405

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMP

ビル 青山特許事務所

【氏名又は名称】 河宮 治

【選任した代理人】

【識別番号】 100113170

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMP

ビル 青山特許事務所

【氏名又は名称】 稲葉 和久

特願2003-057238

出願人履歴情報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月24日 新規登録 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 三菱電機株式会社